



工具调速器 Flash 单片机

HT45F3630

版本 : V1.10 日期 : 2020-03-06

www.holtek.com

目录

特性	6
CPU 特性	6
周边特性	6
概述	7
方框图	7
引脚图	8
引脚说明	8
直流电气特性	11
交流电气特性	12
HIRC 电气特性	13
PC 交流电气特性	13
A/D 转换器电气特性	14
LVD/LVR 电气特性	15
参考电压电气特性	15
过流保护电路电气特性	16
高压输出电气特性	17
上电复位特性	17
系统结构	18
时序和流水线结构	18
程序计数器	19
堆栈	19
算术逻辑单元 – ALU	20
Flash 程序存储器	21
结构	21
特殊向量	21
查表	21
查表范例	22
在线烧录 – ICP	22
片上调试 – OCDS	23
数据存储器	24
结构	24
通用数据存储器	24
特殊功能数据存储器	24
特殊功能寄存器	26
间接寻址寄存器 – IAR0, IAR1, IAR2	26
存储器指针 – MP0, MP1L, MP1H, MP2L, MP2H	26
累加器 – ACC	27
程序计数器低字节寄存器 – PCL	28
表格寄存器 – TBLP, TBHP, TBLH	28

状态寄存器 – STATUS	28
EEPROM 数据存储	30
EEPROM 数据存储结构	30
EEPROM 寄存器	30
从 EEPROM 中读取数据	31
写数据到 EEPROM	31
写保护	32
EEPROM 中断	32
编程注意事项	32
振荡器	34
振荡器概述	34
系统时钟配置	34
内部 RC 振荡器 – HIRC	34
内部 32kHz 振荡器 – LIRC	35
工作模式和系统时钟	35
系统时钟	35
系统工作模式	36
控制寄存器	37
工作模式切换	38
待机电流注意事项	42
唤醒	42
看门狗定时器	43
看门狗定时器时钟源	43
看门狗定时器控制寄存器	43
看门狗定时器操作	44
复位和初始化	45
复位功能	45
复位初始状态	47
输入 / 输出端口	50
上拉电阻	50
PA 口唤醒	51
输入 / 输出端口控制寄存器	51
输入 / 输出端口源电流控制	52
引脚共用功能	52
输入 / 输出引脚结构	55
编程注意事项	56
定时器模块 – TM	56
简介	56
TM 操作	56
TM 时钟源	57
TM 中断	57
TM 外部引脚	57
TM 输入 / 输出引脚选择	57
编程注意事项	58

周期型 TM – PTM	59
周期型 TM 操作	59
周期型 TM 寄存器介绍	59
周期型 TM 工作模式	63
A/D 转换器.....	72
A/D 简介	72
A/D 转换寄存器介绍	73
A/D 操作	75
A/D 转换器参考电压	76
A/D 转换器输入信号	76
A/D 转换率及时序图	77
A/D 转换步骤	77
编程注意事项	78
A/D 转换功能	78
A/D 转换应用范例	79
过流保护功能 – OCP	81
过流保护电路操作	81
过流保护控制寄存器	81
输入电压范围	84
输入失调校准	84
高压输出	86
功能描述	86
保护机制	86
控制寄存器	86
I²C 接口.....	88
I ² C 接口操作	88
I ² C 寄存器	89
I ² C 总线通信	92
I ² C 总线起始信号	93
从机地址	93
I ² C 总线读 / 写信号	93
I ² C 总线从机地址确认信号	93
I ² C 总线数据和确认信号	93
I ² C 超时控制	96
中断	97
中断寄存器	97
中断操作	101
外部中断	102
过流保护中断	102
时基中断	103
I ² C 中断	104
A/D 转换器中断	104
LVD 中断	104
EEPROM 中断	105

多功能中断	105
TM 中断	105
中断唤醒功能	105
编程注意事项	105
低电压检测 – LVD	106
LVD 寄存器	106
LVD 操作	107
应用电路	108
指令集	109
简介	109
指令周期	109
数据的传送	109
算术运算	109
逻辑和移位运算	109
分支和控制转换	110
位运算	110
查表运算	110
其它运算	110
指令集概要	111
惯例	111
扩展指令集	114
指令定义	116
扩展指令定义	128
封装信息	138
16-pin SSOP (150mil) 外形尺寸	139

特性

CPU 特性

- 工作电压：
 - ◆ V_{CC} : 12V (最大值)
 - ◆ $f_{SYS} = 8\text{MHz}$: 2.2V~5.5V
- $V_{DD}=5\text{V}$, 系统时钟为 8MHz 时, 指令周期为 0.5 μs
- 提供暂停和唤醒功能, 以降低功耗
- 振荡器类型：
 - ◆ 内部高速 RC – HIRC
 - ◆ 内部低速 32kHz RC – LIRC
- 多种工作模式: 正常、低速、空闲和休眠
- 内部集成 8MHz 振荡器, 无需外接元件
- 所有指令都可在 1~3 个指令周期内完成
- 查表指令
- 115 条功能强大的指令系统
- 6 层堆栈
- 位操作指令

周边特性

- Flash 程序存储器: 2K \times 16
- RAM 数据存储器: 64 \times 8
- True EEPROM 存储器: 32 \times 8
- 看门狗定时器功能
- 12 个双向 I/O 口
- 可编程的 I/O 端口源电流, 用于 LED 驱动应用
- 2 个与 I/O 口共用引脚的外部中断输入
- 带中断的过流保护 (OCP) 功能, 可与 HVO 连动
- 高压输出 (HVO) 功能, PWM 输出可直推 NMOS
- 多个定时器模块用于时间测量、捕捉输入、比较匹配输出、PWM 输出及单脉冲输出
- 双时基功能可提供固定时间的中断信号
- 8 通道 12-bit 的 A/D 转换器
- I²C 接口
- 低电压复位功能
- 低电压检测功能
- Flash 程序存储器烧录可达 10,000 次
- Flash 程序存储器数据可保存 10 年以上
- True EEPROM 数据存储器烧录可达 100,000 次

- True EEPROM 数据存储器数据可保存 10 年以上
- 封装类型：16-pin SSOP

概述

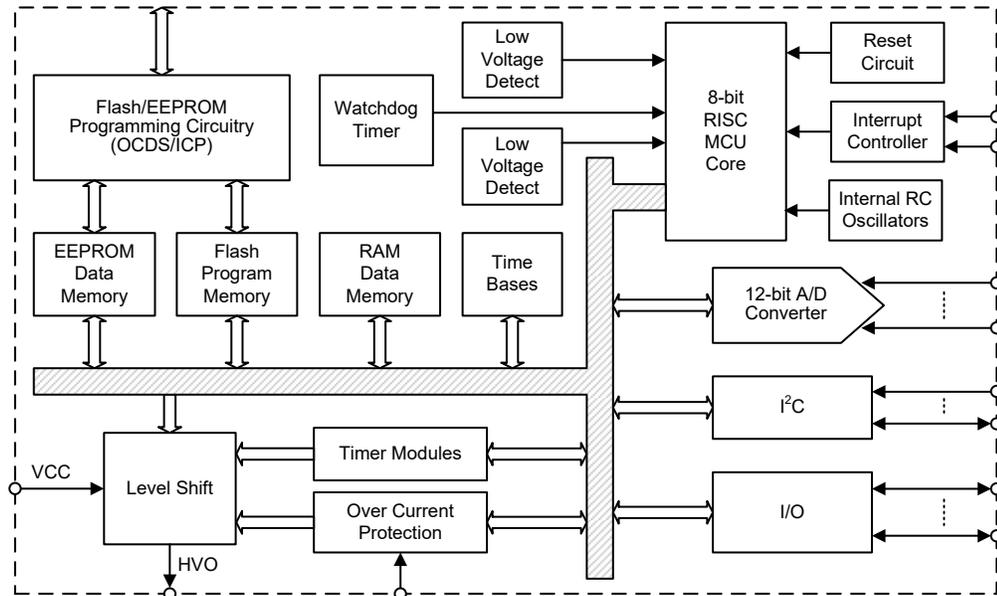
该单片机是一款 A/D 型 8 位高性能精简指令集的 Flash 单片机，具有最高 12V 高压输出驱动器，专门为工具调速器应用而设计。它具有一系列功能和特性，其 Flash 存储器可多次编程的特性给用户提供了较大的方便。存储器方面，还包含了一个 RAM 数据存储器和一个可用于存储序列号、校准数据等非易失性数据的 True EEPROM 存储器。

在模拟特性方面，该单片机包含一个多通道 12 位 A/D 转换器、过流保护功能和 HVO 高压 PWM 输出功能，可直推 NMOS 并进行电机调速。还带有多个使用灵活的定时器模块，可提供定时功能、脉冲产生功能及 PWM 产生等功能。内建 I²C 接口，为设计者提供了一个易与外部硬件通信的方法。内部看门狗定时器、低电压复位和低电压检测等内部保护特性，外加优秀的抗干扰和 ESD 保护性能，确保单片机在恶劣的电磁干扰环境下可靠地运行。

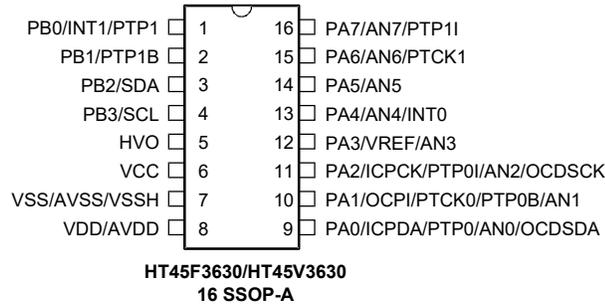
该单片机提供了内部高速和低速振荡器作为系统振荡器功能选项，无需外接元件。其不同工作模式之间动态切换的能力，为用户提供了一个优化单片机操作和减少功耗的手段。

该单片机包含一个可编程 I/O 端口源电流功能，可实现 LED 驱动功能，外加 I/O 使用灵活、时基功能等其它特性，进一步增强了单片机的功能性和灵活性。

方框图



引脚图



- 注：1. 若共用脚同时有多种输出，所需引脚共用功能通过相应的软件控制位决定。
2. HT45V3630 是 HT45F3630 的 OCDS EV 芯片，OCSDA 和 OCDSCK 引脚为片上调试功能专用引脚，仅存在于 OCDS EV 芯片。

引脚说明

除了电源引脚和一些相关的转换器控制引脚外，该单片机的所有引脚都以它的端口名称进行标注，例如 PA0、PA1 等，用于描述这些引脚的数字输入 / 输出功能。然而，这些引脚也与其它功能共用，如模数转换器、定时器模块等。每个引脚的功能如下表所述，而引脚配置的详细内容见规格书其它章节。

引脚名称	功能	OPT	I/T	O/T	说明
PA0/ICPDA/PTP0/AN0/OCSDA	PA0	PAPU PAWU PAS0	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻和唤醒功能
	ICPDA	—	ST	CMOS	ICP 数据 / 地址
	PTP0	PAS0	—	CMOS	PTM0 输出
	AN0	PAS0	AN	—	A/D 转换器输入通道 0
	OCSDA	—	ST	CMOS	OCDS 数据 / 地址，仅用于 EV 芯片
PA1/OCPI/PTCK0/PTP0B/AN1	PA1	PAPU PAWU PAS0	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻和唤醒功能
	OCPI	PAS0	AN	—	OCP 输入
	PTCK0	PAS0	ST	—	PTM0 时钟输入
	PTP0B	PAS0	—	CMOS	PTM0 反相输出
	AN1	PAS0	AN	—	A/D 转换器输入通道 1
PA2/OCDSCK/ICPCK/PTP0I/AN2	PA2	PAPU PAWU PAS0	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻和唤醒功能
	OCDSCK	—	ST	—	OCDS 时钟，仅用于 EV 芯片
	ICPCK	—	ST	—	ICP 时钟
	PTP0I	PAS0	ST	—	PTM0 捕捉输入
	AN2	PAS0	AN	—	A/D 转换器输入通道 2

引脚名称	功能	OPT	I/T	O/T	说明
PA3/VREF/AN3	PA3	PAPU PAWU PAS0	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻和唤醒功能
	VREF	PAS0	AN	—	A/D 转换器和 OCP (D/A 转换器) 参考电压输入
	AN3	PAS0	AN	—	A/D 转换器输入通道 3
PA4/AN4/INT0	PA4	PAPU PAWU PAS1	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻和唤醒功能
	AN4	PAS1	AN	—	A/D 转换器输入通道 4
	INT0	PAS1 INTEG INTC0	ST	—	外部中断 0 输入
PA5/AN5	PA5	PAPU PAWU PAS1	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻和唤醒功能
	AN5	PAS1	AN	—	A/D 转换器输入通道 5
PA6/AN6/PTCK1	PA6	PAPU PAWU PAS1	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻和唤醒功能
	AN6	PAS1	AN	—	A/D 转换器输入通道 6
	PTCK1	PAS1	ST	—	PTM1 时钟输入
PA7/AN7/PTP1I	PA7	PAPU PAWU PAS1	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻和唤醒功能
	AN7	PAS1	AN	—	A/D 转换器输入通道 7
	PTP1I	PAS1	ST	—	PTM1 捕捉输入
PB0/INT1/PTP1	PB0	PBPU PBS0	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻功能
	INT1	PBS0 INTEG INTC0	ST	—	外部中断 1 输入
	PTP1	PBS0	—	CMOS	PTM1 输出
PB1/PTP1B	PB1	PBPU PBS0	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻功能
	PTP1B	PBS0	—	CMOS	PTM1 反向输出
PB2/SDA	PB2	PBPU PBS0	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻功能
	SDA	PBS0	ST	NMOS	I ² C 数据线
PB3/SCL	PB3	PBPU PBS0	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻功能
	SCL	PBS0	ST	NMOS	I ² C 时钟线
HVO	HVO	—	—	PWR	Level Shift 输出

引脚名称	功能	OPT	I/T	O/T	说明
VCC	VCC	—	PWR	—	Level Shift 正电源输入
VDD/AVDD*	VDD	—	PWR	—	数字正电源
	AVDD	—	PWR	—	模拟正电源
VSS/AVSS/VSSH**	VSS	—	PWR	—	数字负电源
	AVSS	—	PWR	—	模拟负电源
	VSSH	—	PWR	—	高压设备负电源

注：I/T：输入类型； O/T：输出类型；
 OPT：通过寄存器选项来配置； PWR：电源；
 ST：施密特触发输入； CMOS：CMOS 输出；
 NMOS：NMOS 输出； AN：模拟信号
 *：VDD 是单片机电源电压，而 AVDD 是 ADC 电源电压。AVDD 与 VDD 在内部是同一个引脚。
 **：VSS 是单片机地引脚，而 AVSS 是 ADC 地引脚，VSSH 是高压设备地引脚。AVSS、VSSH 与 VSS 在内部是同一个引脚。

极限参数

V _{CC} 电源电压	V _{DD} ~12V
V _{DD} 电源电压	V _{SS} -0.3V~V _{SS} +6.0V
端口输入电压	V _{SS} -0.3V~V _{DD} +0.3V
储存温度	-50°C~125°C
工作温度	-40°C~85°C
I _{OL} 总电流.....	80mA
I _{OH} 总电流	-80mA
总功耗	500mW

注：这里只强调额定功率，超过极限参数所规定的范围将对芯片造成损害，无法预期芯片在上述标示范围外的工作状态，而且若长期在标示范围外的条件下工作，可能影响芯片的可靠性。

直流电气特性

Ta = 25°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	条件				
V _{DD}	工作电压 (HIRC)	—	f _{sys} = f _{HIRC} = 8MHz	2.2	—	5.5	V
V _{DD}	工作电压 (LIRC)	—	f _{sys} = f _{LIRC} = 32kHz	2.2	—	5.5	V
I _{DD}	工作电流 (HIRC)	3V	无负载, 所有外围功能 off,	—	0.8	1.2	mA
		5V	f _{sys} = f _{HIRC} = 8MHz	—	1.6	2.4	mA
	工作电流 (LIRC)	3V	无负载, 所有外围功能 off,	—	10	20	μA
		5V	f _{sys} = f _{LIRC} = 32kHz	—	30	50	μA
I _{STB}	待机电流 (SLEEP 模式)	3V	无负载, 所有外围功能 off,	—	0.2	0.8	μA
		5V	WDT off	—	0.5	1	μA
		3V	无负载, 所有外围功能 off,	—	1.5	3	μA
		5V	WDT on	—	3	5	μA
	待机电流 (IDLE0 模式)	3V	无负载, 所有外围功能 off,	—	3	5	μA
		5V	f _{sub} on	—	5	10	μA
	待机电流 (IDLE1 模式, HIRC)	3V	无负载, 所有外围功能 off,	—	360	500	μA
		5V	f _{sub} on, f _{sys} = f _{HIRC} = 8MHz	—	600	800	μA
I _{OH}	I/O 口源电流	3V	V _{OH} = 0.9V _{DD} , SLEDC[m+1, m] = 00B (m = 0, 2, 4)	-0.7	1.5	—	mA
		5V	V _{OH} = 0.9V _{DD} , SLEDC[m+1, m] = 00B (m = 0, 2, 4)	-1.5	2.9	—	mA
		3V	V _{OH} = 0.9V _{DD} , SLEDC[m+1, m] = 01B (m = 0, 2, 4)	-1.3	2.5	—	mA
		5V	V _{OH} = 0.9V _{DD} , SLEDC[m+1, m] = 01B (m = 0, 2, 4)	-2.5	5.1	—	mA
		3V	V _{OH} = 0.9V _{DD} , SLEDC[m+1, m] = 10B (m = 0, 2, 4)	-1.8	3.6	—	mA
		5V	V _{OH} = 0.9V _{DD} , SLEDC[m+1, m] = 10B (m = 0, 2, 4)	-3.6	7.3	—	mA
		3V	V _{OH} = 0.9V _{DD} , SLEDC[m+1, m] = 11B (m = 0, 2, 4)	-4.0	8	—	mA
		5V	V _{OH} = 0.9V _{DD} , SLEDC[m+1, m] = 11B (m = 0, 2, 4)	-8.0	16	—	mA
V _{IL}	I/O 口低电平输入电压	5V	—	0	—	1.5	V
		—	—	0	—	0.2V _{DD}	V

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	条件				
V _{IH}	I/O 口高电平输入电压	5V	—	3.5	—	5	V
		—	—	0.8V _{DD}	—	V _{DD}	V
I _{OL}	I/O 口灌电流	3V	V _{OL} = 0.1V _{DD}	16	32	—	mA
		5V	V _{OL} = 0.1V _{DD}	32	64	—	mA
R _{PH}	I/O 口上拉电阻	3V	—	20	60	100	kΩ
		5V	—	10	30	50	kΩ
I _{LEAK}	输入漏电流	5V	V _{IN} = V _{DD} 或 V _{IN} = V _{SS}	—	—	±1	μA
V _{OH}	I/O 口高电平输出电压	3V	I _{OH} = -5.5mA	2.7	—	—	V
		5V	I _{OH} = -11mA	4.5	—	—	V
V _{OL}	I/O 口低电平输出电压	3V	I _{OL} = 16mA	—	—	0.3	V
		5V	I _{OL} = 32mA	—	—	0.5	V

交流电气特性

Ta = 25°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	条件				
f _{SYS}	系统时钟 (LIRC)	2.2V~5.5V	f _{SYS} = f _{LIRC} = 32kHz	—	32	—	kHz
f _{LIRC}	内部低速 RC 振荡器频率 (LIRC)	3V	Ta = 25°C	-10%	32	+10%	kHz
		5V	Ta = 25°C	-10%	32	+10%	kHz
t _{RSTD}	系统复位延迟时间 (上电复位, LVR 硬件复位, LVR 软件复位, WDT 软件复位)	—	—	25	50	100	ms
	系统复位延迟时间 (WDT 溢出硬件冷复位)	—	—	8.3	16.7	33.3	ms
t _{SST}	系统启动时间 (从暂停模式下 f _{SYS} off 的情况 中唤醒)	—	f _{SYS} = f _{HIRC} ~f _{HIRC} /64	16	—	—	t _{HIRC}
		—	f _{SYS} = f _{LIRC}	2	—	—	t _{LIRC}
	系统启动时间 (低速模式 ↔ 正常模式)	—	f _{HIRC} off → on (HIRCF = 1)	16	—	—	t _{HIRC}
	系统启动时间 (从暂停模式下 f _{SYS} on 的情况 中唤醒)	—	f _{SYS} = f _{HIRC} ~f _{HIRC} /64	2	—	—	t _{HIRC}
		—	f _{SYS} = f _{LIRC}	2	—	—	t _{LIRC}
系统启动时间 (WDT 溢出硬件冷复位)	—	—	0	—	—	t _H	
t _{INT}	外部中断最小脉宽	—	—	10	—	—	μs
t _{TCK}	PTCKn 输入引脚最小脉宽	—	—	0.3	—	—	μs
t _{TP1}	PTPnI 输入引脚最小脉宽	—	—	0.3	—	—	μs
t _{EERD}	EEPROM 读周期	—	—	—	—	4	t _{SYS}
t _{EEWR}	EEPROM 写周期	—	—	—	2	4	ms

HIRC 电气特性

频率精度 Trimmed @ $V_{DD}=3V$

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V_{DD}	条件				
f_{HIRC}	内部高速 RC 振荡器时钟 (HIRC)	3V	$T_a = 25^{\circ}C$	-2%	8	+2%	MHz
		3V	$T_a = 0^{\circ}C \sim 70^{\circ}C$	-5%	8	+5%	MHz
		2.2V~5.5V	$T_a = 0^{\circ}C \sim 70^{\circ}C$	-7%	8	+7%	MHz
		2.2V~5.5V	$T_a = -40^{\circ}C \sim 85^{\circ}C$	-10%	8	+10%	MHz

频率精度 Trimmed @ $V_{DD}=5V$

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V_{DD}	条件				
f_{HIRC}	内部高速 RC 振荡器时钟 (HIRC)	5V	$T_a = 25^{\circ}C$	-2%	8	+2%	MHz
		5V	$T_a = 0^{\circ}C \sim 70^{\circ}C$	-5%	8	+5%	MHz
		2.2V~5.5V	$T_a = 0^{\circ}C \sim 70^{\circ}C$	-7%	8	+7%	MHz
		2.2V~5.5V	$T_a = -40^{\circ}C \sim 85^{\circ}C$	-10%	8	+10%	MHz

I²C 交流电气特性

$T_a=25^{\circ}C$

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V_{DD}	条件				
f_{I2C}	I ² C 标准模式 (100kHz) f_{SYS} 频率	—	无去抖时间	2	—	—	MHz
		—	2 个系统时钟去抖时间	4	—	—	MHz
		—	4 个系统时钟去抖时间	8	—	—	MHz
	I ² C 快速模式 (400kHz) f_{SYS} 频率	—	无去抖时间	5	—	—	MHz
		—	2 个系统时钟去抖时间	10	—	—	MHz
		—	4 个系统时钟去抖时间	20	—	—	MHz

A/D 转换器电气特性

Ta=25°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	条件				
V _{DD}	工作电压	—	—	2.7	—	5.5	V
V _{ADI}	输入电压	—	—	0	—	V _{REF}	V
V _{REF}	参考电压	—	—	2	—	V _{DD}	V
DNL	非线性微分误差	3V	V _{REF} = V _{DD} , t _{ADCK} = 0.5μs	—	—	±3	LSB
		5V	V _{REF} = V _{DD} , t _{ADCK} = 0.5μs				
		3V	V _{REF} = V _{DD} , t _{ADCK} = 10μs				
		5V	V _{REF} = V _{DD} , t _{ADCK} = 10μs				
INL	非线性积分误差	3V	V _{REF} = V _{DD} , t _{ADCK} = 0.5μs	—	—	±4	LSB
		5V	V _{REF} = V _{DD} , t _{ADCK} = 0.5μs				
		3V	V _{REF} = V _{DD} , t _{ADCK} = 10μs				
		5V	V _{REF} = V _{DD} , t _{ADCK} = 10μs				
I _{ADC}	A/D 转换器使能的额外电流	3V	无负载, t _{ADCK} = 0.5μs	—	1	2	mA
		5V	无负载, t _{ADCK} = 0.5μs	—	1.5	3	mA
t _{ADCK}	时钟周期	—	—	0.5	—	10	μs
t _{ON2ST}	A/D 转换器 On-to-Start 时间	—	—	4	—	—	μs
t _{ADS}	采样时间	—	—	—	4	—	t _{ADCK}
t _{ADC}	转换时间 (包括 A/D 采样和保持时间)	—	—	—	16	—	t _{ADCK}

LVD/LVR 电气特性

Ta=25°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	条件				
V _{LVR}	低电压复位电压	—	LVR 使能, 电压选择 2.1V	-5%	2.1	+5%	V
		—	LVR 使能, 电压选择 2.55V	-5%	2.55	+5%	
		—	LVR 使能, 电压选择 3.15V	-5%	3.15	+5%	
		—	LVR 使能, 电压选择 3.8V	-5%	3.8	+5%	
V _{LVD}	低电压检测电压	—	LVD 使能, 电压选择 2.0V	-5%	2.0	+5%	V
		—	LVD 使能, 电压选择 2.2V	-5%	2.2	+5%	
		—	LVD 使能, 电压选择 2.4V	-5%	2.4	+5%	
		—	LVD 使能, 电压选择 2.7V	-5%	2.7	+5%	
		—	LVD 使能, 电压选择 3.0V	-5%	3.0	+5%	
		—	LVD 使能, 电压选择 3.3V	-5%	3.3	+5%	
		—	LVD 使能, 电压选择 3.6V	-5%	3.6	+5%	
		—	LVD 使能, 电压选择 4.0V	-5%	4.0	+5%	
I _{LVRLVDBG}	工作电流	3V	LVD 使能, LVR 使能, VBGEN = 0	—	—	15	μA
		5V	LVD 使能, LVR 使能, VBGEN = 0	—	20	25	μA
		3V	LVD 使能, LVR 使能, VBGEN = 1	—	—	150	μA
		5V	LVD 使能, LVR 使能, VBGEN = 1	—	180	200	μA
t _{LVDS}	LVDO 稳定时间	—	LVR 使能时, VBGEN=0, LVD off → on	—	—	15	μs
		—	LVR 除能时, VBGEN=0, LVD off → on	—	—	150	μs
I _{LVR}	LVR 使能的额外电流	—	LVD 除能, VBGEN = 0	—	—	TBD	μA
I _{LVD}	LVD 使能的额外电流	—	LVR 除能, VBGEN = 0	—	—	TBD	μA

参考电压电气特性

Ta=25°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	条件				
V _{BG}	Bandgap 参考电压	—	—	-5%	1.04	+5%	V
t _{BGS}	V _{BG} 开启稳定时间	—	无负载	—	—	150	μs
I _{BG}	Bandgap 电路使能的额外电流	—	LVR 除能, LVD 除能	—	—	TBD	μA

注: 此 V_{BG} 参考电压可以用作 A/D 转换器内部输入信号。

过流保护电路电气特性

Ta=25°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	条件				
I _{OCP}	工作电流	3V	OCPEN[1:0] = 01B, DAC V _{REF} = 2.5V	—	—	625	μA
		5V	OCPEN[1:0] = 01B, DAC V _{REF} = 2.5V	—	730	1250	μA
V _{OS_CMP}	比较器输入失调电压	3V	未校准 (OCPCOF[4:0] = 10000B)	-15	—	15	mV
		5V	未校准 (OCPCOF[4:0] = 10000B)	-15	—	15	mV
		3V	校准后	-4	—	4	mV
		5V	校准后	-4	—	4	mV
V _{HYS}	迟滞	3V	—	20	40	60	mV
		5V	—	20	40	60	mV
V _{CM_CMP}	比较器共模电压范围	3V	—	V _{SS}	—	V _{DD} -1.4	V
		5V	—	V _{SS}	—	V _{DD} -1.4	V
V _{OS_OPA}	运算放大器输入失调电压	3V	未校准 (OCPOOF[5:0] = 100000B)	-15	—	15	mV
		5V	未校准 (OCPOOF[5:0] = 100000B)	-15	—	15	mV
		3V	校准后	-4	—	4	mV
		5V	校准后	-4	—	4	mV
V _{CM_OPA}	运算放大器共模电压范围	3V	—	V _{SS}	—	V _{DD} -1.4	V
		5V	—	V _{SS}	—	V _{DD} -1.4	V
V _{OR}	运算放大器最大输出电压范围	3V	—	V _{SS} +0.1	—	V _{DD} -0.1	V
		5V	—	V _{SS} +0.1	—	V _{DD} -0.1	V
Ga	PGA 增益精度	3V	所有增益	-5	—	5	%
		5V	所有增益	-5	—	5	%
DNL	非线性微分误差	3V	DAC V _{REF} = V _{DD}	—	—	±1	LSB
		5V	DAC V _{REF} = V _{DD}	—	—	±1	LSB
INL	非线性积分误差	3V	DAC V _{REF} = V _{DD}	—	—	±1.5	LSB
		5V	DAC V _{REF} = V _{DD}	—	—	±1.5	LSB

高压输出电气特性

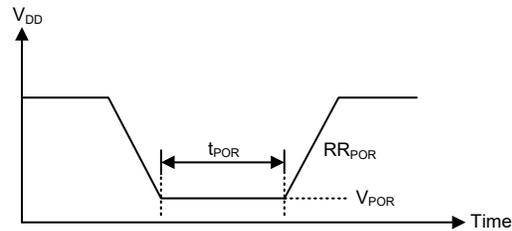
Ta=25°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	条件				
V _{IN}	输入电压	—	—	V _{DD}	—	12	V
I _{OH}	HVO 引脚源电流	—	V _{OH} = 0.9 × V _{IN} , V _{IN} = 10V	-100	—	—	mA
I _{OL}	HVO 引脚灌电流	—	V _{OL} = 0.1 × V _{IN} , V _{IN} = 10V	100	—	—	mA
t _r	HVO 输出上升时间	—	V _{IN} = 10V	—	—	0.5	μs
t _f	HVO 输出下降时间	—	V _{IN} = 10V	—	—	0.5	μs

上电复位特性

Ta=25°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	条件				
V _{POR}	上电复位电压	—	—	—	—	100	mV
RR _{POR}	上电复位电压速率	—	—	0.035	—	—	V/ms
t _{POR}	V _{DD} 保持为 V _{POR} 的最小时间	—	—	1	—	—	ms

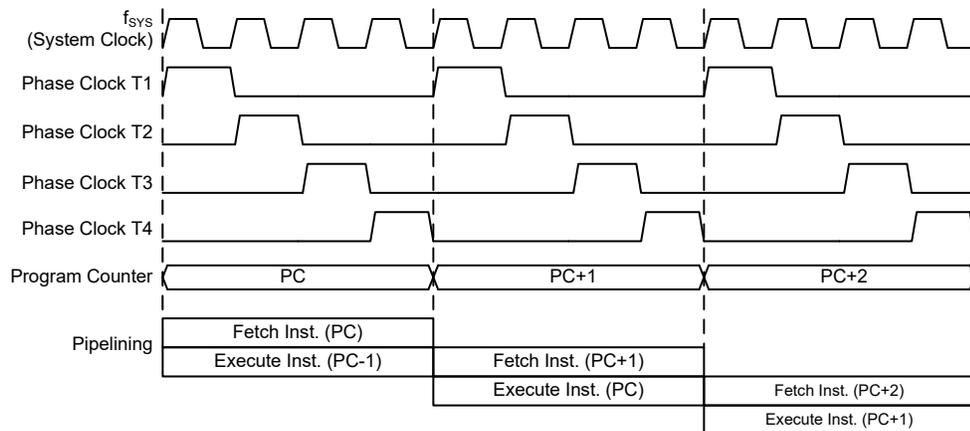


系统结构

内部系统结构是 Holtek 单片机具有良好性能的主要因素。由于采用 RISC 结构，此单片机具有高运算速度和高性能的特点。通过流水线的方式，指令的取得和执行同时进行，此举使得除了跳转和调用指令需要一个以上指令周期外，大部分的标准指令或扩展指令分别能在一个指令周期或两个指令周期内完成。8 位 ALU 参与指令集中所有的运算，它可完成算术运算、逻辑运算、移位、递增、递减和分支等功能，而内部的数据路径则是以通过累加器和 ALU 的方式加以简化。有些寄存器在数据存储器中被实现，且可以直接或间接寻址。简单的寄存器寻址方式和结构特性，确保了在提供具有较大可靠度和灵活性的 I/O 和 A/D 控制系统时，仅需要少数的外部器件。使得该单片机适用于低成本和批量生产的控制应用。

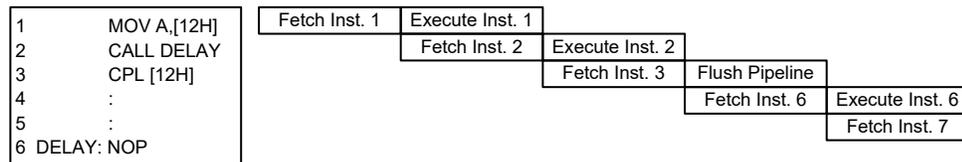
时序和流水线结构

主系统时钟由 HIRC 或 LIRC 振荡器提供，它被细分为 T1~T4 四个内部产生的非重叠时序。在 T1 时间，程序计数器自动加一并抓取一条新的指令。剩下的时间 T2~T4 完成译码和执行功能，因此，一个 T1~T4 时钟周期构成一个指令周期。虽然指令的抓取和执行发生在连续的指令周期，但单片机流水线结构会保证指令在一个指令周期内被有效执行。除非程序计数器的内容被改变，如子程序的调用或跳转，在这种情况下指令将需要多一个指令周期的时间去执行。



系统时序和流水线

如果指令牵涉到分支，例如跳转或调用等指令，则需要两个指令周期才能完成指令执行。需要一个额外周期的原因是程序先用一个周期取出实际要跳转或调用的地址，再用另一个周期去实际执行分支动作，因此用户需要特别考虑额外周期的问题，尤其是在执行时间要求较严格的时候。



指令捕捉

程序计数器

在程序执行期间，程序计数器用来指向下一个要执行的指令地址。除了“JMP”和“CALL”指令需要跳转到一个非连续的程序存储器地址之外，它会在每条指令执行完成以后自动加一。只有较低的 8 位，即所谓的程序计数器低字节寄存器 PCL，可以被用户直接读写。

当执行的指令要求跳转到不连续的地址时，如跳转指令、子程序调用、中断或复位等，单片机通过加载所需要的地址到程序寄存器来控制程序，对于条件跳转指令，一旦条件符合，在当前指令执行时取得的下一条指令将会被舍弃，而由一个空指令周期来取代。

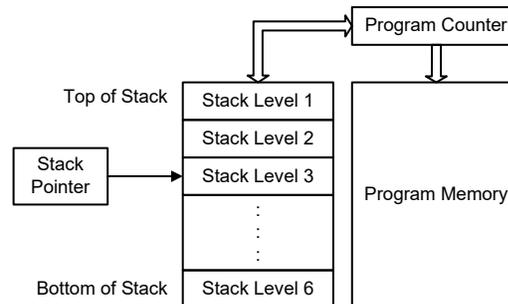
程序计数器	
程序计数器高字节	PCL 寄存器
PC10~PC8	PCL7~PCL0

程序计数器

程序计数器的低字节，即程序计数器的低字节寄存器 PCL，可以通过程序控制，且它是可以读取和写入的寄存器。通过直接写入数据到这个寄存器，一个程序短跳转可直接执行，然而只有低字节的操作是有效的，跳转被限制在存储器的当前页中，即 256 个存储器地址范围内，当这样一个程序跳转要执行时，会插入一个空指令周期。程序计数器的低字节可由程序直接进行读取，PCL 的使用可能引起程序跳转，因此需要额外的指令周期。

堆栈

堆栈是一个特殊的存储空间，用来存储程序计数器中的内容。此单片机有 6 层堆栈，堆栈既不是数据部分也不是程序空间部分，而且它既不是可读取也不是可写入的。当前层由堆栈指针 (SP) 加以指示，同样也是不可读写的。在子程序调用或中断响应服务时，程序计数器的内容被压入到堆栈中。当子程序或中断响应结束时，返回指令 (RET 或 RETI) 使程序计数器从堆栈中重新得到它以前的值。当一个芯片复位后，堆栈指针将指向堆栈顶部。



如果堆栈已满，且有非屏蔽的中断发生，中断请求标志会被置位，但中断响应将被禁止。当堆栈指针减少 (执行 RET 或 RETI)，中断将被响应。这个特性提供程序设计者简单的方法来预防堆栈溢出。然而即使堆栈已满，CALL 指令仍然可以被执行，而造成堆栈溢出。使用时应避免堆栈溢出的情况发生，因为这可能导致不可预期的程序分支指令执行错误。

若堆栈溢出，则首个存入堆栈的程序计数器数据将会丢失。

算术逻辑单元 – ALU

算术逻辑单元是单片机中很重要的部分，执行指令集中的算术和逻辑运算。ALU 连接到单片机的数据总线，在接收相关的指令码后执行需要的算术与逻辑操作，并将结果存储在指定的寄存器，当 ALU 计算或操作时，可能导致进位、借位或其它状态的改变，而相关的状态寄存器会因此更新内容以显示这些改变，ALU 所提供的功能如下：

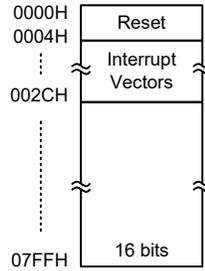
- 算术运算：
ADD, ADDM, ADC, ADCM, SUB, SUBM, SBC, SBCM, DAA
LADD, LADDM, LADC, LADCM, LSUB, LSUBM, LSBC, LSBCM,
LDAA
- 逻辑运算：
AND, OR, XOR, ANDM, ORM, XORM, CPL, CPLA
LAND, LOR, LXOR, LANDM, LORM, LXORM, LCPL, LCPLA
- 移位运算：
RRA, RR, RRCA, RRC, RLA, RL, RLCA, RLC
LRR, LRRCA, LRR, LRLA, LRL, LRLCA, LRLC
- 递增和递减：
INCA, INC, DECA, DEC
LINCA, LINC, LDECA, LDEC
- 分支判断：
JMP, SZ, SZA, SNZ, SIZ, SDZ, SIZA, SDZA, CALL, RET, RETI
LSZ, LSZA, LSNZ, LSIZ, LSDZ, LSIZA, LSDZA

Flash 程序存储器

程序存储器用来存放用户代码即储存程序。程序存储器为 FLASH 类型意味着可以多次重复编程，方便用户使用同一芯片进行程序的修改。使用适当的单片机编程工具，此单片机提供用户灵活便利的调试方法和项目开发规划及更新。

结构

程序存储器的容量为 2K×16 位，程序存储器用程序计数器来寻址，其中也包含数据、表格和中断入口。数据表格可以设定在程序存储器的任何地址，由表格指针来寻址。



程序存储器结构

特殊向量

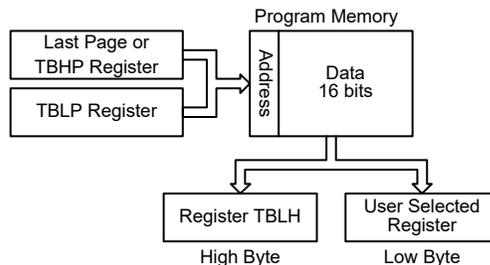
程序存储器内部某些地址保留用做诸如复位和中断入口等特殊用途。地址 0000H 是芯片复位后的程序起始地址。在芯片复位之后，程序将跳到这个地址并开始执行。

查表

程序存储器中的任何地址都可以定义成一个表格，以便储存固定的数据。使用表格时，表格指针必须先行设定，其方式是将表格的地址放在表格指针寄存器 TBLP 和 TBHP 中。这些寄存器定义表格总的地址。

在设定完表格指针后，当数据存储器 [m] 位于 Sector 0，表格数据可以使用如“TABRD [m]”或“TABRDL [m]”等指令分别从程序存储器查表读取。如果存储器 [m] 位于其它 Sector，表格数据可以使用如“LTABRD [m]”或“LTABRDL [m]”等指令分别从程序存储器查表读取。当这些指令执行时，程序存储器中表格数据低字节，将被传送到使用者所指定的数据存储器 [m]，程序存储器中表格数据的高字节，则被传送到 TBLH 特殊寄存器。

下图是查表中寻址 / 数据流程：



查表范例

以下范例说明表格指针和表格数据如何被定义和执行。这个例子使用的表格数据用 ORG 伪指令储存在存储器中。ORG 指令的值“0700H”指向的地址是 2K 程序存储器中最后一页的起始地址。表格指针低字节寄存器的初始值设为 06H，这可保证从数据表格读取的第一笔数据位于程序存储器地址 0706H，即最后一页起始地址后的第六个地址。值得注意的是，假如“TABRD [m]”或“LTABRD [m]”指令被使用，则表格指针指向 TBLP 和 TBHP 指定页的起始地址。在这个例子中，表格数据的高字节等于零，而当“TABRD [m]”或“LTABRD [m]”指令被执行时，此值将会自动的被传送到 TBLH 寄存器。

TBLH 寄存器为可读 / 写寄存器，且能重新储存，若主程序和中断服务程序都使用表格读取指令，应该注意它的保护。使用表格读取指令，中断服务程序可能会改变 TBLH 的值，若随后在主程序中再次使用这个值，则会发生错误，因此建议避免同时使用表格读取指令。然而在某些情况下，如果同时使用表格读取指令是不可避免的，则在执行任何主程序的表格读取指令前，中断应该先除能，另外要注意的是所有与表格相关的指令，都需要两个指令周期去完成操作。

表格读取程序范例

```

tempreg1 db ?      ; temporary register #1
tempreg2 db ?      ; temporary register #2
:
:
mov a,06h          ; initialise low table pointer - note that this address
                  ; is referenced
mov tblp,a         ; to the last page or the page that tbhp pointed
mov a,07h          ; initialise high table pointer
mov tbhp,a
:
:
tabrd tempreg1     ; transfers value in table referenced by table pointer
                  ; data at program memory address "0706H" transferred to
                  ; tempreg1 and TBLH
dec tblp           ; reduce value of table pointer by one
tabrd tempreg2     ; transfers value in table referenced by table pointer
                  ; data at program memory address "0705H" transferred to
                  ; tempreg2 and TBLH in this example the data "1AH" is
                  ; transferred to tempreg1 and data "0FH" to register
                  ; tempreg2
:
:
org 0700h          ; sets initial address of program memory
dc 00Ah, 00Bh, 00Ch, 00Dh, 00Eh, 00Fh, 01Ah, 01Bh
:
:

```

在线烧录 – ICP

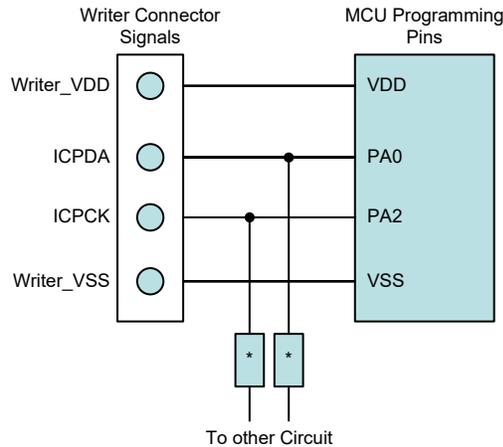
Flash 型程序存储器提供用户便利地对同一芯片进行程序的更新和修改。另外，Holtek 单片机提供 4 线接口的在线烧录方式。用户可将进行过烧录或未经过烧录的单片机芯片连同电路板一起制成，最后阶段进行程序的更新和程序的烧录，在无需去除或重新插入芯片的情况下方便地保持程序为最新版。

Holtek Flash MCU 与烧录器引脚对应表如下：

Holtek 烧录器引脚名称	MCU 在线烧录引脚名称	功能
ICPDA	PA0	串行数据 / 地址烧录
ICPCK	PA2	串行时钟烧录
VDD	VDD	电源
VSS	VSS	地

芯片内部程序存储器可以通过 4 线的接口在线进行烧录。其中 PA0 用于数据串行下载或上传，PA2 用于串行时钟，两条用于提供电源。芯片在线烧写的详细使用说明超出此文档的描述范围，将由专门的参考文献提供。

在烧录过程中，烧录器会控制 ICPDA 和 ICPCK 脚进行数据和时钟烧录，用户必须确保这两个引脚没有连接至其它输出脚。



注：* 可能为电阻或电容。若为电阻则其值必须大于 1kΩ，若为电容则其必须小于 1nF。

片上调试 – OCDS

EV 芯片 HT45V3630 用于 HT45F3630 单片机仿真。此 EV 芯片提供片上调试功能（OCDS—On-Chip Debug Support）用于开发过程中的单片机调试。除了片上调试功能方面，EV 芯片和实际单片机在功能上几乎是兼容的。用户可将 OCSDA 和 OCDSCK 引脚连接至 Holtek HT-IDE 开发工具，从而实现 EV 芯片对实际单片机的仿真。OCSDA 引脚为 OCDS 数据 / 地址输入 / 输出脚，OCDSCK 引脚为 OCDS 时钟输入脚。当用户用 EV 芯片进行调试时，实际单片机 OCSDA 和 OCDSCK 引脚上的其它共用功能无效。由于这两个 OCDS 引脚与 ICP 引脚共用，因此在线烧录时仍用作 Flash 存储器烧录引脚。关于 OCDS 功能的详细描述，请参考“Holtek e-Link for 8-bit MCU OCDS 使用手册”文件。

Holtek e-Link 引脚名称	EV 芯片引脚名称	功能
OCSDA	OCSDA	片上调试串行数据 / 地址输入 / 输出
OCDSCK	OCDSCK	片上调试时钟输入
VDD	VDD	电源
VSS	VSS	地

数据存储

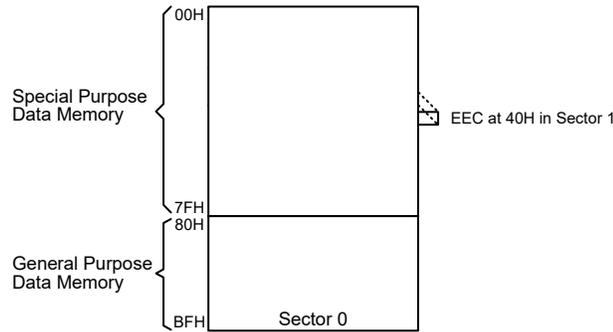
数据存储是内容可更改的 8 位 RAM 内部存储器，用来储存临时数据。

数据存储分为两部分，第一部分是特殊功能数据存储。这些寄存器有固定的地址且与单片机的正确操作密切相关。大多特殊功能寄存器都可在程序控制下直接读取和写入，但有些被加以保护而不对用户开放。第二部分数据存储是做一般用途使用，都可在程序控制下进行读取和写入。

结构

数据存储被分为若干个 Sector，都位于 8 位存储器中。每个数据存储 Sector 分为两类，特殊功能数据存储和通用数据存储。大部分特殊功能数据寄存器可在 Sector 0 被访问，处于 40H 地址的 EEC 寄存器只能在 Sector 1 中被访问到。切换不同的数据存储 Sector 可通过设置正确的存储器指针值实现。数据存储的起始地址为“00H”。

特殊功能数据存储	通用数据存储	
Sector: 地址	容量	Sector: 地址
0: 00H~7FH 1: 40H	64×8	0: 80H~BFH



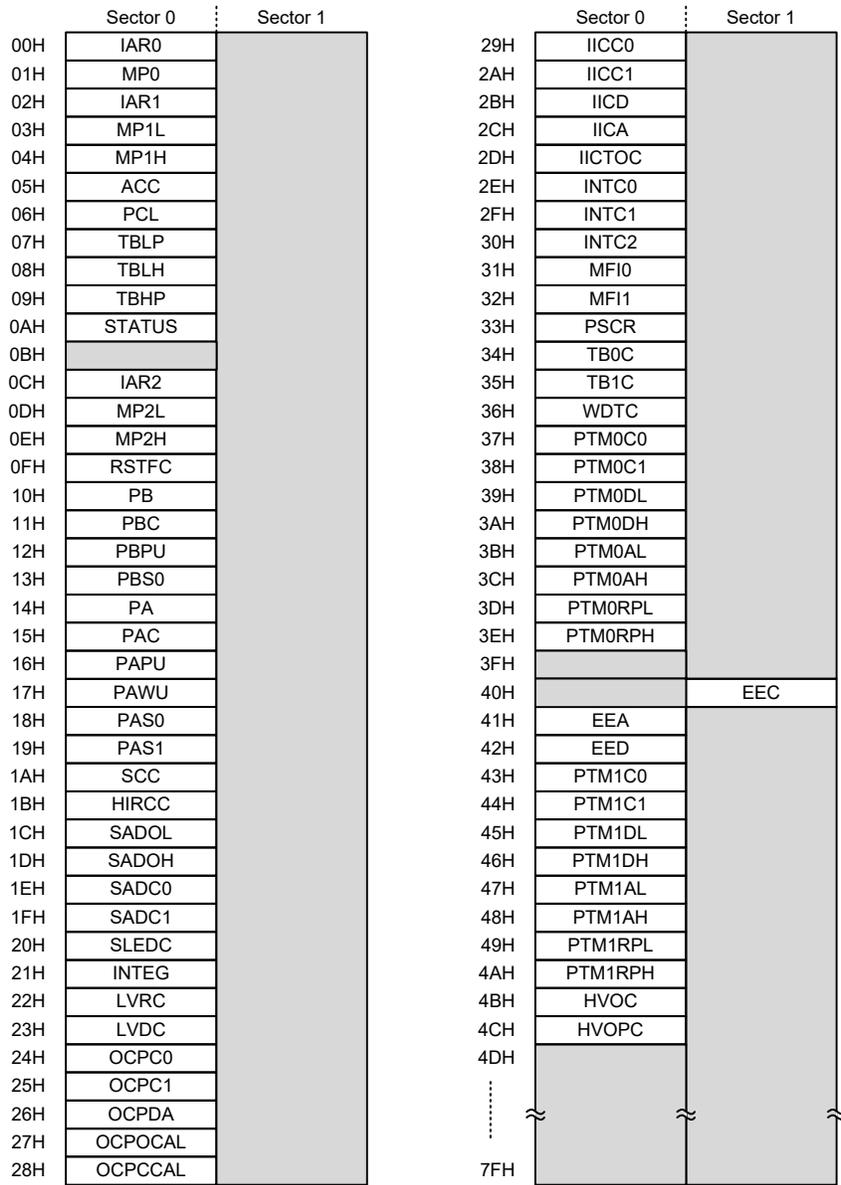
数据存储结构

通用数据存储

通用数据存储共 64 字节位于 Sector 0 的 80H~BFH。所有的单片机程序需要一个读 / 写的存储区，让临时数据可以被储存和再使用，该 RAM 区域就是通用数据存储。这个数据存储区可让使用者进行读取和写入的操作。使用位操作指令可对个别的位做置位或复位的操作，较大地方方便了用户在数据存储区内进行位操作。

特殊功能数据存储

这个区域的数据存储是存放特殊寄存器的，这些寄存器与单片机的正确操作密切相关，大多数的寄存器可进行读取和写入，只有一些是被写保护而只能读取的，相关细节的介绍请参看有关特殊功能寄存器的部分。要注意的是，任何读取指令对存储器中未定义的地址进行读取将返回“00H”。



□: Unused, read as 00H

特殊功能数据存储器结构

特殊功能寄存器

大部分特殊功能寄存器的细节将在相关功能章节描述，但有几个寄存器需在此章节单独描述。

间接寻址寄存器 – IAR0, IAR1, IAR2

间接寻址寄存器 IAR0、IAR1 和 IAR2 的地址虽位于数据存储区，但其并没有实际的物理地址。间接寻址的方法准许使用存储器指针做数据操作，以取代定义实际存储器地址的直接存储器寻址方法。在间接寻址寄存器 IAR0、IAR1 和 IAR2 上的任何动作，将对存储器指针 MP0、MP1L/MP1H 或 MP2L/MP2H 所指定的存储器地址产生对应的读 / 写操作。它们总是成对出现，IAR0 和 MP0 可以访问 Sector 0，而 IAR1 和 MP1L/MP1H、IAR2 和 MP2L/MP2H 可以访问任何 Sector。因为这些间接寻址寄存器不是实际存在的，直接读取将返回“00H”的结果，而直接写入此寄存器则不做任何操作。

存储器指针 – MP0, MP1L, MP1H, MP2L, MP2H

该单片机提供五个存储器指针，即 MP0、MP1L、MP1H、MP2L 和 MP2H。由于这些指针在数据存储区中能像普通的寄存器一般被操作，因此提供了一个寻址和数据追踪的有效方法。当对间接寻址寄存器进行任何操作时，单片机指向的实际地址是由存储器指针所指定的地址。MP0、IAR0 用于访问 Sector 0，而 MP1L/MP1H 和 IAR1、MP2L/MP2H 和 IAR2 可根据 MP1H 或 MP2H 寄存器访问所有的 Sector。直接寻址通过相关的数据存储器寻址指令来访问所有的数据 Sector。

以下例子说明如何清除一个具有 4 RAM 地址的区块，它们已事先定义成地址 adres1 到 adres4。

间接寻址程序举例 1

```
data .section `data`
adres1      db ?
adres2      db ?
adres3      db ?
adres4      db ?
block       db ?
code .section at 0 `code`
org 00h
start:
    mov a, 04h           ; setup size of block
    mov block, a
    mov a, offset adres1 ; Accumulator loaded with first RAM address
    mov mp0, a          ; setup memory pointer with first RAM address
loop:
    clr IAR0            ; clear the data at address defined by MP0
    inc mp0              ; increment memory pointer
    sdz block           ; check if last memory location has been cleared
    jmp loop
continue:
```

间接寻址程序举例 2

```
data .section `data`
adres1      db ?
adres2      db ?
adres3      db ?
adres4      db ?
block       db ?
code .section at 0 `code`
org 00h
start:
    mov a, 04h          ; setup size of block
    mov block, a
    mov a, 01h         ; setup the memory sector
    mov mp1h, a
    mov a, offset adres1 ; Accumulator loaded with first RAM address
    mov mp1l, a        ; setup memory pointer with first RAM address
loop:
    clr IAR1          ; clear the data at address defined by MP1L
    inc mp1l          ; increment memory pointer MP1L
    sdz block         ; check if last memory location has been cleared
    jmp loop
continue:
```

在上面的例子中有一点值得注意，即并没有确定 RAM 地址。

使用扩展指令直接寻址程序举例

```
data .section `data`
temp db ?
code .section at 0 `code`
org 00h
start:
    lmov a, [m]        ; move [m] data to acc
    lsub a, [m+1]      ; compare [m] and [m+1] data
    snz c              ; [m]>[m+1]?
    jmp continue      ; no
    lmov a, [m]        ; yes, exchange [m] and [m+1] data
    mov temp, a
    lmov a, [m+1]
    lmov [m], a
    mov a, temp
    lmov [m+1], a
continue:
```

注：“m”是位于任何数据存储器 Sector 的某一地址。例如，m=1F0H 表示 Sector 1 中的地址 0F0H。

累加器 – ACC

对任何单片机来说，累加器是相当重要的，且与 ALU 所完成的运算有密切关系，所有 ALU 得到的运算结果都会暂时存在 ACC 累加器里。若没有累加器，ALU 必须在每次进行如加法、减法和移位的运算时，将结果写入到数据存储器，这样会造成程序编写和时间的负担。另外数据传送也常常牵涉到累加器的临时储存功能，例如在使用者定义的一个寄存器和另一个寄存器之间传送数据时，由于两寄存器之间不能直接传送数据，因此必须通过累加器来传送数据。

程序计数器低字节寄存器 – PCL

为了提供额外的程序控制功能，程序计数器低字节设置在数据存储器的特殊功能区域内，程序员可对此寄存器进行操作，很容易的直接跳转到其它程序地址。直接给 PCL 寄存器赋值将导致程序直接跳转到程序存储器的某一地址，然而由于寄存器只有 8 位长度，因此只允许在本页的程序存储器范围内进行跳转，而当使用这种运算时，要注意会插入一个空指令周期。

表格寄存器 – TBLP, TBHP, TBLH

这三个特殊功能寄存器对存储在程序存储器中的表格进行操作。TBLP 和 TBHP 为表格指针，指向表格数据存储的地址。它们的值必须在任何表格读取指令执行前加以设定，由于它们的值可以被如“INC”或“DEC”的指令所改变，这就提供了一种简单的方法对表格数据进行读取。表格读取数据指令执行之后，表格数据高字节存储在 TBLH 中。其中要注意的是，表格数据低字节会被传送到使用者指定的地址。

状态寄存器 – STATUS

这 8 位的状态寄存器由 SC 标志位、CZ 标志位、零标志位 (Z)、进位标志位 (C)、辅助进位标志位 (AC)、溢出标志位 (OV)、暂停标志位 (PDF) 和看门狗定时器溢出标志位 (TO) 组成。这些算术 / 逻辑操作和系统运行标志位是用来记录单片机的运行状态。

除了 PDF 和 TO 标志外，状态寄存器中的位像其它大部分寄存器一样可以被改变。任何数据写入到状态寄存器将不会改变 TO 或 PDF 标志位。另外，执行不同的指令后，与状态寄存器有关的运算可能会得到不同的结果。TO 标志位只会受系统上电、看门狗溢出或执行“CLR WDT”或“HALT”指令影响。PDF 标志位只会受执行“HALT”或“CLR WDT”指令或系统上电影响。

SC、CZ、Z、OV、AC 和 C 标志位通常反映最近运算的状态。

- SC: 当 OV 与当前指令操作结果 MSB 执行“XOR”所得结果。
- CZ: 不同指令不同标志位的操作结果。详细资料请参考寄存器定义部分。
- C: 当加法运算的结果产生进位，或减法运算的结果没有产生借位时，则 C 被置位，否则 C 被清零，同时 C 也会被带进位的移位指令所影响。
- AC: 当低半字节加法运算的结果产生进位，或低半字节减法运算的结果没有产生借位时，AC 被置位，否则 AC 被清零。
- Z: 当算术或逻辑运算结果是零时，Z 被置位，否则 Z 被清零。
- OV: 当运算结果高两位的进位状态异或结果为 1 时，OV 被置位，否则 OV 被清零。
- PDF: 系统上电或执行“CLR WDT”指令会清零 PDF，而执行“HALT”指令则会置位 PDF。
- TO: 系统上电或执行“CLR WDT”或“HALT”指令会清零 TO，而当 WDT 溢出则会置位 TO。

另外，当进入一个中断程序或执行子程序调用时，状态寄存器不会自动压入到堆栈保存。假如状态寄存器的内容是重要的且子程序可能改变状态寄存器的话，则需谨慎的去做正确的储存。

STATUS 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	SC	CZ	TO	PDF	OV	Z	AC	C
R/W	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	x	x	0	0	x	x	x	x

“x”为未知

- Bit 7 **SC**: 当 OV 与当前指令操作结果 MSB 执行“XOR”所得结果
- Bit 6 **CZ**: 不同指令不同标志位的操作结果。
对于 SUB/SUBM/LSUB/LSUBM 指令, CZ 等于 Z 标志位。
对于 SBC/SBCM/LSBC/LSBCM 指令, CZ 等于上一个 CZ 标志位与当前零标志位执行“AND”所得结果。对于其它指令, CZ 标志位无影响。
- Bit 5 **TO**: 看门狗溢出标志位
0: 系统上电或执行“CLR WDT”或“HALT”指令后
1: 看门狗溢出发生
- Bit 4 **PDF**: 暂停标志位
0: 系统上电或执行“CLR WDT”指令后
1: 执行“HALT”指令
- Bit 3 **OV**: 溢出标志位
0: 无溢出
1: 运算结果高两位的进位状态异或结果为 1
- Bit 2 **Z**: 零标志位
0: 算术或逻辑运算结果不为 0
1: 算术或逻辑运算结果为 0
- Bit 1 **AC**: 辅助进位标志位
0: 无辅助进位
1: 在加法运算中低四位产生了向高四位进位, 或减法运算中低四位不发生从高四位借位
- Bit 0 **C**: 进位标志位
0: 无进位
1: 如果在加法运算中结果产生了进位, 或在减法运算中结果不发生借位
C 也受循环移位指令的影响。

EEPROM 数据存储

此单片机的一个特性是内建 EEPROM 数据存储。 “Electrically Erasable Programmable Read Only Memory” 为电可擦可编程只读存储器，由于其非易失的存储结构，即使在电源掉电的情况下存储器内的数据仍然保存完好。这种存储区扩展了 ROM 空间，对设计者来说增加了许多新的应用机会。EEPROM 可以用来存储产品编号、校准值、用户特定数据、系统配置参数或其它产品信息等。EEPROM 的数据读取和写入过程也会变的更简单。

EEPROM 数据存储结构

EEPROM 数据存储容量为 32×8。由于映射方式与程序存储器和数据存储器不同，因此不能像其它类型的存储器一样寻址。使用 Sector 0 中的一个地址和数据寄存器以及 Sector 1 中的一个控制寄存器，可以实现对 EEPROM 的单字节读写操作。

EEPROM 寄存器

有三个寄存器控制内部 EEPROM 数据存储总的操作，地址寄存器 EEA、数据寄存器 EED 及控制寄存器 EEC。EEA 和 EED 位于 Sector 0 中，它们能像其它特殊功能寄存器一样直接被访问。EEC 位于 Sector 1 中，不能被直接访问，仅能通过 MP1L/MP1H 和 IAR1 或 MP2L/MP2H 和 IAR2 进行间接读取或写入。由于 EEC 控制寄存器位于 Sector 1 中的“40H”，在 EEC 寄存器上的任何操作被执行前，MP1L 或 MP2L 必须先设为“40H”，MP1H 或 MP2H 被设为“01H”。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
EEA	—	—	—	EEA4	EEA3	EEA2	EEA1	EEA0
EED	EED7	EED6	EED5	EED4	EED3	EED2	EED1	EED0
EEC	—	—	—	—	WREN	WR	RDEN	RD

EEPROM 寄存器列表

EEA 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	EEA4	EEA3	EEA2	EEA1	EEA0
R/W	—	—	—	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	—	—	—	0	0	0	0	0

Bit 7~5 未定义，读为“0”

Bit 4~0 数据 EEPROM 地址
数据 EEPROM 地址 Bit 4~Bit 0

EED 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	EED7	EED6	EED5	EED4	EED3	EED2	EED1	EED0
R/W								
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 数据 EEPROM 数据
数据 EEPROM 数据 Bit 7~Bit 0

EEC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	WREN	WR	RDEN	RD
R/W	—	—	—	—	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	0	0	0	0

Bit 7~4 未定义，读为“0”

Bit 3 **WREN**: 数据 EEPROM 写使能位

0: 除能
1: 使能

此位为数据 EEPROM 写使能位，向数据 EEPROM 写操作之前需将此位置高。将此位清零时，则禁止向数据 EEPROM 写操作。

Bit 2 **WR**: EEPROM 写控制位

0: 写周期结束
1: 激活写周期

此位为数据 EEPROM 写控制位，由应用程序将此位置高将激活写周期。写周期结束后，硬件自动将此位清零。当 WREN 未先置高时，此位置高无效。

Bit 1 **RDEN**: 数据 EEPROM 读使能位

0: 除能
1: 使能

此位为数据 EEPROM 读使能位，向数据 EEPROM 读操作之前需将此位置高。将此位清零时，则禁止向数据 EEPROM 读操作。

Bit 0 **RD**: EEPROM 读控制位

0: 读周期结束
1: 激活读周期

此位为数据 EEPROM 读控制位，由应用程序将此位置高将激活读周期。读周期结束后，硬件自动将此位清零。当 RDEN 未首先置高时，此位置高无效。

注：在同一条指令中 WREN、WR、RDEN 和 RD 不能同时置为“1”。WR 和 RD 不能同时置为“1”。

从 EEPROM 中读取数据

从 EEPROM 中读取数据，EEC 寄存器中的读使能位 RDEN 先置为高以使能读功能，EEPROM 中读取数据的地址要先放入 EEA 寄存器中。若 EEC 寄存器中的 RD 位被置高，一个读周期将开始。若 RD 位已置为高而 RDEN 位还未被设置则不能开始读操作。若读周期结束，RD 位将自动清除为“0”，数据可以从 EED 寄存器中读取。数据在其它读或写操作执行前将一直保留在 EED 寄存器中。应用程序将轮询 RD 位以确定数据可以有效地被读取。

写数据到 EEPROM

写数据至 EEPROM，EEPROM 中写入数据的地址要先放入 EEA 寄存器中，写入的数据需存入 EED 寄存器中。EEC 寄存器中的写使能位 WREN 先置为高以使能写功能，然后 EEC 寄存器中的 WR 位需立即置高以开始写操作，这两条指令必须连续执行。总中断位 EMI 在写周期开始前应当被清零，写周期开始后再将其使能。若 WR 位已置为高而 WREN 位还未被设置则不能开始写操作。由于控制 EEPROM 写周期是一个内部时钟，与单片机的系统时钟异步，所以数据写入 EEPROM 的时间将有所延迟。可通过轮询 EEC 寄存器中的 WR 位或判断 EEPROM 写中断以侦测写周期是否完成。若写周期完成，WR 位将自动清除为“0”，通知用户数据已写入 EEPROM。因此，应用程序将轮询 WR 位以确定写周期是否结束。

写保护

防止误写入的写保护有以下几种。单片机上电后控制寄存器中的写使能位将被清除以杜绝任何写入操作。上电后存储器指针高字节寄存器将重置为“0”，这意味着数据存储区 Sector 0 被选中。由于 EEPROM 控制寄存器位于 Sector 1 中，这增加了对写操作的保护措施。在正常程序操作中确保控制寄存器中的写使能位被清除将能防止不正确的写操作。

EEPROM 中断

EEPROM 写周期结束后将产生 EEPROM 写中断，需先通过设置相关中断寄存器的 DEE 位使能 EEPROM 中断。当 EEPROM 写周期结束，DEF 请求标志位将被置位。若总中断和 EEPROM 中断使能且堆栈未满的情况下将跳转到相应的 EEPROM 中断向量中执行。当中断被响应，中断请求标志位 DEF 会被复位且 EMI 位会被清零以除能其它中断。更多细节将在中断章节讲述。

编程注意事项

必须注意的是数据不会无意写入 EEPROM。在没有写动作时写使能位被正常清零可以增强保护功能。存储器指针高字节寄存器也可以正常清零以阻止进入 EEPROM 控制寄存器存在的 Sector 1。尽管没有必要，写一个简单的读回程序以检查新写入的数据是否正确还是应该考虑的。

WREN 位置位后，EEC 寄存器中的 WR 位需立即置位，以确保写周期正确地执行。写周期执行前总中断位 EMI 应先清零，写周期开始执行后再将此位重新使能。注意，单片机不应在 EEPROM 读或写操作完全完成之前进入空闲或休眠模式，否则 EEPROM 读或写操作将失败。

程序举例

从 EEPROM 中读取数据 — 轮询法

```

MOV A, EEPROM_ADRES      ; user defined address
MOV EEA, A
MOV A, 040H              ; setup memory pointer MP1L
MOV MP1L, A              ; MP1 points to EEC register
MOV A, 01H               ; setup memory pointer MP1H
MOV MP1H, A
SET IAR1.1               ; set RDEN bit, enable read operations
SET IAR1.0               ; start Read Cycle - set RD bit
BACK:
SZ IAR1.0                ; check for read cycle end
JMP BACK
CLR IAR1                  ; disable EEPROM read/write
CLR MP1H
MOV A, EED               ; move read data to register
MOV READ_DATA, A

```

写数据到 EEPROM — 轮询法

```
MOV A, EEPROM_ADRES      ; user defined address
MOV EEA, A
MOV A, EEPROM_DATA       ; user defined data
MOV EED, A
MOV A, 040H               ; setup memory pointer MP1L
MOV MP1L, A               ; MP1 points to EEC register
MOV A, 01H                ; setup memory pointer MP1H
MOV MP1H, A
CLR EMI
SET IAR1.3                ; set WREN bit, enable write operations
SET IAR1.2                ; start Write Cycle - set WR bit - executed
                          ; immediately after set WREN bit

SET EMI
BACK:
SZ IAR1.2                 ; check for write cycle end
JMP BACK
CLR IAR1                  ; disable EEPROM read/write
CLR MP1H
```

振荡器

不同的振荡器选择可以让使用者在不同的应用需求中实现更大范围的功能。振荡器的灵活性使得在速度和功耗方面可以达到较佳的优化。振荡器选择是通过寄存器完成的。

振荡器概述

振荡器除了作为系统时钟源，还作为看门狗定时器和时基中断的时钟源。集成的内部振荡器不需要任何外围器件。较高频率的振荡器提供更高的性能，但要求有更高的功率，反之亦然。动态切换快慢系统时钟的能力使单片机具有灵活而优化的性能 / 功耗比，此特性对功耗敏感的应用领域尤为重要。

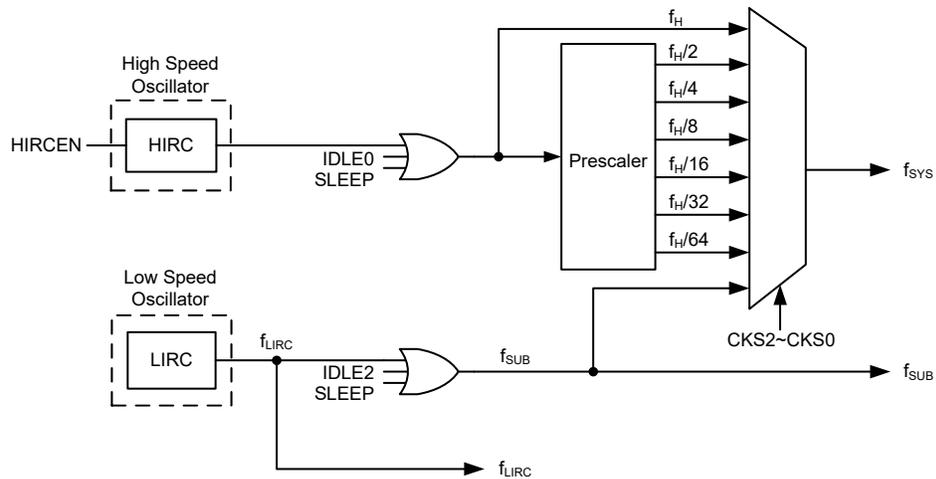
类型	名称	频率
内部高速 RC	HIRC	8MHz
内部低速 RC	LIRC	32kHz

振荡器类型

系统时钟配置

此单片机有两个系统振荡器，包括一个高速振荡器和一个低速振荡器。高速振荡器为内部 8MHz RC 振荡器。低速振荡器为内部 32kHz RC 振荡器。使用高速或低速振荡器作为系统时钟的选择是通过设置 SCC 寄存器中的 CKS2~CKS0 位决定的，系统时钟可动态选择。

低速或高速系统时钟频率由 SCC 寄存器的 CKS2~CKS0 位决定的。请注意，两个振荡器必须做出选择，即一个高速和一个低速振荡器。



系统时钟配置

内部 RC 振荡器 – HIRC

内部 RC 振荡器是一个集成的系统振荡器，不需其它外部器件。内部 RC 振荡器具有一个固定频率：8MHz。芯片在制造时进行调整且内部含有频率补偿电路，使得振荡频率因 V_{DD} 、温度以及芯片制成工艺不同的影响较大程度地降低。此振荡器工作不需要使用外部引脚。

内部 32kHz 振荡器 – LIRC

内部 32kHz 系统振荡器是一个低频振荡器。这种单片机有一个完全集成 RC 振荡器，它在 5V 电压下运行的典型频率值为 32kHz 且无需外部元件。芯片在制造时进行调整且内部含有频率补偿电路，使得振荡器因电源电压、温度及芯片制成工艺不同的影响较大程度地降低。

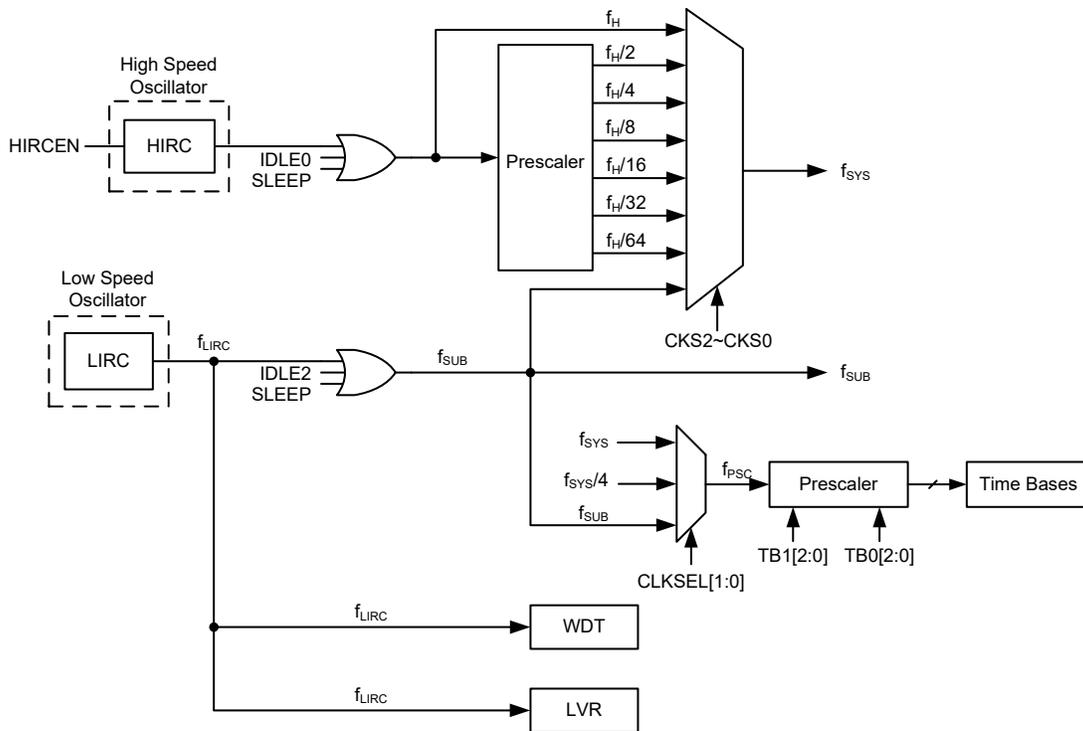
工作模式和系统时钟

现今的应用要求单片机具有较高的性能及尽可能低的功耗，这种矛盾的要求在便携式电池供电的应用领域尤为明显。高性能所需要的高速时钟将增加功耗，反之亦然。此单片机提供高、低速两种时钟源，它们之间可以动态切换，用户可通过优化单片机操作来获得较佳性能 / 功耗比。

系统时钟

单片机为 CPU 和外围功能操作提供了多种不同的时钟源。用户使用寄存器编程可获取多种时钟，进而使系统时钟获取较大的应用性能。

主系统时钟可来自高频时钟源 f_H 或低频时钟源 f_{SUB} ，通过 SCC 寄存器中的 CKS2~CKS0 位进行选择。高频时钟来自 HIRC 振荡器，低频时钟源来自 LIRC 振荡器。其它系统时钟还有高速系统振荡器的分频 $f_H/2 \sim f_H/64$ 。



单片机时钟配置

注：当系统时钟源 f_{SYS} 由 f_H 到 f_{SUB} 转换时，可以通过设置相应的使能控制位将高速振荡器停止以节省耗电，或者使其继续振荡为外围电路提供 $f_H \sim f_H/64$ 频率的时钟源。

系统工作模式

单片机有 6 种不同的工作模式，每种有它自身的特性，根据应用中不同的性能和功耗要求可选择不同的工作模式。单片机正常工作有两种模式：正常模式和低速模式。剩余的 4 种工作模式：休眠模式、空闲模式 0、空闲模式 1 和空闲模式 2 用于单片机 CPU 关闭时以节省耗电。

工作模式	CPU	寄存器设置			f _{sys}	f _H	f _{sub}	f _{LIRC}
		FHIDEN	FSIDEN	CKS2~CKS0				
正常模式	On	x	x	000~110	f _H ~f _H /64	On	On	On
低速模式	On	x	x	111	f _{sub}	On/Off ⁽¹⁾	On	On
空闲模式 0	Off	0	1	000~110	Off	Off	On	On
				111	On			
空闲模式 1	Off	1	1	xxx	On	On	On	On
空闲模式 2	Off	1	0	000~110	On	On	Off	On
				111	Off			
休眠模式	Off	0	0	xxx	Off	Off	Off	On/Off ⁽²⁾

“x”表示不相关

注：1. 在低速模式下，f_H 开启或关闭由相应的振荡器使能位控制。

2. 在休眠模式下，f_{LIRC} 开启或关闭由 WDT 功能使能或除能控制。

正常模式

顾名思义，这是主要的工作模式之一，单片机的所有功能均可在此模式中实现且系统时钟由一个高速振荡器提供。该模式下单片机正常工作的时钟源来自 HIRC 振荡器。高速振荡器频率可被分为 1~64 的不等比率，实际的比率由 SCC 寄存器中的 CKS2~CKS0 位选择。单片机使用高速振荡器分频作为系统时钟可减少工作电流。

低速模式

此模式的系统时钟虽为较低速时钟源，但单片机仍能正常工作。该低速时钟源来自 f_{sub}，而 f_{sub} 来自 LIRC 振荡器。在低速模式下，f_H 的开启或关闭由相应的振荡器使能位 HIRCEN 来决定。

休眠模式

执行 HALT 指令后且 SCC 寄存器中的 FHIDEN 和 FSIDEN 位都为低时，系统进入休眠模式。在休眠模式中，CPU 停止运行。然而若看门狗定时器功能使能，f_{LIRC} 将继续运行。若看门狗定时器功能除能，f_{LIRC} 也会停止运行。

空闲模式 0

执行 HALT 指令后且 SCC 寄存器中的 FHIDEN 位为低、FSIDEN 位为高时，系统进入空闲模式 0。在空闲模式 0 中，CPU 停止，但低速振荡器会开启以驱动一些外围功能。

空闲模式 1

执行 HALT 指令后且 SCC 寄存器中的 FHIDEN 和 FSIDEN 位都为高时，系统进入空闲模式 1。在空闲模式 1 中，CPU 停止，但高速和低速振荡器都会开启以保持一些外围功能继续工作。

空闲模式 2

执行 HALT 指令后且 SCC 寄存器中的 FHIDEN 位为高、FSIDEN 位为低时，系统进入空闲模式 2。在空闲模式 2 中，CPU 停止，但高速振荡器会开启以保持一些外围功能继续工作。

控制寄存器

寄存器 SCC 和 HIRCC 用于控制系统时钟和相应的振荡器配置。

SCC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	CKS2	CKS1	CKS0	—	—	—	FHIDEN	FSIDEN
R/W	R/W	R/W	R/W	—	—	—	R/W	R/W
POR	0	0	0	—	—	—	0	0

Bit 7~5 **CKS2~CKS0**: 系统时钟选择位

000: f_H
 001: $f_H/2$
 010: $f_H/4$
 011: $f_H/8$
 100: $f_H/16$
 101: $f_H/32$
 110: $f_H/64$
 111: f_{SUB}

这三位用于选择系统时钟源。除了 f_H 或 f_{SUB} 提供的系统时钟源外，也可使用高频振荡器的分频作为系统时钟。

Bit 4~2 未定义，读为“0”

Bit 1 **FHIDEN**: CPU 关闭时高频振荡器控制位

0: 除能
 1: 使能

此位用来控制在执行 HALT 指令 CPU 关闭后高速振荡器是被激活还是停止。

Bit 0 **FSIDEN**: CPU 关闭时低频振荡器控制位

0: 除能
 1: 使能

此位用来控制在执行 HALT 指令 CPU 关闭后低速振荡器是被激活还是停止。无论是 LIRC 被选择作为低速振荡器时钟源还是 WDT 功能使能，LIRC 振荡器都是由该位与 WDT 功能控制位共同控制的。如果该位被清零，但 WDT 功能使能，LIRC 振荡器也将使能。

HIRCC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	HIRCF	HIRCEN
R/W	—	—	—	—	—	—	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	—	—	0	1

Bit 7~2 未定义，读为“0”

Bit 1 **HIRCF**: HIRC 振荡器稳定标志位

0: HIRC 不稳定
 1: HIRC 稳定

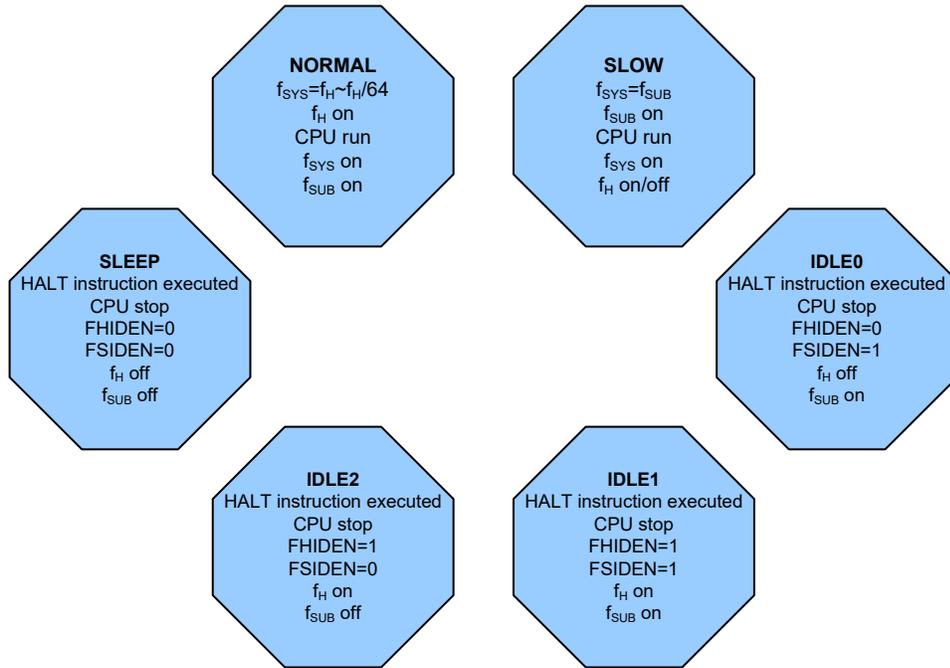
此位用于表明 HIRC 振荡器是否稳定。HIRCEN 位置高使能 HIRC 振荡器，HIRCF 位会先被清零，在 HIRC 稳定后会被置高。

Bit 0 **HIRCEN**: HIRC 振荡器使能控制位
 0: 除能
 1: 使能

工作模式切换

单片机可在各个工作模式间自由切换，使得用户可根据所需选择较佳的性能 / 功耗比。用此方式，对单片机工作的性能要求不高的情况下，可使用较低频时钟以减少工作电流，在便携式应用上延长电池的使用寿命。

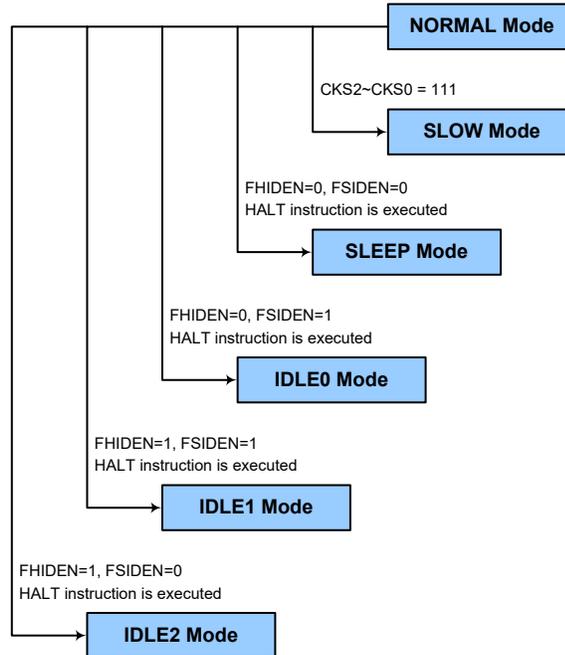
简单来说，正常模式和低速模式间的切换仅需设置 SCC 寄存器中的 CKS2~CKS0 位即可实现，而正常模式 / 低速模式与休眠模式 / 空闲模式间的切换经由 HALT 指令实现。当 HALT 指令执行后，单片机是否进入空闲模式或休眠模式由 SCC 寄存器中的 FHIDEN 和 FSIDEN 位决定的。



正常模式切换到低速模式

系统运行在正常模式时使用高速系统振荡器，因此较为耗电。可通过设置 SCC 寄存器中的 CKS2~CKS0 位为“111”使系统时钟切换至运行在低速模式下。此时将使用低速系统振荡器以节省耗电。用户可在对性能要求不高的操作中使用此方法以减少耗电。

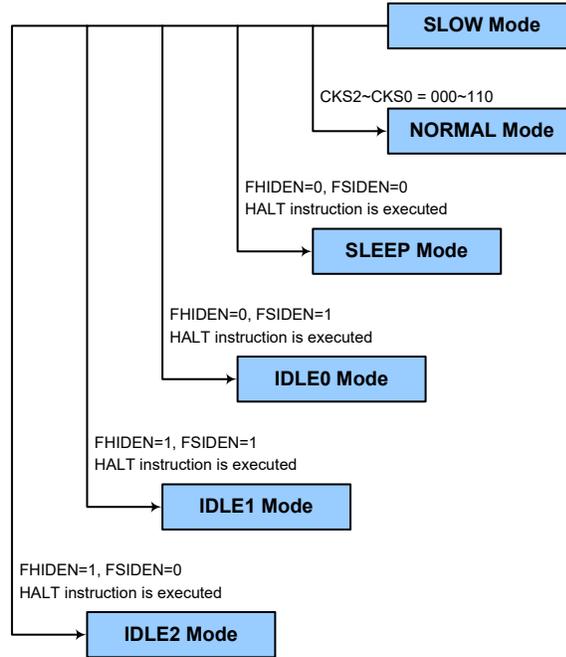
低速模式的时钟源来自 LIRC 振荡器，因此要求此振荡器在所有模式切换动作发生前稳定下来。



低速模式切换到正常模式

在低速模式时系统时钟来自 f_{SUB} 。切换回正常模式时，需设置 $CKS2 \sim CKS0$ 位为“000”~“110”使系统时钟从 f_{SUB} 切换到 $f_H \sim f_H/64$ 。

然而，如果在低速模式下 f_H 因未使用而关闭，那么从低速模式切换到正常模式时，它需要一定的时间来重新起振和稳定，可通过检测 HIRCC 寄存器中的 HIRCF 位进行判断，所需的高速系统振荡器稳定时间指定在交流电气特性中。



进入休眠模式

进入休眠模式的方法仅有一种——应用程序中执行“HALT”指令前需设置 SCC 寄存器中的 FHIDEN 和 FSIDEN 位都为“0”。在这种模式下，除了 WDT 以外的所有时钟和功能都将关闭。在上述条件下执行该指令后，将发生的情况如下：

- 系统时钟停止运行，应用程序停止在“HALT”指令处。
- 数据存储器和寄存器的内容和寄存器将保持当前值。
- 输入 / 输出口将保持当前值。
- 状态寄存器中暂停标志 PDF 将被置起，看门狗溢出标志 TO 将被清除。
- 如果 WDT 功能使能，WDT 将被清零并重新开始计数。如果 WDT 功能除能，WDT 将被清零并停止计数。

进入空闲模式 0

进入空闲模式 0 的方法仅有一种——应用程序中执行“HALT”指令前需设置 SCC 寄存器中的 FHIDEN 位为“0”且 FSIDEN 位为“1”。在上述条件下执行该指令后，将发生的情况如下：

- f_H 时钟停止运行，应用程序停止在“HALT”指令处，但 f_{SUB} 时钟将继续运行。
- 数据存储器和寄存器的内容和寄存器将保持当前值。
- 输入 / 输出口将保持当前值。
- 状态寄存器中暂停标志 PDF 将被置起，看门狗溢出标志 TO 将被清除。
- 如果 WDT 功能使能，WDT 将被清零并重新开始计数。如果 WDT 功能除能，WDT 将被清零并停止计数。

进入空闲模式 1

进入空闲模式 1 的方法仅有一种——应用程序中执行“HALT”指令前需设置 SCC 寄存器中的 FHIDEN 和 FSIDEN 位都为“1”。在上述条件下执行该指令后，将发生的情况如下：

- f_H 和 f_{SUB} 时钟开启，应用程序停止在“HALT”指令处。
- 数据存储器和寄存器的内容和寄存器将保持当前值。
- 输入 / 输出口将保持当前值。
- 状态寄存器中暂停标志 PDF 将被置起，看门狗溢出标志 TO 将被清除。
- 如果 WDT 功能使能，WDT 将被清零并重新开始计数。如果 WDT 功能除能，WDT 将被清零并停止计数。

进入空闲模式 2

进入空闲模式 2 的方法仅有一种——应用程序中执行“HALT”指令前需设置 SCC 寄存器中的 FHIDEN 位为“1”且 FSIDEN 位为“0”。在上述条件下执行该指令后，将发生的情况如下：

- f_H 时钟开启， f_{SUB} 时钟关闭，应用程序停止在“HALT”指令处。
- 数据存储器和寄存器的内容和寄存器将保持当前值。
- 输入 / 输出口将保持当前值。
- 状态寄存器中暂停标志 PDF 将被置起，看门狗溢出标志 TO 将被清除。

- 如果 WDT 功能使能，WDT 将被清零并重新开始计数。如果 WDT 功能除能，WDT 将被清零并停止计数。

待机电流注意事项

由于单片机进入休眠或空闲模式的主要原因是将 MCU 的电流降低到尽可能低，可能到只有几个微安的级别（空闲模式 1 和空闲模式 2 除外），所以如果要降低电路的电流进一步降低，电路设计者还应有其它的考虑。应该特别注意的是单片机的输入 / 输出引脚。所有高阻抗输入脚都必须连接到固定的高或低电平，因为引脚浮空会造成内部振荡并导致耗电增加。这也应用于有不同封装的单片机，因为它们可能含有未引出的引脚，这些引脚也必须设为输出或带有上拉电阻的输入。

另外还需注意单片机设为输出的 I/O 引脚上的负载。应将它们设置在有最小拉电流的状态或将它们和其它的 CMOS 输入一样接到没有拉电流的外部电路上。还应注意的，如果选择 LIRC 振荡器，会导致耗电增加。

在空闲模式 1 和空闲模式 2 中，高速振荡器开启。若外围功能时钟源来自高速振荡器，额外的待机电流也可能会有几百微安。

唤醒

单片机进入休眠模式或空闲模式后，系统时钟将停止以降低功耗。然而单片机再次唤醒，原来的系统时钟重新起振、稳定且恢复正常工作需要一定的时间。

系统进入休眠或空闲模式之后，可以通过以下几种方式唤醒：

- PA 口下降沿
- 系统中断
- WDT 溢出

单片机执行 HALT 指令，PDF 将被置位；系统上电或执行清除看门狗的指令，PDF 将被清零。看门狗计数器溢出将会置位 TO 标志并唤醒系统，这种复位会重置程序计数器和堆栈指针，其它标志保持原有状态。

PA 口中的每个引脚都可以通过 PAWU 寄存器使能下降沿唤醒功能。PA 端口唤醒后，程序将在“HALT”指令后继续执行。如果系统是通过中断唤醒，则有两种可能发生。第一种情况是：相关中断除能或是中断使能且堆栈已满，则程序会在“HALT”指令之后继续执行。这种情况下，唤醒系统的中断会等到相关中断使能或有堆栈层可以使用之后才执行。第二种情况是：相关中断使能且堆栈未滿，则中断可以马上执行。如果在进入休眠或空闲模式之前中断标志位已经被设置为“1”，则相关中断的唤醒功能将无效。

看门狗定时器

看门狗定时器的功能在于防止如电磁的干扰等外部不可控制事件，所造成的程序不正常动作或跳转到未知的地址。

看门狗定时器时钟源

WDT 定时器时钟源由内部 RC 振荡器 LIRC 提供。看门狗定时器的时钟源可分频为 $2^8 \sim 2^{18}$ 以提供更大的溢出周期，分频比由 WDTC 寄存器中的 WS2~WS0 位来决定。内部振荡器 LIRC 的频率大约为 32kHz，这个特殊的内部时钟周期随 V_{DD} 、温度和制成的不同而变化。

看门狗定时器控制寄存器

WDTC 寄存器用于控制 WDT 功能的使能 / 除能和复位 MCU 操作及选择溢出周期。

WDTC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	WE4	WE3	WE2	WE1	WE0	WS2	WS1	WS0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	1	0	1	0	0	1	1

Bit 7~3 **WE4~WE0**: WDT 软件控制位

10101: 除能
01010: 使能
其它值: MCU 复位

若因外部环境噪声或软件设置使这些位的值发生改变，则在 2~3 个 f_{LIRC} 周期后产生复位，复位后 RSTFC 寄存器中的 WRF 标志位会被置位。

Bit 2~0 **WS2~WS0**: WDT 溢出周期选择位

000: $2^8/f_{LIRC}$
001: $2^{10}/f_{LIRC}$
010: $2^{12}/f_{LIRC}$
011: $2^{14}/f_{LIRC}$
100: $2^{15}/f_{LIRC}$
101: $2^{16}/f_{LIRC}$
110: $2^{17}/f_{LIRC}$
111: $2^{18}/f_{LIRC}$

这三位控制 WDT 时钟源的分频比，从而实现对 WDT 溢出周期的控制。

RSTFC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	LVRF	LRF	WRF
R/W	—	—	—	—	—	R/W	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	—	x	0	0

“x” 为未知

Bit 7~3 未定义，读为 “0”

Bit 2 **LVRF**: LVR 复位标志位
具体描述见其它章节

Bit 1 **LRF**: LVR 控制寄存器软件复位标志位
具体描述见其它章节

Bit 0 **WRF:** WDT 控制寄存器软件复位标志位
 0: 未发生
 1: 发生
 当发生 WDT 控制寄存器软件复位时，此位被置为“1”，且只能通过应用程序清零。

看门狗定时器操作

当 WDT 溢出时，它产生一个芯片复位的动作。这也就意味着正常工作期间，用户需在应用程序中看门狗溢出前有策略地清看门狗定时器以防止其产生复位，可使用清除看门狗指令实现。无论什么原因，程序失常跳转到一个未知的地址或进入一个死循环，这些清除指令都不能被正确执行，此种情况下，看门狗将溢出以使单片机复位。看门狗定时器控制寄存器 WDT 中的 WE4~WE0 位可提供使能 / 除能控制以及控制看门狗定时器复位操作。当 WE4~WE0 设置为“10101B”时除能 WDT 功能，而当设置为“01010B”时使能 WDT 功能。如果 WE4~WE0 设置为除“01010B”和“10101B”以外的值时，则经过 2~3 个 f_{LIRC} 时钟周期后单片机复位。上电后这些位初始化为“01010B”。

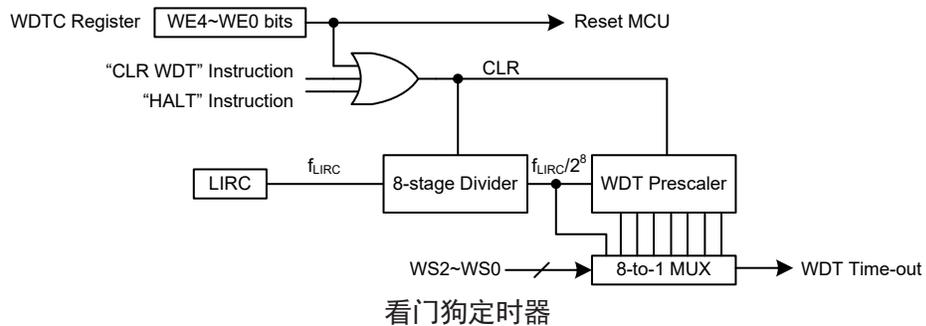
WE4~WE0 位	WDT 功能
10101B	除能
01010B	使能
其它值	MCU 复位

看门狗定时器使能 / 除能控制

程序正常运行时，WDT 溢出将导致芯片复位，并置位状态标志位 TO。若系统处于休眠或空闲模式，当 WDT 发生溢出时，状态寄存器中的 TO 应置位，仅 PC 和堆栈指针复位。有三种方法可以用来清除 WDT 的内容。第一种是通过 WDT 软件复位，即将 WE4~WE0 位设置成除了 01010B 和 10101B 外的任意值，第二种是通过软件清除指令，而第三种是通过“HALT”指令。

该单片机只使用一条清看门狗指令“CLR WDT”。因此只要执行“CLR WDT”便清除 WDT。

当设置分频比为 2^{18} 时，溢出周期最大。例如，时钟源为 32kHz LIRC 振荡器，分频比为 2^{18} 时最大溢出周期约 8s，分频比为 2^8 时最小溢出周期约 7.8ms。



复位和初始化

复位功能在任何单片机中基本的部分，使得单片机可以设定一些与外部参数无关的先置条件。最重要的复位条件是在单片机首次上电以后，经过短暂的延迟，内部硬件电路使得单片机处于预期的稳定状态并开始执行第一条程序指令。上电复位以后，在程序执行之前，部分重要的内部寄存器将会被设定为预先设定的状态。程序计数器就是其中之一，它会被清除为零，使得单片机从最低的程序存储器地址开始执行程序。

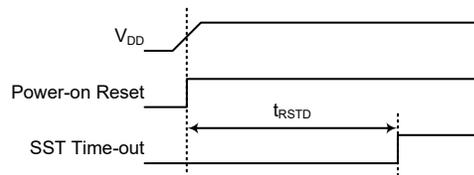
另一种复位为看门狗溢出单片机复位。不同方式的复位操作会对寄存器产生不同的影响。另一种复位为低电压复位即 LVR 复位，在电源供应电压低于 LVR 设定值时，系统会产生 LVR 复位。

复位功能

单片机包含几种由内部事件触发的复位方式。

上电复位

这是最基本且不可避免的复位，发生在单片机上电后。除了保证程序存储器从开始地址执行，上电复位也使得其它寄存器被设定在预设条件。所有的输入/输出端口控制寄存器在上电复位时会保持高电平，以确保上电后所有引脚被设定为输入状态。

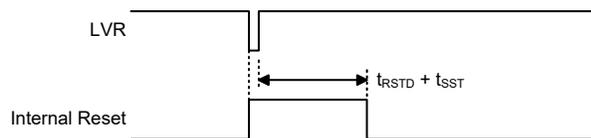


注： t_{RSTD} 为上电延迟时间，典型值为 50ms。

上电复位时序图

低电压复位 – LVR

单片机具有低电压复位电路，用来监测它的电源电压。LVR 始终使能于特定的电压值， V_{LVR} 。例如在更换电池的情况下，单片机供应的电压可能会在 $0.9V \sim V_{LVR}$ 之间，这时 LVR 将会自动复位单片机且 RSTFC 寄存器中的 LVRF 标志位置位。LVR 包含以下的规格：有效的 LVR 信号，即在 $0.9V \sim V_{LVR}$ 的低电压状态的时间，必须超过 LVD/LVR 电气特性中 t_{LVR} 参数的值。如果低电压存在不超过 t_{LVR} 参数的值，则 LVR 将会忽略它且不会执行复位功能。 V_{LVR} 参数值通过 LVRC 寄存器设置。若因为环境噪声或软件设置修改了 LVRC 寄存器的值，LVC 将在 2~3 个 f_{LIRC} 时钟周期后复位单片机。同时 RSTFC 寄存器 LRF 位将被置“1”。上电复位后 LVRC 的初始值是 01010101B。需要注意的是，当单片机进入空闲或休眠模式，LVR 功能将自动关闭。



注： t_{RSTD} 为上电延迟时间，典型值为 50ms。

低电压复位时序图

• LVRC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	LVS7	LVS6	LVS5	LVS4	LVS3	LVS2	LVS1	LVS0
R/W								
POR	0	1	0	1	0	1	0	1

Bit 7~0 **LVS7~LVS0**: LVR 电压选择

01010101: 2.1V
00110011: 2.55V
10011001: 3.15V
10101010: 3.8V

其它值: MCU 复位一寄存器复位为 POR 值

若低电压情况发生且满足以上定义的低电压复位值, 则单片机复位。需要低电压保持时间超过 t_{LVR} 以后响应复位。此时复位后的寄存器内容保持不变。

除了以上定义的低电压复位值外, 其它值也能导致单片机复位。需要经过 2~3 个 f_{LIRC} 时钟周期响应复位。但此时寄存器内容将复位为 POR 值。

• RSTFC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	LVRF	LRF	WRF
R/W	—	—	—	—	—	R/W	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	—	x	0	0

“x” 为未知

Bit 7~3 未定义, 读为 “0”

Bit 2 **LVRF**: LVR 复位标志位

0: 未发生
1: 发生

当特定的低电压复位条件发生时, 此位被置为 “1”, 且只能通过应用程序清零。

Bit 1 **LRF**: LVR 控制寄存器软件复位标志位

0: 未发生
1: 发生

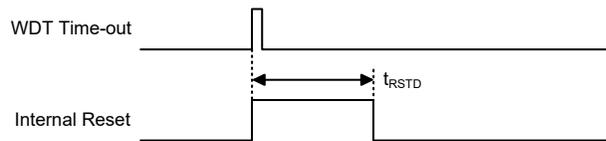
如果 LVRC 寄存器包含任何非定义的 LVR 电压值, 此位被置为 “1”, 这类似于软件复位功能, 且只能通过应用程序清零。

Bit 0 **WRF**: WDT 控制寄存器软件复位标志位

具体描述见其它章节

正常运行时看门狗溢出复位

除了看门狗溢出标志位 TO 将被设为 “1” 之外, 正常运行时看门狗溢出复位和 LVR 复位相同。

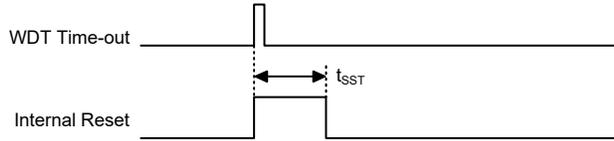


注: t_{RSTD} 为上电延迟时间, 典型值为 16.7ms。

正常运行时看门狗溢出时序图

休眠或空闲时看门狗溢出复位

休眠或空闲时看门狗溢出复位和其它种类的复位有些不同。除了程序计数器与堆栈指针将被清“0”及 TO 位被设为“1”外，绝大部分的条件保持不变。图中 t_{SST} 的详细说明请参考交流电气特性。



休眠或空闲时看门狗溢出复位时序图

复位初始状态

不同的复位形式以不同的途径影响复位标志位。这些标志位，即 PDF 和 TO 位存放在状态寄存器中，由休眠或空闲模式功能或看门狗计数器等几种控制器操作控制。复位标志位如下所示：

TO	PDF	复位条件
0	0	上电复位
u	u	正常模式或低速模式时的 LVR 复位
1	u	正常模式或低速模式时的 WDT 溢出复位
1	1	空闲或休眠模式时的 WDT 溢出复位

“u”代表不改变

在单片机上电复位之后，各功能单元初始化的情形，列于下表。

项目	复位后情况
程序计数器	清除为零
中断	所有中断被除能
看门狗定时器	WDT 清除并重新计数
定时器模块	所有定时器模块停止
输入 / 输出口	I/O 口设为输入模式
堆栈指针	堆栈指针指向堆栈顶端

不同的复位形式对单片机内部寄存器的影响是不同的。为保证复位后程序能正常执行，了解寄存器在特定条件复位后的设置是非常重要的。下表即为不同方式复位后内部寄存器的状况。

寄存器	上电复位	WDT 溢出 (正常模式)	WDT 溢出 (暂停模式)
IAR0	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
MP0	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
IAR1	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
MP1L	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
MP1H	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
ACC	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
PCL	0000 0000	0000 0000	0000 0000
TBLP	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
TBLH	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu

寄存器	上电复位	WDT 溢出 (正常模式)	WDT 溢出 (暂停模式)
TBHP	---- -xxx	---- -uuu	---- -uuu
STATUS	xx00 xxxx	xx1u uuuu	uull uuuu
IAR2	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
MP2L	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
MP2H	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
RSTFC	---- -x00	---- -uuu	---- -uuu
PB	---- 1111	---- 1111	---- uuuu
PBC	---- 1111	---- 1111	---- uuuu
PBPU	---- 0000	---- 0000	---- uuuu
PBS0	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PA	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
PAC	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
PAPU	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PAWU	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PAS0	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PAS1	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
SCC	000- --00	000- --00	uuu- --uu
HIRCC	---- --01	---- --01	---- --uu
SADOL (ADRFs=0)	xxxx ----	xxxx ----	xxxx ----
SADOL (ADRFs=1)	xxxx xxxx	xxxx xxxx	xxxx xxxx
SADOH (ADRFs=0)	xxxx xxxx	xxxx xxxx	uuuu uuuu
SADOH (ADRFs=1)	---- xxxx	---- xxxx	---- uuuu
SADC0	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
SADC1	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
SLEDC	--00 0000	--00 0000	--uu uuuu
INTEG	---- 0000	---- 0000	---- uuuu
LVRC	0101 0101	0101 0101	uuuu uuuu
LVDC	--00 0000	--00 0000	--uu uuuu
OCPC0	0000 ---0	0000 ---0	uuuu ---u
OCPC1	--00 0000	--00 0000	--uu uuuu
OCPDA	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
OCPOCAL	0010 0000	0010 0000	uuuu uuuu
OCPCAL	0001 0000	0001 0000	uuuu uuuu
IICC0	---- 000-	---- 000-	---- uuu-
IICC1	1000 0001	1000 0001	uuuu uuuu
IICD	xxxx xxxx	xxxx xxxx	uuuu uuuu
IICA	0000 000-	0000 000-	uuuu uuu-
IICTOC	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
INTC0	-000 0000	-000 0000	-uuu uuuu
INTC1	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu

寄存器	上电复位	WDT 溢出 (正常模式)	WDT 溢出 (暂停模式)
INTC2	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
MFIO	--00 --00	--00 --00	--uu --uu
MFII	--00 --00	--00 --00	--uu --uu
PSCR	---- --00	---- --00	---- --uu
TB0C	0--- -000	0--- -000	u--- -uuu
TB1C	0--- -000	0--- -000	u--- -uuu
WDTC	0101 0011	0101 0011	uuuu uuuu
PTM0C0	0000 0---	0000 0---	uuuu u---
PTM0C1	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PTM0DL	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PTM0DH	---- --00	---- --00	---- --uu
PTM0AL	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PTM0AH	---- --00	---- --00	---- --uu
PTM0RPL	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PTM0RPH	---- --00	---- --00	---- --uu
PTMIC0	0000 0---	0000 0---	uuuu u---
PTMIC1	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
EEA	---0 0000	---0 0000	---u uuuu
EED	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PTM1DL	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PTM1DH	---- --00	---- --00	---- --uu
PTM1AL	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PTM1AH	---- --00	---- --00	---- --uu
PTM1RPL	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PTM1RPH	---- --00	---- --00	---- --uu
HVOC	---- 0000	---- 0000	---- uuuu
HVOPC	---- 0000	---- 0000	---- uuuu
EEC	---- 0000	---- 0000	---- uuuu

注：“u”表示不改变
“x”表示未知
“-”表示未定义

输入 / 输出端口

Holtek 单片机的输入 / 输出控制具有很大的灵活性。大部分引脚可在用户程序控制下被设定为输入或输出。所有引脚的上拉电阻设置以及指定引脚的唤醒设置也都由软件控制，这些特性也使得此类单片机在广泛应用上都能符合开发的需求。

该单片机提供 PA~PB 双向输入 / 输出。这些寄存器在数据存储寄存器有特定的地址。所有 I/O 口用于输入输出操作。作为输入操作，输入引脚无锁存功能，也就是说输入数据必须在执行“MOV A, [m]”，T2 的上升沿准备好，m 为端口地址。对于输出操作，所有数据都是被锁存的，且保持不变直到输出锁存被重写。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
PAWU	PAWU7	PAWU6	PAWU5	PAWU4	PAWU3	PAWU2	PAWU1	PAWU0
PAPU	PAPU7	PAPU6	PAPU5	PAPU4	PAPU3	PAPU2	PAPU1	PAPU0
PA	PA7	PA6	PA5	PA4	PA3	PA2	PA1	PA0
PAC	PAC7	PAC6	PAC5	PAC4	PAC3	PAC2	PA1	PAC0
PBPU	—	—	—	—	PBPU3	PBPU2	PBPU1	PBPU0
PB	—	—	—	—	PB3	PB2	PB1	PB0
PBC	—	—	—	—	PBC3	PBC2	PBC1	PBC0

I/O 口寄存器列表

上拉电阻

许多产品应用在端口处于输入状态时需要外加一个上拉电阻来实现上拉的功能。为了免去外部上拉电阻，当引脚规划为输入时，可由内部连接到一个上拉电阻。这些上拉电阻可通过寄存器 PAPU 和 PBPU 来设置，它用一个 PMOS 晶体管来实现上拉电阻功能。

当 I/O 引脚设为数字输入或设为 NMOS 输出时，上拉电阻功能才会受 PxPU 控制开启，其他状态均为关闭。

PAPU 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PAPU7	PAPU6	PAPU5	PAPU4	PAPU3	PAPU2	PAPU1	PAPU0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **PAPU7~PAPU0:** PA 口 bit 7 ~ bit 0 上拉功能控制位
 0: 除能
 1: 使能

PBPU 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	PBPU3	PBPU2	PBPU1	PBPU0
R/W	—	—	—	—	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	0	0	0	0

Bit 7~4 未定义，读为“0”

Bit 3~0 **PBPU3~PBPU0**: PB 口 bit 3 ~ bit 0 上拉功能控制位
0: 除能
1: 使能

PA 口唤醒

当使用暂停指令“HALT”迫使单片机进入休眠或空闲模式，单片机的系统时钟将会停止以降低功耗，此功能对于电池及低功耗应用很重要。唤醒单片机有很多种方法，其中之一就是使 PA 口的其中一个引脚从高电平转为低电平。这个功能特别适合于通过外部开关来唤醒的应用。PA 口的每个引脚可以通过设置 PAWU 寄存器来单独选择是否具有唤醒功能。

当引脚功能为通用 I/O 输入时，且 MCU 处于 HALT 模式时，唤醒功能才会受 PAWU 控制开启，其他状态均为关闭。

PAWU 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PAWU7	PAWU6	PAWU5	PAWU4	PAWU3	PAWU2	PAWU1	PAWU0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **PAWU7~PAWU0**: PA 口 bit 7 ~ bit 0 唤醒功能控制位
0: 除能
1: 使能

输入 / 输出端口控制寄存器

每一个输入 / 输出端口都具有各自的控制寄存器，即 PAC~PBC，用来控制输入 / 输出状态。从而每个 I/O 引脚都可以通过软件控制，动态的设置为 CMOS 输出或输入。所有的 I/O 端口的引脚都各自对应于 I/O 端口控制的某一位。若 I/O 引脚要实现输入功能，则对应的控制寄存器的位需要设置为“1”。这时程序指令可以直接读取输入脚的逻辑状态。若控制寄存器相应的位被设定为“0”，则此引脚被设置为 CMOS 输出。当引脚设置为输出状态时，程序指令读取的是输出端口寄存器的内容。注意，如果对输出口做读取动作时，程序读取到的是内部输出数据锁存器中的状态，而不是输出引脚上实际的逻辑状态。

PAC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PAC7	PAC6	PAC5	PAC4	PAC3	PAC2	PAC1	PAC0
R/W								
POR	1	1	1	1	1	1	1	1

Bit 7~0 **PAC7~PAC0**: PA 口 bit 7 ~ bit 0 输入 / 输出控制位
0: 输出
1: 输入

PBC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	PBC3	PBC2	PBC1	PBC0
R/W	—	—	—	—	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	1	1	1	1

Bit 7~4 未定义，读为“0”

Bit 3~0 **PBC3~PBC0**: PB 口 bit 3 ~ bit 0 输入 / 输出控制位
0: 输出
1: 输入

输入 / 输出端口源电流控制

该单片机的每个 I/O 口都支持不同的源电流驱动能力。通过设置相应的选择寄存器 SLEDC，每个 I/O 口可以支持四个级别的源电流驱动能力。用户可参考直流电气特性章节为不同应用选择所需的源电流。

SLEDC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	SLEDC5	SLEDC4	SLEDC3	SLEDC2	SLEDC1	SLEDC0
R/W	—	—	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	—	—	0	0	0	0	0	0

Bit 7~6 未使用，读为“0”

Bit 5~4 **SLEDC5~SLEDC4**: PB3~PB0 源电流选择位
00: 源电流 = Level 0 (最小值)
01: 源电流 = Level 1
10: 源电流 = Level 2
11: 源电流 = Level 3 (最大值)

Bit 3~2 **SLEDC3~SLEDC2**: PA7~PA4 源电流选择位
00: 源电流 = Level 0 (最小值)
01: 源电流 = Level 1
10: 源电流 = Level 2
11: 源电流 = Level 3 (最大值)

Bit 1~0 **SLEDC1~SLEDC0**: PA3~PA0 源电流选择位
00: 源电流 = Level 0 (最小值)
01: 源电流 = Level 1
10: 源电流 = Level 2
11: 源电流 = Level 3 (最大值)

注：用户可参考直流电气特性章节为不同应用获取源电流的准确值。

引脚共用功能

引脚的多功能可以增加单片机应用的灵活性。有限的引脚个数将会限制设计者，而引脚的多功能将会解决很多此类问题。此外，这些引脚功能可以通过一系列寄存器进行设定。

引脚共用功能选择寄存器

封装中有限的引脚个数会对某些单片机功能造成影响。然而，引脚功能共用和引脚功能选择，使得小封装单片机具有更多不同的功能。单片机包含端口“x”输出功能选择寄存器“n”，记为 PxSn，这些寄存器可以用来选择共用引脚的特定功能。

要注意的一点是，确保所需的引脚共用功能被正确地选择和取消。要选择所需的引脚共用功能，首先应通过相应的引脚共用控制寄存器正确地选择该功能，然后再配置相应的功能设置最后再使能此功能。要正确地取消引脚共用功能，首先应除能该功能，然后再修改相应的引脚共用控制寄存器以选择其它的共用功能。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
PAS0	PAS07	PAS06	PAS05	PAS04	PAS03	PAS02	PAS01	PAS00
PAS1	PAS17	PAS16	PAS15	PAS14	PAS13	PAS12	PAS11	PAS10
PBS0	PBS07	PBS06	PBS05	PBS04	PBS03	PBS02	PBS01	PBS00

引脚共用功能选择寄存器列表

PAS0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PAS07	PAS06	PAS05	PAS04	PAS03	PAS02	PAS01	PAS00
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 7~6 **PAS07~PAS06:** PA3 引脚共用功能选择位
 00: PA3
 01: VREF, 用于 OCP DAC 输入参考电压
 10: VREF, 用于 ADC 和 OCP DAC 输入参考电压
 11: AN3
- Bit 5~4 **PAS05~PAS04:** PA2 引脚共用功能选择位
 00: PA2/PTP0I
 01: PA2/PTP0I
 10: PA2/PTP0I
 11: AN2
- Bit 3~2 **PAS03~PAS02:** PA1 引脚共用功能选择位
 00: PA1/PTCK0
 01: PTP0B
 10: OCPI
 11: AN1
- Bit 1~0 **PAS01~PAS00:** PA0 引脚共用功能选择位
 00: PA0
 01: PTP0
 10: PA0
 11: AN0

PAS1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PAS17	PAS16	PAS15	PAS14	PAS13	PAS12	PAS11	PAS10
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 7~6 **PAS17~PAS16:** PA7 引脚共用功能选择位
 00: PA7/PTP1I
 01: PA7/PTP1I
 10: PA7/PTP1I
 11: AN7
- Bit 5~4 **PAS15~PAS14:** PA6 引脚共用功能选择位
 00: PA6/PTCK1
 01: PA6/PTCK1
 10: PA6/PTCK1
 11: AN6
- Bit 3~2 **PAS13~PAS12:** PA5 引脚共用功能选择位
 00: PA5
 01: PA5
 10: PA5
 11: AN5
- Bit 1~0 **PAS11~PAS10:** PA4 引脚共用功能选择位
 00: PA4/INT0
 01: PA4/INT0
 10: PA4/INT0
 11: AN4

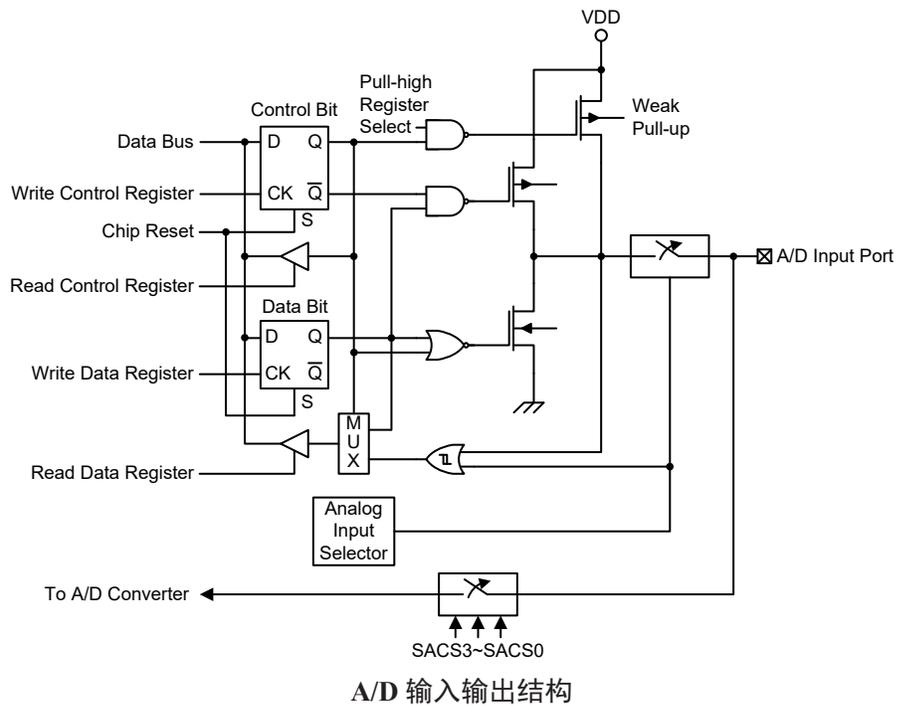
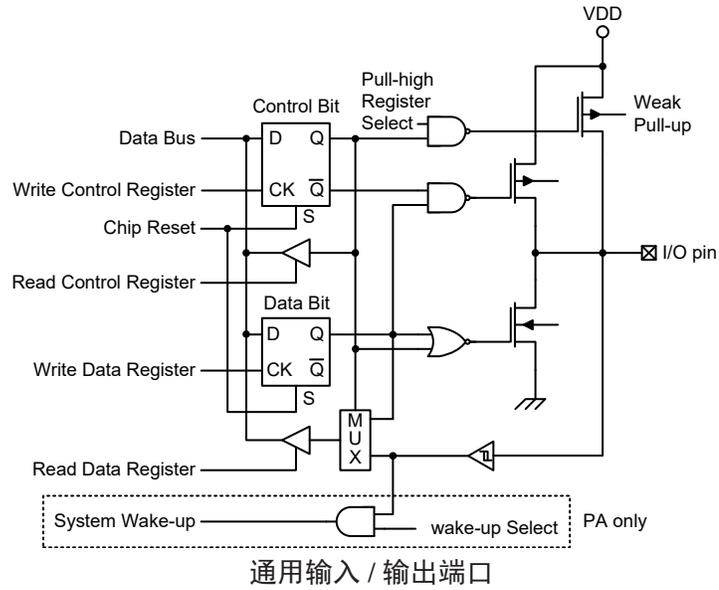
PBS0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PBS07	PBS06	PBS05	PBS04	PBS03	PBS02	PBS01	PBS00
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 7~6 **PBS07~PBS06:** PB3 引脚共用功能选择位
 00: PB3
 01: SCL
 10: PB3
 11: PB3
- Bit 5~4 **PBS05~PBS04:** PB2 引脚共用功能选择位
 00: PB2
 01: SDA
 10: PB2
 11: PB2
- Bit 3~2 **PBS03~PBS02:** PB1 引脚共用功能选择位
 00: PB1
 01: PTP1B
 10: PB1
 11: PB1
- Bit 1~0 **PBS01~PBS00:** PB0 引脚共用功能选择位
 00: PB0/INT1
 01: PTP1
 10: PB0/INT1
 11: PB0/INT1

输入 / 输出引脚结构

下图为输入 / 输出引脚的内部结构图。输入 / 输出引脚的准确逻辑结构图可能与此图不同，这里只是为了方便对 I/O 引脚功能的理解提供的一个参考。



编程注意事项

在编程中，最先要考虑的是端口的初始化。复位之后，所有的输入 / 输出数据及端口控制寄存器都将被设为逻辑高。所有输入 / 输出引脚默认为输入状态，而其电平则取决于其它相连接电路以及是否选择了上拉电阻。如果端口控制寄存器 PAC~PBC，某些引脚位被设定输出状态，这些输出引脚会有初始高电平输出，除非数据寄存器端口 PA~PB 在程序中被预先设定。设置哪些引脚是输入及哪些引脚是输出，可通过设置正确的值到适当的端口控制寄存器，或使用指令“SET [m].i”及“CLR [m].i”来设定端口控制寄存器中个别的位。注意，当使用这些位控制指令时，系统即将产生一个读 - 修改 - 写的操作。单片机需要先读入整个端口上的数据，修改个别的位，然后重新把这些数据写入到输出端口。PA 口的每个引脚都带唤醒功能。单片机处于休眠或空闲模式时，有很多方法可以唤醒单片机，其中之一就是通过 PA 任一引脚电平从高到低转换的方式，可以设置 PA 口一个或多个引脚具有唤醒功能。

定时器模块 – TM

控制和测量时间在任何单片机中都是一个很重要的部分。该单片机提供几个定时器模块 (简称 TM)，来实现和时间有关的功能。定时器模块是包括多种操作的定时单元，提供的操作有：定时 / 事件计数器，捕捉输入，比较匹配输出，单脉冲输出以及 PWM 输出等功能。每个定时器模块有两个独立中断。每个 TM 外加的输入输出引脚，扩大了定时器的灵活性，便于用户使用。

这里只简单介绍周期型 TM 的基本特性，更多详细资料请参考周期型 TM 章节。

简介

该单片机包含两个周期型 TM，记为 PTM0 和 PTM1。本章介绍周期型 TM 的一些特性，更多详细资料见后面章节。PTM 的基本功能见下表。

TM 功能	PTM
定时 / 计数器	√
捕捉输入	√
比较匹配输出	√
PWM 通道数	1
单脉冲输出	1
PWM 对齐方式	边沿对齐
PWM 调节周期 & 占空比	占空比或周期

TM 功能概要

TM 操作

周期型 TM 提供从简单的定时操作到 PWM 信号产生等多种功能。理解 TM 操作的关键是比较 TM 内独立运行的计数器的值与内部比较器的预置值。当计数器的值与比较器的预置值相同时，则比较匹配，TM 中断信号产生，清零计数器并改变 TM 输出引脚的状态。用户选择内部时钟或外部时钟来驱动内部 TM 计数器。

TM 时钟源

驱动 TM 计数器的时钟源很多。通过设置 PTMn 控制寄存器的 PTnCK2~PTnCK0 位，选择所需的时钟源。该时钟源来自系统时钟 f_{SYS} 的分频比或内部高速时钟 f_H 或 f_{SUB} 时钟源或外部 PTCKn 引脚。PTCKn 引脚时钟源用于允许外部信号作为 TM 时钟源或用于事件计数。

TM 中断

周期型 TM 拥有两个内部中断，分别是内部比较器 A 或比较器 P，当比较匹配发生时产生 TM 中断。当 TM 中断产生时，计数器清零并改变 TM 输出引脚的状态。

TM 外部引脚

每个 TM 都有两个 TM 输入引脚 PTCKn 和 PTPnI。PTMn 输入引脚 PTCKn 作为 PTMn 时钟源输入脚，通过设置 PTMnC0 寄存器中的 PTnCK2~PTnCK0 位进行选择。外部时钟源可通过该引脚来驱动内部 PTMn。PTCKn 引脚可选择上升沿有效或下降沿有效。此外，PTCKn 引脚还可用作 PTMn 单脉冲输出模式的外部触发引脚或捕捉输入模式的信号输入引脚。

另一种 TM 输入引脚 PTPnI 作为捕捉输入脚，其有效边沿有上升沿、下降沿和双沿，通过设置 PTMnC1 寄存器中的 PTnIO1~PTnIO0 位来选择有效边沿类型。除了 PTPnI 引脚外，PTCKn 引脚也可用作 PTMn 捕捉输入模式的外部触发引脚。

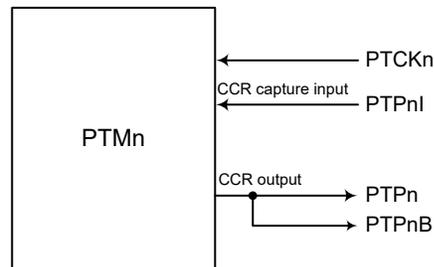
每个 TM 都有两个输出引脚 PTPn 和 PTPnB。PTPnB 是 PTPn 输出的反相信号。当 TM 工作在比较匹配输出模式且比较匹配发生时，这些引脚会由 TM 控制切换到高电平或低电平或翻转。外部 PTPn 或 PTPnB 输出引脚也被 TM 用来产生 PWM 输出波形。因 TM 输出引脚与其它功能共用，故在使用 TM 输出功能时需要先行设置相应的引脚共用功能选择寄存器。

PTM0		PTM1	
输入	输出	输入	输出
PTCK0, PTP0I	PTP0, PTP0B	PTCK1, PTP1I	PTP1, PTP1B

TM 外部引脚

TM 输入 / 输出引脚选择

通过设置与 TM 输入 / 输出引脚相关的引脚共用功能选择寄存器的位，选择作为 TM 输入 / 输出功能或其它共用功能。正确设置选择位将相应的引脚用作 TM 输入 / 输出。更多引脚共用功能选择详见引脚共用功能章节。

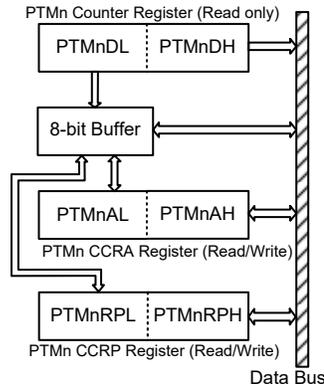


PTM 功能引脚控制框图 (n=0 或 1)

编程注意事项

TM 计数寄存器和捕捉 / 比较寄存器 CCRA 和 CCRP，都为 10-bit，含有低字节和高字节结构。高字节可直接访问，低字节则仅能通过一个内部 8-bit 的缓存器进行访问。值得注意的是 8-bit 缓存器的存取数据及相关低字节的读写操作仅在其相应的高字节读取操作发生时发生。

CCRA 和 CCRP 寄存器访问方式如下图所示，读写这些成对的寄存器需通过特殊的方式。建议使用“MOV”指令按照以下步骤访问 CCRA 或 CCRP 低字节寄存器，即 PTMnAL 和 PTMnRPL，否则可能导致无法预期的结果。

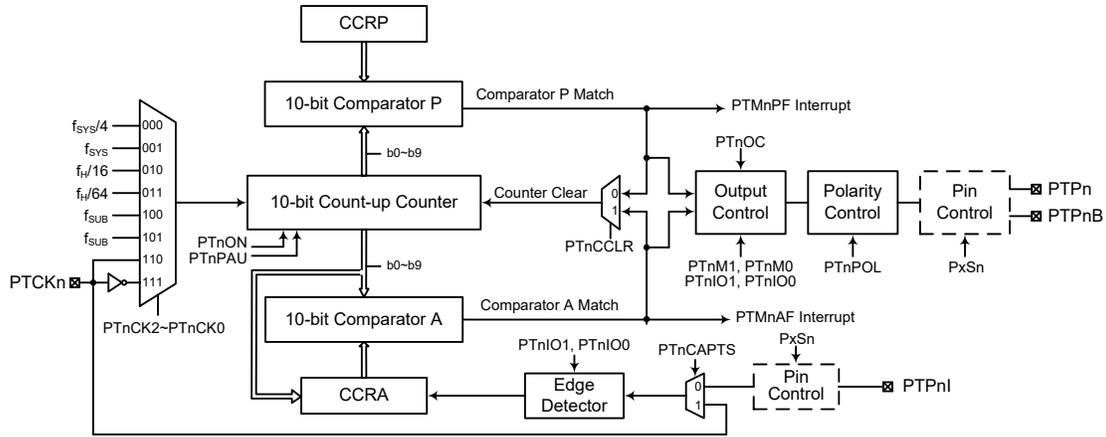


读写流程如下步骤所示：

- 写数据至 CCRA 或 CCRP
 - ◆ 步骤 1. 写数据至低字节寄存器 PTMnAL 或 PTMnRPL
 - 注意，此时数据仅写入 8-bit 缓存器。
 - ◆ 步骤 2. 写数据至高字节寄存器 PTMnAH 或 PTMnRPH
 - 注意，此时数据直接写入高字节寄存器，同时锁存在 8-bit 缓存器中的数据写入低字节寄存器。
- 由计数器寄存器和 CCRA 或 CCRP 中读取数据
 - ◆ 步骤 1. 由高字节寄存器 PTMnDH、PTMnAH 或 PTMnRPH 读取数据
 - 注意，此时高字节寄存器中的数据直接读取，同时由低字节寄存器读取的数据锁存至 8-bit 缓存器中。
 - ◆ 步骤 2. 由低字节寄存器 PTMnDL、PTMnAL 或 PTMnRPL 读取数据
 - 注意，此时读取 8-bit 缓存器中的数据。

周期型 TM – PTM

周期型 TM 包括 5 种工作模式，即比较匹配输出、定时 / 事件计数器、捕捉输入、单脉冲输出和 PWM 输出模式。周期型 TM 由两个外部输入脚控制并驱动两个外部输出脚。



周期型 TM 方框图 (n=0 或 1)

周期型 TM 操作

周期型 TM 是 10 位宽度。周期型 TM 核心是一个由用户选择的内部或外部时钟源驱动的 10 位向上计数器，它还包括两个内部比较器即比较器 A 和比较器 P。这两个比较器将计数器的值与 CCRA 和 CCRP 寄存器中的值进行比较。CCRP 和 CCRA 是 10 位的，与计数器的所有位比较。

通过应用程序改变 10 位计数器值的唯一方法是使 PTnON 位发生上升沿跳变清除计数器。此外，计数器溢出或比较匹配也会自动清除计数器。上述条件发生时，通常情况会产生 PTMn 中断信号。周期型 TM 可工作在不同的模式，可由包括来自输入脚的不同时钟源驱动，也可以控制输出脚。所有工作模式的设定都是通过设置相关寄存器来实现的。

周期型 TM 寄存器介绍

周期型 TM 的所有操作由一系列寄存器控制。一对只读寄存器用来存放 10 位计数器的值，两对读 / 写寄存器存放 10 位 CCRA 和 CCRP 的值。剩下两个控制寄存器用来设置不同的操作和控制模式。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
PTMnC0	PTnPAU	PTnCK2	PTnCK1	PTnCK0	PTnON	—	—	—
PTMnC1	PTnM1	PTnM0	PTnIO1	PTnIO0	PTnOC	PTnPOL	PTnCAPTS	PTnCCCLR
PTMnDL	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
PTMnDH	—	—	—	—	—	—	D9	D8
PTMnAL	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
PTMnAH	—	—	—	—	—	—	D9	D8
PTMnRPL	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
PTMnRPH	—	—	—	—	—	—	D9	D8

10-bit 周期型 TM 寄存器列表 (n=0 或 1)

PTMnC0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PTnPAU	PTnCK2	PTnCK1	PTnCK0	PTnON	—	—	—
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	—	—	—
POR	0	0	0	0	0	—	—	—

Bit 7 **PTnPAU**: PTMn 计数器暂停控制位

- 0: 运行
- 1: 暂停

通过设置此位为高可使计数器暂停，清零此位恢复正常计数器操作。当处于暂停条件时，PTMn 保持上电状态并继续耗电。当此位由低到高转变时，计数器将保留其剩余值，直到此位再次改变为低电平，并从此值开始继续计数。

Bit 6~4 **PTnCK2~PTnCK0**: 选择 PTMn 计数时钟位

- 000: $f_{SYS}/4$
- 001: f_{SYS}
- 010: $f_H/16$
- 011: $f_H/64$
- 100: f_{SUB}
- 101: f_{SUB}
- 110: PTCKn 上升沿
- 111: PTCKn 下降沿

此三位用于选择 PTMn 的时钟源。外部引脚时钟源能被选择在上升沿或下降沿有效。 f_{SYS} 是系统时钟， f_H 和 f_{SUB} 是其它的内部时钟源，细节方面请参考振荡器章节

Bit 3 **PTnON**: PTMn 计数器 On/Off 控制位

- 0: Off
- 1: On

此位控制 PTMn 的总开关功能。设置此位为高则使能计数器使其运行，清零此位则除能 PTMn。清零此位将停止计数器并关闭 PTMn 减少耗电。当此位经由低到高转变时，内部计数器将复位清零；当此位经由高到低转换时，内部计数器将保持其剩余值，直到此位再次改变为高电平。

若 PTMn 处于比较匹配输出模式时，当 PTnON 位经由低到高转换时，PTMn 输出脚将复位至 PTnOC 位指定的初始值。

Bit 2~0 未定义，读为“0”

PTMnC1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PTnM1	PTnM0	PTnIO1	PTnIO0	PTnOC	PTnPOL	PTnCAPTS	PTnCCLR
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~6 **PTnM1~PTnM0**: 选择 PTMn 工作模式位

- 00: 比较匹配输出模式
- 01: 捕捉输入模式
- 10: PWM 输出模式或单脉冲输出模式
- 11: 定时 / 计数器模式

这两位设置 PTMn 需要的工作模式。为了确保操作可靠，PTMn 应在 PTnM1 和 PTnM0 位有任何改变前先关掉。在定时 / 计数器模式，PTMn 输出脚控制必须除能。

Bit 5~4	<p>PTnIO1~PTnIO0: 选择 PTMn 外部引脚 PTPn 或 PTPnI/PTCKn 功能位</p> <p>比较匹配输出模式</p> <ul style="list-style-type: none">00: 无变化01: 输出低10: 输出高11: 输出翻转 <p>PWM 输出模式 / 单脉冲输出模式</p> <ul style="list-style-type: none">00: 强制无效状态01: 强制有效状态10: PWM 输出11: 单脉冲输出 <p>捕捉输入模式</p> <ul style="list-style-type: none">00: 在 PTPnI 或 PTCKn 上升沿输入捕捉01: 在 PTPnI 或 PTCKn 下降沿输入捕捉10: 在 PTPnI 或 PTCKn 双沿输入捕捉11: 输入捕捉除能 <p>定时 / 计数器模式</p> <p>未使用</p> <p>此两位用于决定在一定条件达到时 PTMn 输出脚如何改变状态。这两位值的选择取决于 PTMn 运行在哪种模式下。</p> <p>在比较匹配输出模式下，PTnIO1 和 PTnIO0 位决定当从比较器 A 比较匹配输出发生时 PTMn 输出脚如何改变状态。当从比较器 A 比较匹配输出发生时 PTMn 输出脚能设为切换高、切换低或翻转当前状态。若此两位同时为 0 时，这个输出将不会改变。PTMn 输出脚的初始值通过 PTMnC1 寄存器的 PTnOC 位设置取得。注意，由 PTnIO1 和 PTnIO0 位得到的输出电平必须与通过 PTnOC 位设置的初始值不同，否则当比较匹配发生时，PTMn 输出脚将不会发生变化。在 PTMn 输出脚改变状态后，通过 PTnON 位由低到高电平的转换复位至初始值。</p> <p>在 PWM 输出模式，PTnIO1 和 PTnIO0 用于决定比较匹配条件发生时怎样改变 PTMn 输出脚的状态。PWM 输出功能通过这两位的变化进行更新。仅在 PTMn 关闭时改变 PTnIO1 和 PTnIO0 位的值是很有必要的。若在 PTMn 运行时改变 PTnIO1 和 PTnIO0 的值，PWM 输出的值是无法预料的。</p>
Bit 3	<p>PTnOC: PTMn PTPn 输出控制位</p> <p>比较匹配输出模式</p> <ul style="list-style-type: none">0: 初始低1: 初始高 <p>PWM 输出模式 / 单脉冲输出模式</p> <ul style="list-style-type: none">0: 低有效1: 高有效 <p>这是 PTMn 输出脚输出控制位。它取决于 PTMn 此时正运行于比较匹配输出模式还是 PWM 输出模式 / 单脉冲输出模式。若 PTMn 处于定时 / 计数器模式，则其不受影响。在比较匹配输出模式时，比较匹配发生前其决定 PTMn 输出脚的逻辑电平值。在 PWM 输出模式时，其决定 PWM 信号是高有效还是低有效。</p>
Bit 2	<p>PTnPOL: PTMn PTPn 输出极性控制位</p> <ul style="list-style-type: none">0: 同相1: 反相 <p>此位控制 PTPn 输出脚的极性。此位为高时 PTMn 输出脚反相，为低时 PTMn 输出脚同相。若 PTMn 处于定时 / 计数器模式时其不受影响。</p>
Bit 1	<p>PTnCAPTS: 选择 PTMn 捕捉触发源</p> <ul style="list-style-type: none">0: 来自 PTPnI 引脚1: 来自 PTCKn 引脚
Bit 0	<p>PTnCCLR: 选择 PTMn 计数器清零条件位</p> <ul style="list-style-type: none">0: PTMn 比较器 P 匹配1: PTMn 比较器 A 匹配 <p>此位用于选择清除计数器的方法。周期型 PTMn 包括两个比较器—比较器 A 和比较器 P，两者都可以用作清除内部计数器。PTnCCLR 位设为高，计数器在比</p>

较器 A 比较匹配发生时被清除；此位设为低，计数器在比较器 P 比较匹配发生或计数器溢出时被清除。计数器溢出清除的方法仅在 CCRP 被清除为 0 时才能生效。PTnCCLR 位在 PWM 输出模式、单脉冲或输入捕捉模式时未使用。

PTMnDL 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R	R	R	R	R	R	R	R
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **D7~D0:** PTMn 计数器低字节寄存器 bit 7 ~ bit 0
PTMn 10-bit 计数器 bit 7 ~ bit 0

PTMnDH 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	D9	D8
R/W	—	—	—	—	—	—	R	R
POR	—	—	—	—	—	—	0	0

Bit 7~2 未定义，读为“0”
Bit 1~0 **D9~D8:** PTMn 计数器高字节寄存器 bit 1 ~ bit 0
PTMn 10-bit 计数器 bit 9 ~ bit 8

PTMnAL 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **D7~D0:** PTMn CCRA 低字节寄存器 bit 7 ~ bit 0
PTMn 10-bit CCRA bit 7 ~ bit 0

PTMnAH 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	D9	D8
R/W	—	—	—	—	—	—	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	—	—	0	0

Bit 7~2 未定义，读为“0”
Bit 1~0 **D9~D8:** PTMn CCRA 高字节寄存器 bit 1 ~ bit 0
PTMn 10-bit CCRA bit 9 ~ bit 8

PTMnRPL 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **D7~D0:** PTMn CCRP 低字节寄存器 bit 7 ~ bit 0
PTMn 10-bit CCRP bit 7 ~ bit 0

PTMnRPH 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	D9	D8
R/W	—	—	—	—	—	—	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	—	—	0	0

Bit 7~2 未定义，读为“0”

Bit 1~0 **D9~D8**: PTMn CCRP 高字节寄存器 bit 1 ~ bit 0
PTMn 10-bit CCRP bit 9 ~ bit 8

周期型 TM 工作模式

周期型 TM 有五种工作模式，即比较匹配输出模式、PWM 输出模式、单脉冲输出模式、捕捉输入模式或定时 / 计数器模式。通过设置 PTMnC1 寄存器的 PTnM1 和 PTnM0 位选择任意模式。

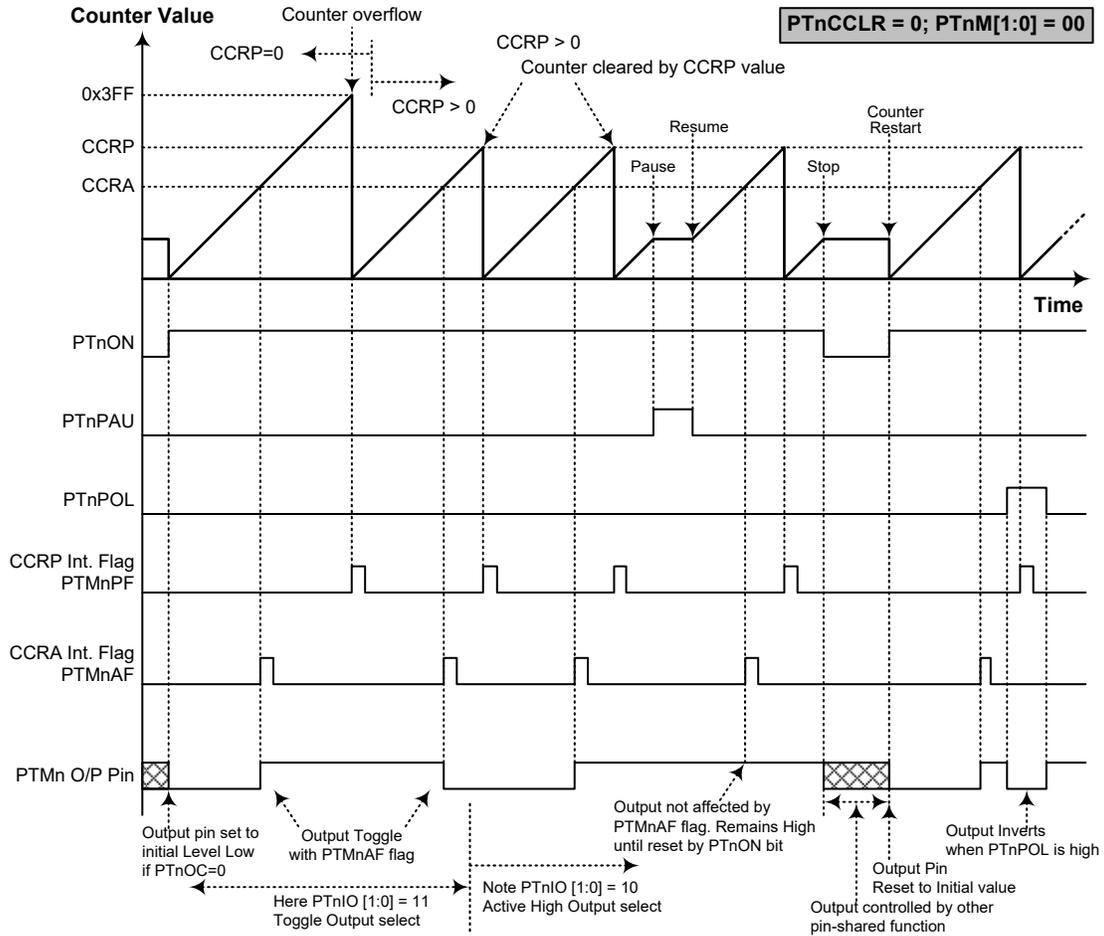
比较匹配输出模式

为使 PTMn 工作在此模式，PTMnC1 寄存器的 PTnM1 和 PTnM0 位需要设置为“00”。当工作在该模式，一旦计数器使能并开始计数，有三种方法来清零，分别是：计数器溢出，比较器 A 比较匹配发生和比较器 P 比较匹配发生。当 PTnCCLR 位为低，有两种方法清除计数器。一种是比较器 P 比较匹配发生，另一种是 CCRP 所有位设置为零并使得计数器溢出。此时，比较器 A 和比较器 P 的请求标志位 PTMnAF 和 PTMnPF 将分别置起。

如果 PTMnC1 寄存器的 PTnCCLR 位设置为高，当比较器 A 比较匹配发生时计数器被清零。此时，即使 CCRP 寄存器的值小于 CCRA 寄存器的值，仅 PTMnAF 中断请求标志产生。所以当 PTnCCLR 为高时，不会产生 PTMnPF 中断请求标志。在比较匹配输出模式中，CCRA 寄存器值不能设为“0”。

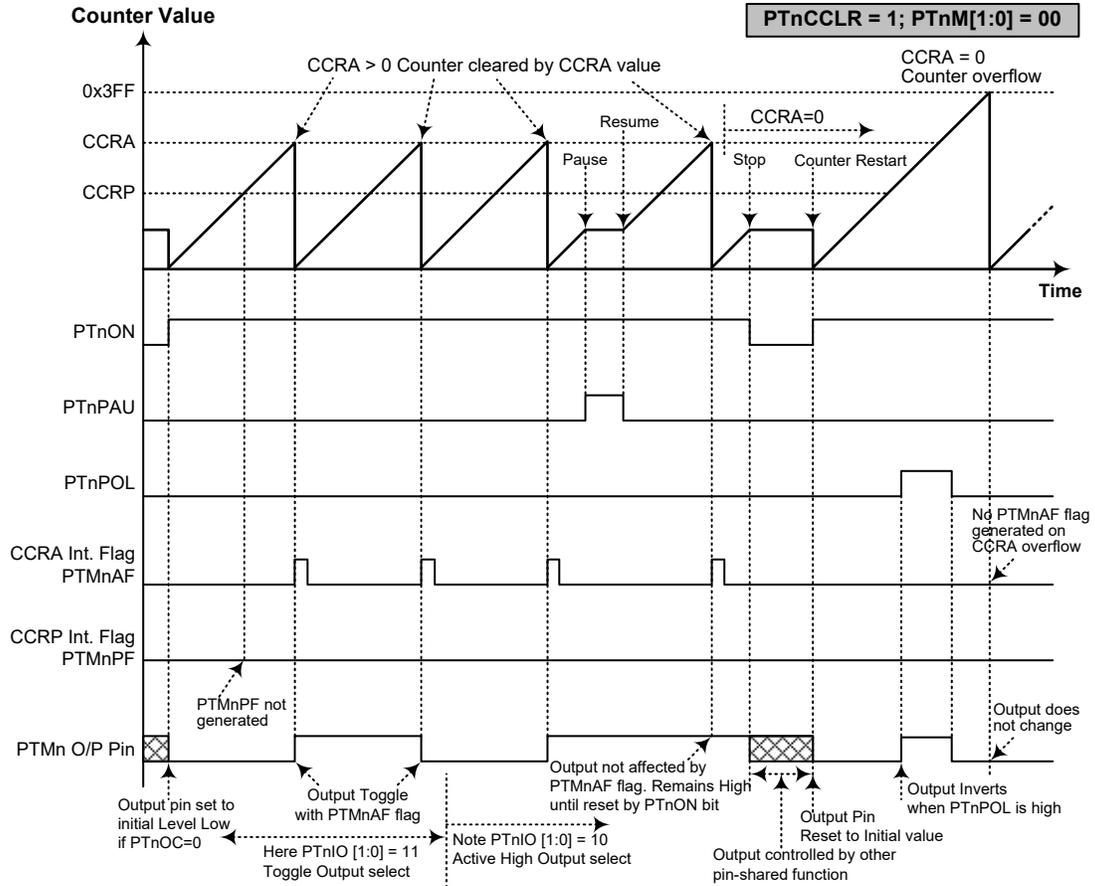
如果 CCRA 被清零，当计数达到最大值 3FFH 时，计数器溢出，而此时不产生 PTMnAF 请求标志。

正如该模式名所言，当比较匹配发生后，PTMn 输出脚状态改变。当比较器 A 比较匹配发生后 PTMnAF 中断请求标志产生时，PTMn 输出脚状态改变。比较器 P 比较匹配发生时产生的 PTMnPF 标志不影响 PTMn 输出脚。PTMn 输出脚状态改变方式由 PTMnC1 寄存器中 PTnIO1 和 PTnIO0 位决定。当比较器 A 比较匹配发生时，PTnIO1 和 PTnIO0 位决定 PTMn 输出脚输出高，低或翻转当前状态。PTMn 输出脚初始值，在 PTnON 位由低到高电平的变化后通过 PTnOC 位设置。注意，若 PTnIO1 和 PTnIO0 位同时为 0 时，引脚输出不变。



比较器匹配输出模式 – PTnCCLR=0 (n=0 或 1)

- 注：1. PTnCCLR=0, 比较器 P 匹配将清除计数器
2. PTMn 输出脚仅由 PTMnAF 标志位控制
3. 在 PTnON 上升沿 PTMn 输出脚复位至初始值



比较器匹配输出模式 – PTnCCLR=1 (n=0 或 1)

- 注：1. PTnCCLR=1，比较器 P 匹配将清除计数器
 2. PTMn 输出脚仅由 PTMnAF 标志位控制
 3. 在 PTnON 上升沿 PTMn 输出脚复位至初始值
 4. 当 PTnCCLR=1 时，不会产生 PTMnPF 标志

定时 / 计数器模式

为使 PTMn 工作在此模式，PTMnC1 寄存器的 PTnM1 和 PTnM0 位需要设置为“11”。定时 / 计数器模式与比较输出模式操作方式相同，并产生同样的中断请求标志。不同的是，在定时 / 计数器模式下 PTMn 输出脚未使用。因此，比较匹配输出模式中的描述和时序图可以适用于此功能。该模式中未使用的 PTMn 输出脚用作普通 I/O 脚或其它功能。

PWM 输出模式

为使 PTMn 工作在此模式，PTMnC1 寄存器的 PTnM1 和 PTnM0 位需要设置为“10”，且 PTnIO1 和 PTnIO0 位也需要设置为“10”。PTMn 的 PWM 功能在马达控制，加热控制，照明控制等方面十分有用。给 PTMn 输出脚提供一个频率固定但占空比可调的信号，将产生一个有效值等于 DC 均方根的 AC 方波。

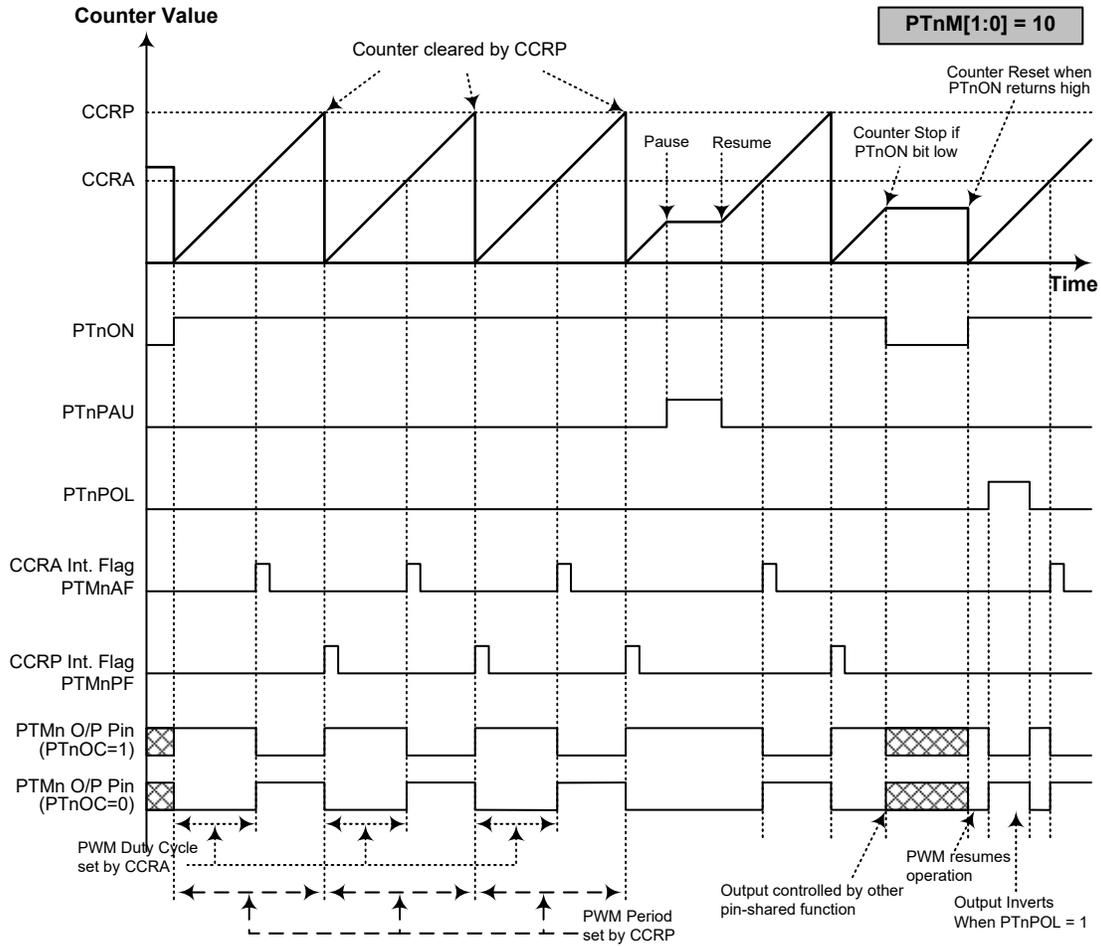
由于 PWM 波形的周期和占空比可调，其波形的选择就较为灵活。在 PWM 输出模式中，PTnCCLR 位对 PWM 周期无影响。CCRP 和 CCRA 寄存器都用于控制 PWM 方波。CCRP 寄存器通过清除内部计数从而控制 PWM 周期，CCRA 寄存器设置 PWM 的占空比。PWM 波形的周期和占空比由 CCRP 和 CCRA 寄存器的值控制。

当比较器 A 或比较器 P 比较匹配发生时，CCRA 和 CCRP 中断标志位分别产生。PTMnC1 寄存器的 PTnOC 位选择 PWM 波形的极性，PTnIO1 和 PTnIO0 位使能 PWM 输出或强制 PTMn 输出脚为高电平或低电平。PTnPOL 位用于 PWM 输出波形的极性反相控制。

● 10-bit PTMn, PWM 输出模式, 边沿对齐模式

CCRP	1~1023	0
Period	1~1023	1024
Duty	CCRA	

若 $f_{SYS}=12\text{MHz}$ ，PTMn 时钟源选择 $f_{SYS}/4$ ，CCRP=512 且 CCRA=128，
PTMn PWM 输出频率 = $(f_{SYS}/4) / 512 = f_{SYS}/2048 = 5.8594\text{kHz}$ ， $duty=128/512=25\%$ ，
若由 CCRA 寄存器定义的 Duty 值等于或大于 Period 值，PWM 输出占空比为 100%。



PWM 输出模式 (n=0 或 1)

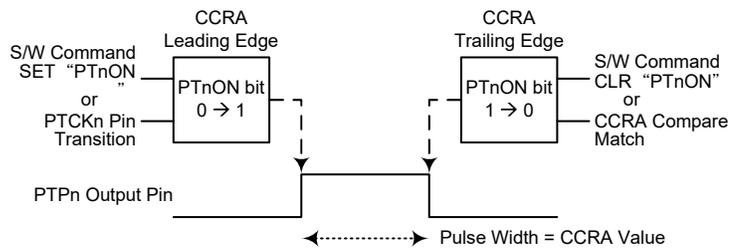
- 注：1. CCRP 清除计数器
2. 计数器清除并决定 PWM 周期
3. 当 PTnIO[1:0]=00 或 01, PWM 功能不变
4. PTnCCLR 位对 PWM 功能无影响

单脉冲输出模式

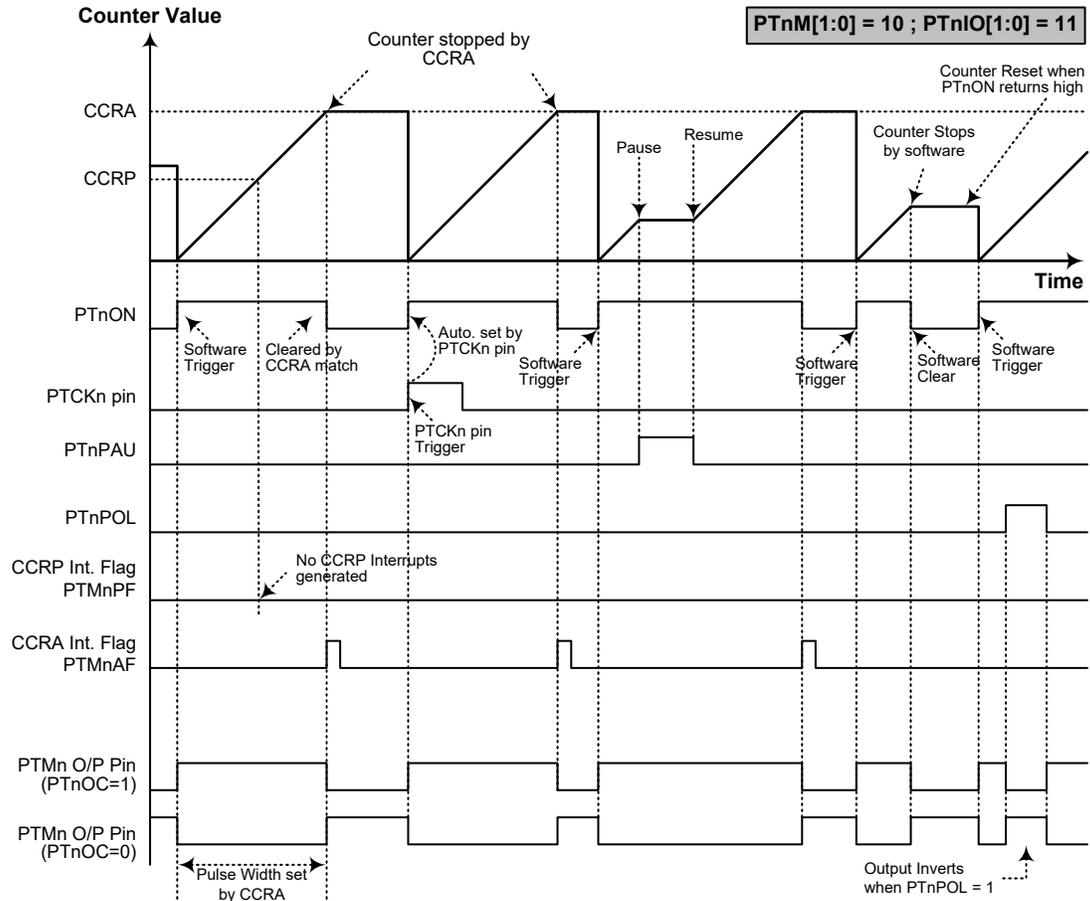
为使 PTMn 工作在此模式，PTMnC1 寄存器中的 PTnM1 和 PTnM0 位需要设置为“10”，并且相应的 PTnIO1 和 PTnIO0 需要设置为“11”。正如模式名所言，单脉冲输出模式，在 PTMn 输出脚将产生一个脉冲输出。

通过应用程序控制 PTnON 位由低到高的转变来触发脉冲前沿输出。而处于单脉冲输出模式时，PTnON 位可在 PTCKn 脚发生有效边沿跳转时自动由低转变为高，进而开始单脉冲输出。当 PTnON 位转变为高电平时，计数器将开始运行，并产生脉冲前沿。通过应用程序使 PTnON 位清零或比较器 A 比较匹配发生时，产生脉冲后沿。

而比较器 A 比较匹配发生时，会自动清除 PTnON 位并产生单脉冲输出边沿跳转。CCRA 的值通过这种方式控制脉冲宽度。比较器 A 比较匹配发生时，也会产生 PTMn 中断。PTnON 位在计数器重启时会发生由低到高的转变，此时计数器才复位至零。在单脉冲输出模式中，CCRP 寄存器和 PTnCLLR 位未使用。



单脉冲产生示意图 (n=0 或 1)



单脉冲输出模式 (n=0 或 1)

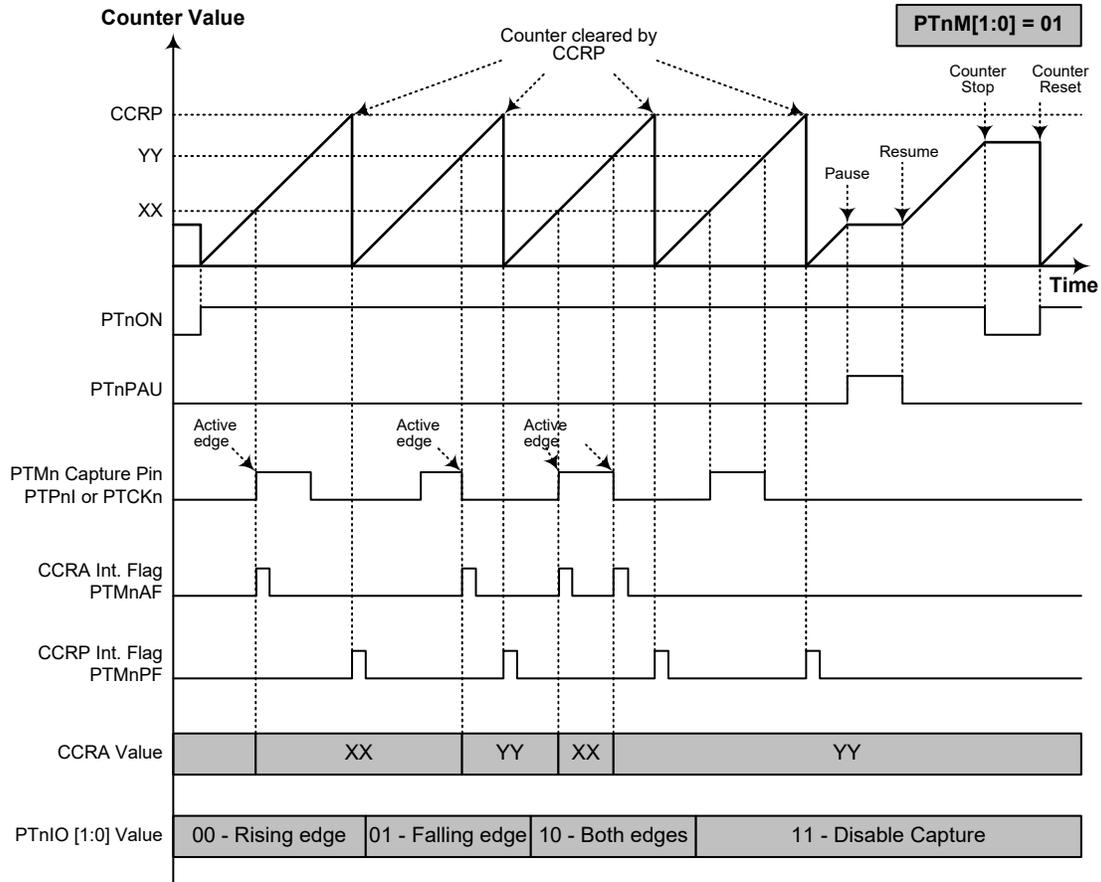
- 注：1. 通过 CCRA 匹配停止计数器
2. CCRP 未使用
3. 通过 PTCKn 脚或设置 PTnON 位为高来触发脉冲
4. PTCKn 脚有效沿会自动置位 PTnON
5. 单脉冲输出模式中，PTnIO[1:0] 需置为“11”，且不能更改。

捕捉输入模式

为使 PTMn 工作在此模式，PTMnC1 寄存器的 PTnM1 和 PTnM0 位需要设置为“01”。此模式使能外部信号捕捉并保存内部计数器当前值，因此被用于诸如脉冲宽度测量的应用中。PTPnI 或 PTCKn 引脚上的外部信号，通过设置 PTMnC1 寄存器的 PTnCAPTS 位选择。可通过设置 PTMnC1 寄存器的 PTnIO1 和 PTnIO0 位选择有效边沿类型，即上升沿，下降沿或双沿有效。通过应用程序将 PTnON 位由低到高转变时，计数器启动。

当 PTPnI 或 PTCKn 引脚出现有效边沿转换时，计数器当前值被锁存到 CCRA 寄存器，并产生 PTMn 中断。无论 PTPnI 或 PTCKn 引脚发生哪种边沿转换，计数器将继续工作直到 PTnON 位发生下降沿跳变。当 CCRP 比较匹配发生时计数器复位至零；CCRP 的值通过这种方式控制计数器的最大值。当比较器 P CCRP 比较匹配发生时，也会产生 PTMn 中断。记录 CCRP 溢出中断信号的值可以测量长脉宽。通过设置 PTnIO1 和 PTnIO0 位选择 PTPnI 或 PTCKn 引脚为上升沿，下降沿或双沿有效。如果 PTnIO1 和 PTnIO0 位都设置为高，无论 PTPnI 或 PTCKn 引脚发生哪种边沿转换都不会产生捕捉操作，但计数器仍会继续运行。

当 PTPnI 或 PTCKn 引脚与其它功能共用，PTMn 工作在输入捕捉模式时需多加注意。这是因为如果引脚被设为输出，那么该引脚上的任何电平转变都可能执行输入捕捉操作。PTnCCLR，PTnOC 和 PTnPOL 位在此模式中未使用。



捕捉输入模式 (n=0 或 1)

- 注:
1. PTnM[1:0]=01 并通过 PTnIO[1:0] 位设置有效边沿
 2. PTMn 捕捉输入脚的有效边沿将计数器的值转移到 CCRA 中
 3. PTnCCLR 位未使用
 4. 无输出功能 -PTnOC 和 PTnPOL 位未使用
 5. 计数器值由 CCRP 决定, 在 CCRP 为“0”时, 计数器计数值可达最大

A/D 转换器

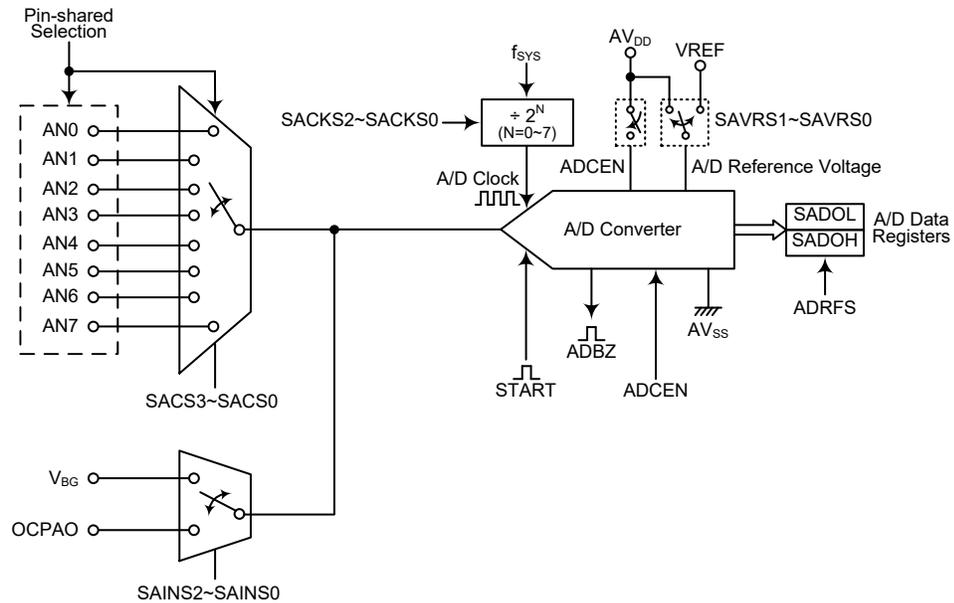
对于大多数电子系统而言，处理现实世界的模拟信号是共同的需求。为了完全由单片机来处理这些信号，首先需要通过 A/D 转换器将模拟信号转换成数字信号。将 A/D 转换器电路集成入单片机，可有效的减少外部器件，随之而来，具有降低成本和减少器件空间需求的优势。

A/D 简介

此单片机包含一个多通道的 A/D 转换器，它可以直接接入外部模拟信号（来自传感器或其它控制信号）或内部模拟信号（例如 Bandgap 参考电压 V_{BG} 和过流保护模拟输出信号 OCPAO）并直接将这此信号转换成 12 位的数字量。选择转换外部或内部模拟信号由 SAINS2~SAINS0 位和 SACS3~SACS0 位共同控制。若要转换外部模拟信号，首先应正确设置好相应的共用引脚控制位，然后再通过 SAINS2~SAINS0 位选择所需的外部输入通道。注意，若要转换内部模拟信号，除了 SAINS 和 SACS 字段外，共用引脚控制位也应正确设置。关于 A/D 输入信号的详细描述请参考“A/D 转换寄存器介绍”和“A/D 转换器输入信号”两节内容。

外部输入通道	内部信号	A/D 通道选择位
8: AN0~AN7	2: V_{BG} , OCPAO	SAINS2~SAINS0; SACS3~SACS0

下图显示了 A/D 转换器内部结构和相关的寄存器。



A/D 转换器结构

A/D 转换寄存器介绍

A/D 转换器的所有工作由一系列寄存器控制。一对只读寄存器来存放 12 位 A/D 转换数据的值。剩下两个控制寄存器 SADC0 和 SADC1 设置 A/D 转换器的操作和控制功能。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
SADOL(ADRFS=0)	D3	D2	D1	D0	—	—	—	—
SADOL(ADRFS=1)	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
SADOH(ADRFS=0)	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4
SADOH(ADRFS=1)	—	—	—	—	D11	D10	D9	D8
SADC0	START	ADBZ	ADCEN	ADRFS	SACS3	SACS2	SACS1	SACS0
SADC1	SAINS2	SAINS1	SAINS0	SAVRS1	SAVRS0	SACKS2	SACKS1	SACKS0

A/D 转换寄存器列表

A/D 转换器数据寄存器 – SADOL, SADOH

对于具有 12 位 A/D 转换器的芯片，需要两个数据寄存器存放转换结果，一个高字节寄存器 SADOH 和一个低字节寄存器 SADOL。在 A/D 转换完毕后，单片机可以直接读取这些寄存器以获得转换结果。由于寄存器只使用了 16 位中的 12 位，其数据存储格式由 SADC0 寄存器的 ADRFS 位控制，如下表所示。D0~D11 是 A/D 转换数据结果位。未使用的位读为“0”。当 A/D 转换器除能时，数据寄存器的值将保持不变。

ADRFS	SADOH								SADOL							
	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
0	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

A/D 数据寄存器

A/D 转换控制寄存器 – SADC0, SADC1

寄存器 SADC0 和 SADC1 用来控制 A/D 转换器的功能和操作。这些 8 位的寄存器定义包括选择连接至内部 A/D 转换器的模拟通道，数字化数据格式，A/D 时钟源，并控制和监视 A/D 转换器的忙碌状态。由于每个单片机只包含一个实际的模数转换电路，因此这些外部和内部模拟信号中的每一个都需要分别被发送到转换器。SADC0 寄存器中的 SACS3~SACS0 位用于选择哪个外部模拟输入通道被连接到内部 A/D 转换器。SADC1 寄存器中的 SAINS2~SAINS0 位用于选择外部模拟输入通道或内部模拟信号被连接到内部 A/D 转换器。

引脚共用功能选择寄存器的相关位用来定义 I/O 端口中的哪些引脚为 A/D 转换器的模拟输入，哪些引脚不作为 A/D 转换输入。当引脚作为 A/D 输入时，其原来的 I/O 或其它引脚共用功能消失，此外，其内部上拉电阻也将自动断开。

• SADC0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	START	ADBZ	ADCEN	ADRF5	SACS3	SACS2	SACS1	SACS0
R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 7 **START**: 启动 A/D 转换位
 0→1→0: 启动
 此位用于初始化 A/D 转换过程。通常此位为低，但如果设为高再被清零，将初始化 A/D 转换过程。当此位为高，将重置 A/D 转换器。
- Bit 6 **ADBZ**: A/D 转换忙碌标志位
 0: A/D 转换结束或未开始转换
 1: A/D 转换中
 此位用于表明 A/D 转换过程是否完成。当 START 位由低变为高再变为低时，ADBZ 位为高，表明 A/D 转换已初始化。A/D 转换结束后，此位被清零。
- Bit 5 **ADCEN**: A/D 转换器使能 / 除能控制位
 0: 除能
 1: 使能
 此位控制 A/D 内部功能。该位被置高将使能 A/D 转换器。如果该位设为低将关闭 A/D 转换器以降低功耗。当 A/D 转换器除能时，A/D 数据寄存器 SADOH 和 SADOL 的内容将保持不变。
- Bit 4 **ADRF5**: A/D 转换数据格式选择位
 0: A/D 转换数据格式 →SADOH=D[11:4]; SADOL=D[3:0]
 1: A/D 转换数据格式 →SADOH=D[11:8]; SADOL=D[7:0]
 此位控制存放在两个 A/D 数据寄存器中的 12 位 A/D 转换结果的格式。细节方面请参考 A/D 数据寄存器章节。
- Bit 3~0 **SACS3~SACS0**: A/D 外部模拟通道输入选择位
 0000: AN0
 0001: AN1
 0010: AN2
 0011: AN3
 0100: AN4
 0101: AN5
 0110: AN6
 0111: AN7
 1xxx: 无通道，输入浮空

• SADC1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	SAINS2	SAINS1	SAINS0	SAVRS1	SAVRS0	SACKS2	SACKS1	SACKS0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 7~5 **SAINS2~SAINS0**: A/D 输入信号选择位
 000: 外部信号 – 外部模拟通道输入
 001: 内部信号 – 内部 Bandgap 参考电压 V_{BG}
 010: 内部信号 – 内部 OCPAO 信号
 011~100: 保留，接地
 101~111: 外部信号 – 外部模拟通道输入
 必须注意当 SAINS2~SAINS0 位为 001~010 选择转换内部模拟信号时，外部输入通道一定不能作为 A/D 输入，SACS3~SACS0 位需正确设置为 1000~1111 中的一个值。否则，外部输入通道将与内部模拟信号相连接，这将导致不可预期的后果，甚至不可逆的损坏。

- Bit 4~3 **SAVRS1~SAVRS0**: A/D 转换器参考电压选择位
 00: VREF 引脚
 01: 内部 A/D 转换器电源 AV_{DD}
 1x: VREF 引脚

这几位用于选择 A/D 转换器的参考电压。必须注意当 SAVRS1~SAVRS0 为“01”选择内部 A/D 转换器电源作为参考电压时，需正确的设置相应的共用引脚功能控制位，不能将 VREF 引脚设置为参考电压输入。否则，VREF 引脚的外部输入电压也会连接到内部 A/D 转换器电源。

- Bit 2~0 **SACKS2~SACKS0**: A/D 时钟源选择位
 000: f_{sys}
 001: f_{sys}/2
 010: f_{sys}/4
 011: f_{sys}/8
 100: f_{sys}/16
 101: f_{sys}/32
 110: f_{sys}/64
 111: f_{sys}/128

这三位用于选择 A/D 转换器的时钟源。

A/D 操作

SADC0 寄存器中的 START 位，用于打开 A/D 转换器。当单片机设置此位从逻辑低到逻辑高，然后再到逻辑低，就会开始一个模数转换周期。

SADC0 寄存器中的 ADBZ 位用于表明模数转换过程是否正在进行。A/D 转换成功启动后，ADBZ 位会被单片机自动置为“1”。在转换周期结束后，ADBZ 位会自动置为“0”。此外，也会置位中断控制寄存器内相应的 A/D 中断请求标志位，如果中断使能，就会产生对应的内部中断信号。A/D 内部中断信号将引导程序跳转到相应的 A/D 内部中断地址。如果 A/D 内部中断被禁止，可以让单片机轮询 SADC0 寄存器中的 ADBZ 位，检查此位是否被清除，作为另一种侦测 A/D 转换周期结束的方法。

A/D 转换器的时钟源为系统时钟 f_{sys} 或其分频，而分频系数由 SADC1 寄存器中的 SACKS2~SACKS0 位决定。虽然 A/D 时钟源是由系统时钟 f_{sys} 和 SACKS2~SACKS0 位决定，但可选择的最大 A/D 时钟源则有一些限制。由于允许的 A/D 时钟周期 t_{ADCK} 的范围为 0.5μs~10μs，所以选择系统时钟速度时就必须小心。如果系统时钟速度为 8MHz 时，SACKS2~SACKS0 位不能设为“000”，“001”或“111”。必须保证设置的 A/D 转换时钟周期不小于时钟周期的最小值或大于时钟周期的最大值，否则将会产生不准确的 A/D 转换值。使用者可以参考下面的表格，被标上星号 * 的数值是不允许的，因为它们 A/D 转换时钟周期小于规定的最小值。

f _{sys}	A/D 时钟周期 (t _{ADCK})							
	SACKS[2:0] = 000 (f _{sys})	SACKS[2:0] = 001 (f _{sys} /2)	SACKS[2:0] = 010 (f _{sys} /4)	SACKS[2:0] = 011 (f _{sys} /8)	SACKS[2:0] = 100 (f _{sys} /16)	SACKS[2:0] = 101 (f _{sys} /62)	SACKS[2:0] = 110 (f _{sys} /64)	SACKS[2:0] = 111 (f _{sys} /128)
1MHz	1μs	2μs	4μs	8μs	16μs *	32μs *	64μs *	128μs *
2MHz	500ns	1μs	2μs	4μs	8μs	16μs *	32μs *	64μs *
4MHz	250ns *	500ns	1μs	2μs	4μs	8μs	16μs *	32μs *
8MHz	125ns *	250ns *	500ns	1μs	2μs	4μs	8μs	16μs *

A/D 时钟周期范例

SADC0 寄存器中的 ADCEN 位用于控制 A/D 转换电路电源的开启和关闭。该位必须置高以开启 A/D 转换器电源。当设置 ADCEN 位为高开启 A/D 转换器内部电路时，在 A/D 转换成功开启前需一段延时。即使通过相关引脚共用控制位选择无引脚作为 A/D 输入，如果 ADCEN 设为“1”，那么仍然会产生功耗。因此在功耗敏感的应用中，当未使用 A/D 转换器功能时，建议设置 ADCEN 为低以减少功耗。

A/D 转换器参考电压

A/D 转换器参考电压可以来自正电源电压引脚 AVDD 或外部参考源引脚 VREF，可通过 SAVRS1~SAVRS0 位来选择。当 SAVRS 字段为“01”时，A/D 转换器参考电压来自 AVDD 引脚。否则，当 SAVRS 字段为“01”以外任何值时，A/D 转换器参考电压来自 VREF 引脚。由于 A/D 转换器和 OCP D/A 转换器共用同一个外部参考电压引脚 VREF，当选择 VREF 作为 A/D 转换器的参考电压时，除了合理设置相关引脚共用控制位外，也应合理设置 OCP D/A 转换器参考电压选择位 OCPVRS，以避免功能异常。然而，若选择 A/D 转换器电源作为 A/D 转换器的参考电压，VREF 引脚不能配置为参考电压输入功能，以避免 VREF 引脚与 A/D 转换器电源引脚 AVDD 内部相连接。模拟输入值一定不能超过所选的参考电压 AV_{DD} 或 V_{REF} 值。

如何正确选择 A/D 转换器或 OCP D/A 转换器的参考电压，如下表所示。

A/D 转换器参考电压选择	OCP D/A 转换器参考电压选择	SAVRS[1:0]	OCPVRS	PAS07~PAS06
AVDD	AVDD	01	0	除“10”外其它值
AVDD	VREF	01	1	01
VREF	AVDD	除“01”外其它值	0	10
VREF	VREF	除“01”外其它值	1	10

A/D 转换器输入信号

所有的 A/D 外部模拟输入引脚都与 I/O 口及其它功能共用。使用 PAS0 和 PAS1 寄存器中的相应位，可以将它们设置为 A/D 转换器模拟输入脚或其它共用功能。如果对应的引脚作为 A/D 转换输入，那么它原来的引脚功能将除能。通过这种方式，引脚的功能可由程序来控制，灵活地切换引脚功能。如果将引脚设为 A/D 输入，则通过寄存器编程设置的所有上拉电阻会自动断开。请注意，端口控制寄存器不需要为使能 A/D 输入而先设定为输入模式，当 A/D 输入功能选择位使能 A/D 输入时，端口控制寄存器的状态将被重置。

A/D 转换器还有两个内部模拟信号，来自 Bandgap 参考电压或过流保护输出信号，可通过设置 SAINS2~SAINS0 位将其连接到 A/D 转换器作为模拟输入信号。如果选择外部输入通道，SAINS2~SAINS0 位应设为“000”，具体外部通道编号由 SACS3~SACS0 位决定。如果选择内部模拟信号，那么必须适当地设置 SACS3~SACS0 位为 1000~1111 中的一个值，将外部输入通道切换到无 A/D 输入通道状态。否则，外部输入通道将与内部模拟信号相连接，这将导致不可预期的后果。

SAINS[2:0]	SACS[3:0]	输入信号	描述
000, 101~111	0000~0111	AN0~AN7	外部模拟通道输入
	1000~1111	—	无通道, 输入浮空
001	1000~1111	V _{BG}	内部 Bandgap 参考电压
010	1000~1111	OCPAO	内部过流保护模拟输出信号
011, 100	1000~1111	—	保留, 连接到地

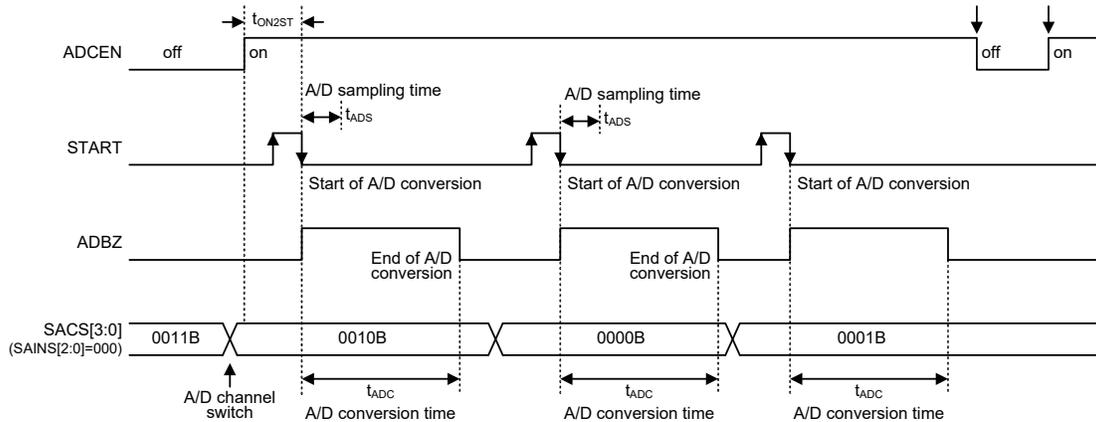
A/D 转换器输入信号选择

A/D 转换率及时序图

一个完整的 A/D 转换包含两部分, 数据采样和数据转换。数据采样时间定义为 t_{ADS} , 需要 4 个 A/D 时钟周期, 而数据转换需要 12 个 A/D 时钟周期。所以一个完整的 A/D 转换时间 t_{ADC} , 一共需要 16 个 A/D 时钟周期。

$$\text{最大 A/D 转换率} = \text{A/D 时钟周期} \div 16$$

下列时序图表示模数转换过程中不同阶段的图形与时序。由应用程序控制开始 A/D 转换过程后, 单片机的内部硬件就会开始进行转换, 在这个过程中, 程序可以继续其它功能。A/D 转换时间为 $16t_{ADCK}$, t_{ADCK} 为 A/D 时钟周期。



A/D 转换时序图 - 外部通道输入

A/D 转换步骤

下面概述实现 A/D 转换过程的各个步骤。

- 步骤 1
通过 SADC1 寄存器中的 SACKS2~SACKS0 位, 选择所需的 A/D 转换时钟。
- 步骤 2
将 SADC0 寄存器中的 ADCEN 位置高使能 A/D 转换器。
- 步骤 3
通过 SADC1 寄存器中的 SAINS2~SAINS0 位, 选择连接至内部 A/D 转换器的信号。
若选择外部通道输入, 接着执行步骤 4。
若选择内部模拟信号, 接着执行步骤 5。

- 步骤 4
若已通过 SAINS2~SAINS0 位选择 A/D 输入信号来自外部通道输入，接着应设置相关的引脚共用控制位将该引脚规划为 A/D 输入引脚。通过设置 SACS3~SACS0 位选择哪个外部通道接至 A/D 转换器。接着执行步骤 6。
- 步骤 5
在 SAINS2~SAINS0 位选择 A/D 输入信号来自内部模拟信号之前，需设置 SACS3~SACS0 为 1000~1111 中的一个值，将外部通道输入切换到无通道输入，然后再通过 SAINS2~SAINS0 位选择内部模拟信号。接着执行步骤 6。
- 步骤 6
通过 SADC1 寄存器中的 SAVRS1~SAVRS0 位选择参考电压。
- 步骤 7
设置 SADC0 寄存器中的 ADRFS 位选择 A/D 转换器输出数据格式。
- 步骤 8
如果要使用中断，则中断控制寄存器需要正确地设置，以确保 A/D 中断功能是激活的。总中断控制位 EMI 需要置位为“1”，以及 A/D 转换器中断位 ADE 也需要置位为“1”。
- 步骤 9
现在可以通过设置 SADC0 寄存器中的 START 位从“0”到“1”再回到“0”，开始模数转换的过程。
- 步骤 10
如果 A/D 转换正在进行中，ADBZ 位会被置为逻辑高。A/D 转换完成后，ADBZ 位会被置为逻辑低，并可从 SADOH 和 SADOL 寄存器中读取输出数据。
注：若使用轮询 SADC0 寄存器中 ADBZ 位的状态的方法来检查转换过程是否结束时，则中断使能的步骤可以省略。

编程注意事项

在编程时，如果 A/D 转换器未使用，通过设置 SADC0 寄存器中的 ADCEN 为低，关闭 A/D 内部电路以减少电源功耗。此时，不考虑输入脚的模拟电压，内部 A/D 转换器电路不产生功耗。如果 A/D 转换器输入脚用作普通 I/O 脚，必须特别注意，输入电压为无效逻辑电平也可能增加功耗。

A/D 转换功能

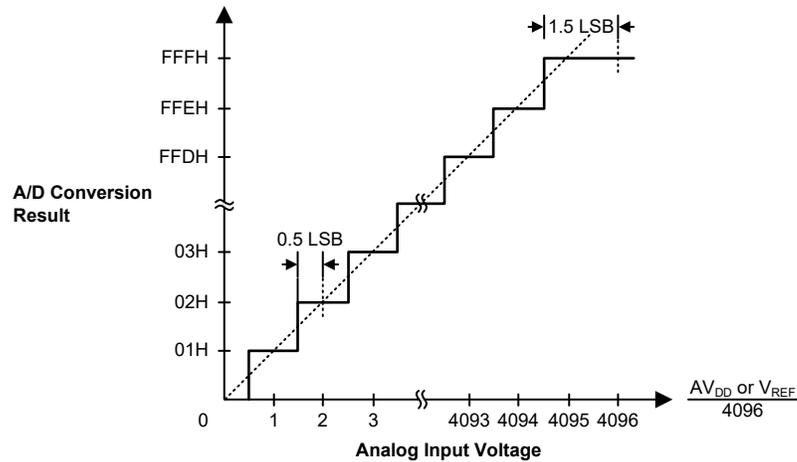
单片机含有一组 12 位的 A/D 转换器，它们转换的最大值可达 FFFH。由于模拟输入最大值等于 AV_{DD} 或 V_{REF} 的电压值，因此每一位可表示 $(AV_{DD}$ 或 $V_{REF})/4096$ 的模拟输入值。

$$1 \text{ LSB} = (AV_{DD} \text{ 或 } V_{REF}) \div 4096$$

通过下面的等式可估算 A/D 转换器输入电压值：

$$\text{A/D 输入电压} = \text{A/D 数字输出值} \times (AV_{DD} \text{ 或 } V_{REF}) \div 4096$$

下图显示 A/D 转换器模拟输入值和数字输出值之间理想的转换功能。除了数字化数值 0，其后的数字化数值会在精确点之前的 0.5 LSB 处改变，而数字化数值的最大值将在 AV_{DD} 或 V_{REF} 之前的 1.5 LSB 处改变。



理想的 A/D 转换功能

A/D 转换应用范例

下面两个范例程序用来说明怎样使用 A/D 转换。第一个范例是轮询 SADC0 寄存器中的 ADBZ 位来判断 A/D 转换是否完成；第二个范例则使用中断的方式判断。

范例 1: 使用查询 ADBZ 的方式来检测转换结束

```

clr ADE                ; disable ADC interrupt
mov a,03H
mov SADC1,a            ; select fsys/8 as A/D clock
set ADCEN
mov a,03h              ; setup PAS0 to configure pin AN0
mov PAS0,a
mov a,20h
mov SADC0,a           ; enable and connect AN0 channel to A/D converter
:
start_conversion:
clr START              ; high pulse on start bit to initiate conversion
set START              ; reset A/D
clr START              ; start A/D
polling_EOC:
sz ADBZ                ; poll the SADC0 register ADBZ bit to detect end
                    ; of A/D conversion
jmp polling_EOC       ; continue polling
mov a,SADOL            ; read low byte conversion result value
mov SADOL_buffer,a    ; save result to user defined register
mov a,SADOH            ; read high byte conversion result value
mov SADOH_buffer,a   ; save result to user defined register
:
:
jmp start_conversion  ; start next A/D conversion
    
```

范例 2：使用中断的方式来检测转换结束

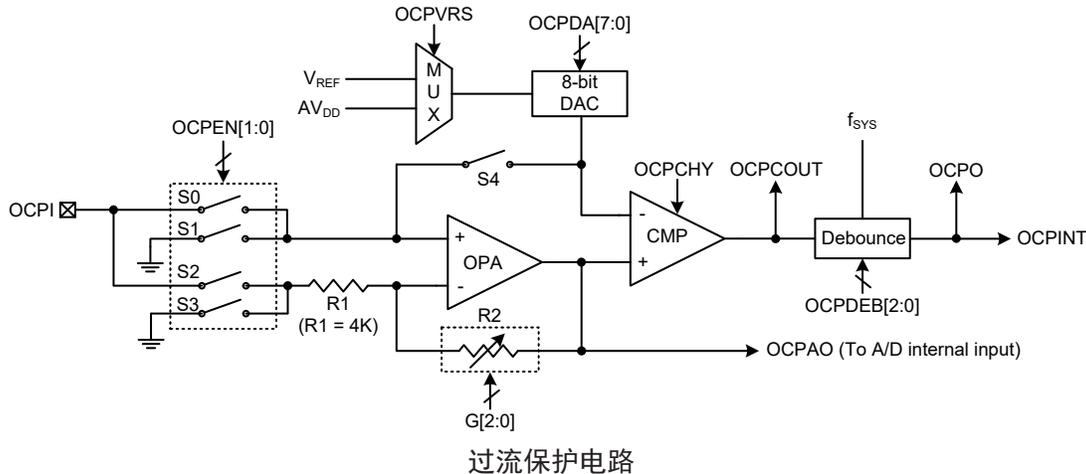
```

clr ADE                ; disable ADC interrupt
mov a,03H
mov SADC1,a           ; select fsys/8 as A/D clock
set ADCEN
mov a,03h             ; setup PAS0 to configure pin AN0
mov PAS0,a
mov a,20h
mov SADC0,a           ; enable and connect AN0 channel to A/D converter
Start_conversion:
clr START             ; high pulse on START bit to initiate conversion
set START             ; reset A/D
clr START             ; start A/D
clr ADF               ; clear ADC interrupt request flag
set ADE               ; enable ADC interrupt
set EMI               ; enable global interrupt
:
:
                        ; ADC interrupt service routine
ADC_ISR:
mov acc_stack,a       ; save ACC to user defined memory
mov a,STATUS
mov status_stack,a   ; save STATUS to user defined memory
:
:
mov a,SADOL           ; read low byte conversion result value
mov SADOL_buffer,a   ; save result to user defined register
mov a,SADOH           ; read high byte conversion result value
mov SADOH_buffer,a   ; save result to user defined register
:
:
EXIT_INT_ISR:
mov a,status_stack
mov STATUS,a         ; restore STATUS from user defined memory
mov a,acc_stack      ; restore ACC from user defined memory
reti

```

过流保护功能 – OCP

该单片机内建过流保护功能，为应用提供了一个过电流保护机制。为了防止电池过充或负载电流超过特定值，根据 OCP 运算放大器的电流值将 OCP 引脚上的电流转换为相应的电压，然后与 8 位 D/A 转换器产生的参考电压进行比较。当过流情况发生时，如果相应的中断控制位使能，将产生一个 OCP 中断。



过流保护电路操作

OCP 电路是用来防止输入电流超过参考电流。将 OCP 引脚上的电流转换为电压，然后经 OCP 运算放大器放大，该运算放大器具有一个 1~50 的可编程增益，可通过 OCPC1 寄存器的 G2~G0 位选择，因此被称为可编程增益放大器或 PGA。通过设置 OCPC0 寄存器的 OCPEN1 和 OCPEN0 位，PGA 还可以选择工作在正相、反相或输入失调校准模式。电流经过转换并放大为某一特定的电压值后，将与 8 位 D/A 转换器提供的参考电压进行比较。8 位 D/A 转换器的电源可通过 OCPC0 寄存器的 OCPVRS 位选择由 AV_{DD} 或 V_{REF} 提供。比较器输出 OCPCOUT 要先滤波，可通过 OCPC1 寄存器的 OCPDEB2~OCPDEB0 位设置去抖时间周期。然后根据滤波后的 OCP 比较器数字输出 OCPO 判断过流情况是否发生。如果过流情况发生，OCPO 为 1，否则为 0。一旦过流情况发生，即 OCP 输入电流所转换的电压大于参考电压，如果相关的中断控制位使能，则会产生相应的中断。

过流保护控制寄存器

过流保护的所有工作由多个寄存器控制。其中一个寄存器用来提供过流保护电路的参考电压。有两个寄存器用来控制运算放大器和比较器的输入失调校准功能。剩下的两个控制寄存器用来控制 OCP 功能、D/A 转换器参考电压选择、PGA 增益选择、比较器去抖时间和迟滞功能。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
OCPC0	OCPEN1	OCPEN0	OCPVRS	OCPCHY	—	—	—	OCPO
OCPC1	—	—	G2	G1	G0	OCPDEB2	OCPDEB1	OCPDEB0
OCPDA	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
OCPOCAL	OCPOOFM	OCPORSP	OCPOOF5	OCPOOF4	OCPOOF3	OCPOOF2	OCPOOF1	OCPOOF0
OCPCCAL	OCPCOUT	OCPCOFM	OCPCRSF	OCPCOF4	OCPCOF3	OCPCOF2	OCPCOF1	OCPCOF0

过流保护寄存器列表

OCPC0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	OCPEN1	OCPEN0	OCPVRS	OCPCHY	—	—	—	OCPO
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	—	—	—	R
POR	0	0	0	0	—	—	—	0

Bit 7~6 **OCPEN1~OCPEN0**: OCP 功能工作模式选择位

- 00: 除能, S1 和 S3 on, S0 和 S2 off
- 01: 同相模式, S0 和 S3 on, S1 和 S2 off
- 10: 反相模式, S1 和 S2 on, S0 和 S3 off
- 11: 校准模式, S1 和 S3 on, S0 和 S2 off

Bit 5 **OCPVRS**: OCP D/A 转换器参考电压选择

- 0: 来自 AV_{DD}
- 1: 来自 V_{REF}

Bit 4 **OCPCHY**: OCP 比较器迟滞功能控制

- 0: 除能
- 1: 使能

Bit 3~1 未定义, 读为“0”

Bit 0 **OCPO**: OCP 电路数字输出位

- 0: 无过电流发生
- 1: 发生过电流

OCPC1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	G2	G1	G0	OCPDEB2	OCPDEB1	OCPDEB0
R/W	—	—	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	—	—	0	0	0	0	0	0

Bit 7~6 未定义, 读为“0”

Bit 5~3 **G2~G0**: PGA R2/R1 比值选择位

- 000: 单位增益缓冲器功能 (同相模式) 或 R2/R1=1 (反相模式)
- 001: R2/R1=5
- 010: R2/R1=10
- 011: R2/R1=15
- 100: R2/R1=20
- 101: R2/R1=30
- 110: R2/R1=40
- 111: R2/R1=50

这些位用于选择 R2/R1 比值, 从而获得各种增益用于反相和同相模式。反相和同相模式下的 PGA 增益的计算公式会在“输入电压范围”章节中描述。

- Bit 2~0 **OCPDEB2~OCPDEB0**: OCP 输出滤波器去抖时间选择位
 000: 旁路, 无去抖
 001: $(1\sim 2)\times t_{DEB}$
 010: $(3\sim 4)\times t_{DEB}$
 011: $(7\sim 8)\times t_{DEB}$
 100: $(15\sim 16)\times t_{DEB}$
 101: $(31\sim 32)\times t_{DEB}$
 110: $(63\sim 64)\times t_{DEB}$
 111: $(127\sim 128)\times t_{DEB}$
 注: $t_{DEB} = 1/f_{SYS}$

OCPDA 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 7~0 **D7~D0**: OCP D/A 转换器输出电压控制位
 D/A 转换器输出电压 = (D/A 转换器参考电压 / 256) × D[7:0]

OCPOCAL 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	OCPOOFM	OCPORSP	OCPOOF5	OCPOOF4	OCPOOF3	OCPOOF2	OCPOOF1	OCPOOF0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	1	0	0	0	0	0

- Bit 7 **OCPOOFM**: OCP 运算放大器输入失调电压校准模式使能控制位
 0: 输入失调电压校准模式除能
 1: 输入失调电压校准模式使能
 此位用来控制 OCP 运算放大器的输入失调校准功能。首先将 OCPEN1 和 OCPEN0 位设为“11”，接着设置 OCPCOFM 位为 0，然后再将 OCPOOFM 位设为 1，那么运算放大器的输入失调校准模式将会使能。失调校准步骤的详细描述，请参考“运算放大器输入失调校准”章节。
- Bit 6 **OCPORSP**: OCP 运算放大器输入失调电压校准参考选择位
 0: 选择负输入端作为参考输入
 1: 选择正输入端作为参考输入
- Bit 5~0 **OCPOOF5~OCPOOF0**: OCP 运算放大器输入失调电压校准控制位
 这 6 位用来执行运算放大器的输入失调校准操作，并重新储存 OCP 运算放大器的输入失调校准值。更多详细资料请参考“运算放大器输入失调校准”章节。

OCPCCAL 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	OCPCOUT	OCPCOFM	OCPCRSP	OCPCOF4	OCPCOF3	OCPCOF2	OCPCOF1	OCPCOF0
R/W	R	R/W						
POR	0	0	0	1	0	0	0	0

- Bit 7 **OCPCOUT**: OCP 比较器输出位, 正逻辑 (只读)
 0: 正相输入电压 < 反相输入电压
 1: 正相输入电压 > 反相输入电压
 此位用来表明 OCP 工作在输入失调校准模式时正相输入电压是否大于反相输入电压。如果 OCPCOUT 为 1, 正相输入电压大于负输入电压。否则, 正相输入电压小于反相输入电压。

- Bit 6 **OCPCOFM:** OCP 比较器输入失调电压校准模式使能控制位
 0: 输入失调电压校准模式除能
 1: 输入失调电压校准模式使能
 此位用来控制 OCP 比较器的输入失调校准功能。首先将 OCPEN1 和 OCPEN0 位设为“11”，接着设置 OCPOOFM 位为 0，然后再将 OCPCOFM 位设为 1，那么比较器的输入失调校准模式将会使能。失调校准步骤的详细描述，请参考“比较器输入失调校准”章节。
- Bit 5 **OCPCRSF:** OCP 比较器输入失调电压校准参考选择位
 0: 选择负输入端作为参考输入
 1: 选择正输入端作为参考输入
- Bit 4~0 **OCPCOF4-OCPCOF0:** OCP 比较器输入失调电压校准控制位
 这 5 位用来执行比较器的输入失调校准操作，并重新储存 OCP 比较器的输入失调校准值。更多详细资料请参考“比较器输入失调校准”章节。

输入电压范围

在不同的 PGA 工作模式下，OCP 引脚可以输入正电压或负电压，以提供给各式的应用。对于正输入电压或负输入电压，需要使用不同的公式来计算 PGA 的输出，如下所述。

- 对于输入电压 $V_{IN} > 0$ ，PGA 工作在同相模式，PGA 的输出通过下面的公式得到：

$$V_{OUT} = (1+R2/R1) \times V_{IN}$$

- 当设置 OCPEN[1:0] 为“01”使 PGA 工作在同相模式，设置 G[2:0] 为“000”选择单位增益时，PGA 将作为单位增益缓冲器，其输出等于 V_{IN} 。

$$V_{OUT} = V_{IN}$$

- 对于输入电压 $0 > V_{IN} > -0.4$ ，PGA 工作在反相模式，PGA 的输出通过下面的公式得到。注意，如果输入电压为负，那它不可低于 -0.4V，否则将导致漏电。

$$V_{OUT} = (-R2/R1) \times V_{IN}$$

输入失调校准

过流保护电路有四种工作模式，通过 OCPEN[1:0] 位进行选择。其中之一为校准模式。在此模式可以对运算放大器和比较器进行失调电压校准。

运算放大器输入失调校准

步骤 1. 设置 OCPEN[1:0] = 11，OCPOOFM=1，OCPCOFM=0，OCP 将工作在运算放大器输入失调校准模式。

步骤 2. 设置 OCPOOF[5:0] = 000000，读 OCPCOUT 位的值。

步骤 3. 将 OCPOOF[5:0] 的值加 1，再读 OCPCOUT 位的值。

如果 OCPCOUT 位的状态未改变，重复步骤 3 直到 OCPCOUT 位改变。

如果 OCPCOUT 位的状态改变，记录下 OCPOOF[5:0] 的值为 V_{OOS1} ，然后转到步骤 4。

步骤 4. 设置 OCPOOF[5:0] = 111111，读 OCPCOUT 位的值。

步骤 5. 将 OCPOOF[5:0] 的值减 1，再读 OCPCOUT 位的值。

如果 OCPCOUT 位的状态未改变，重复步骤 5 直到 OCPCOUT 位改变。

如果 OCPCOUT 位的状态改变，记录下 OCPOOF[5:0] 的值为 V_{OOS2} ，然后转到步骤 6。

步骤 6. 将运算放大器的输入失调校准值 V_{OOS} 重新储存到 OCPOOF[5:0] 位，这样失调校准就完成了。

$$\text{其中, } V_{OOS} = (V_{OOS1} + V_{OOS2}) / 2$$

比较器输入失调校准

步骤 1. 设置 OCPEN[1:0] = 11，OCPCOFM=1，OCPOOFM=0，OCP 将工作在比较器输入失调校准模式。

步骤 2. 设置 OCPCOF[4:0] = 00000，读 OCPCOUT 位的值。

步骤 3. 将 OCPCOF[4:0] 的值加 1，再读 OCPCOUT 位的值。

如果 OCPCOUT 位的状态未改变，重复步骤 3 直到 OCPCOUT 位改变。

如果 OCPCOUT 位的状态改变，记录下 OCPCOF[4:0] 的值为 V_{COS1} ，然后转到步骤 4。

步骤 4. 设置 OCPCOF[4:0] = 11111，读 OCPCOUT 位的值。

步骤 5. 将 OCPCOF[4:0] 的值减 1，再读 OCPCOUT 位的值。

如果 OCPCOUT 位的状态未改变，重复步骤 5 直到 OCPCOUT 位改变。

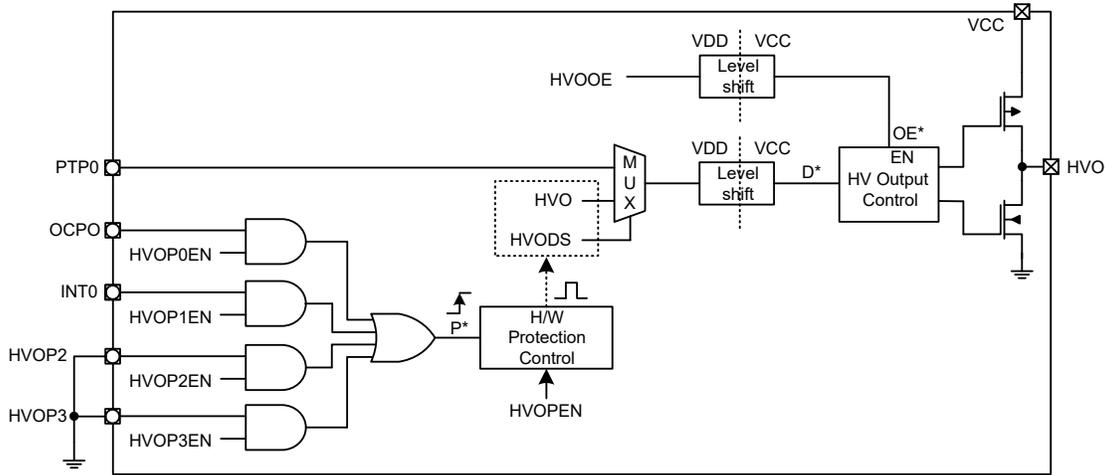
如果 OCPCOUT 位的状态改变，记录下 OCPCOF[4:0] 的值为 V_{COS2} ，然后转到步骤 6。

步骤 6. 将比较器的输入失调校准值 V_{COS} 重新储存到 OCPCOF[4:0] 位，这样失调校准就完成了。

$$\text{其中, } V_{COS} = (V_{COS1} + V_{COS2}) / 2$$

高压输出

该单片机包含一个带 Level Shift 功能的高压驱动器，可以用来驱动外部功率 MOS。



- 注: 1. “*” 是电路节点名称, 非特殊功能寄存器位名
2. PTP0 为控制信号输出高 / 低 (D) 来源

高压输出方框图

功能描述

HVO 引脚的高压输出信号用于驱动外部功率 MOS，通过 HVO 位高 / 低控制或 PTP0 输出能对功率 MOS 控制负载进行控制，控制方式由 HVODS 位选择。

保护机制

以下是为高压输出提供的保护机制。

- 若 HVOPEN=0，则由 HVOOE 位决定 HVO 引脚是否为浮空或由上述方式控制的正常输出。
- 若 HVOPEN=1，当控制信号 P 由低到高的触发发生时，HVO 和 HVODS 位将被硬件强迫清零，目的为：
 - ◆ 当 OE=1 时 HVO 引脚输出低电平。
 - ◆ 当 OE=0 时 HVO 引脚输出浮空，此时 OE 的值由 HVOOE 位决定。
 - ◆ 之后由软件决定 HVOC 寄存器的动作。
- 若 HVOPEN=1，但控制信号 P 触发没发生，HVO 和 HVODS 位不受影响。

控制寄存器

高压输出的所有操作由两个寄存器控制。

HVOC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	HVOPEN	HVOOE	HVODS	HVO
R/W	—	—	—	—	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	0	0	0	0

Bit 7~4 未定义，读为“0”

Bit 3 **HVOPEN**: HVO 引脚硬件保护使能控制位

0: 除能
1: 使能

Bit 2 **HVOOE**: HVO 引脚输出使能控制位

0: 输出除能
1: 输出使能

Bit 1 **HVODS**: HVO 引脚输出数据选择位

0: 由 HVO 位决定输出
1: 由 PTP0 决定输出

Bit 0 **HVO**: HVO 引脚输出控制位

0: 输出低
1: 输出高

注：因为 HVOOE 和 HVO 位在同一个寄存器中，HVOC 寄存器设置好后，为了避免 HVO 引脚输出使能信号和数据信号太近的问题，硬件会在两个信号之间提供一个系统时钟 f_{sys} 延迟。

HVOPC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	HVOP3EN	HVOP2EN	HVOPIEN	HVOP0EN
R/W	—	—	—	—	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	0	0	0	0

Bit 7~4 未定义，读为“0”

Bit 3 **HVOP3EN**: HVOP3 硬件保护控制位

0: 除能
1: 使能

Bit 2 **HVOP2EN**: HVOP2 硬件保护控制位

0: 除能
1: 使能

Bit 1 **HVOPIEN**: INT0 硬件保护控制位

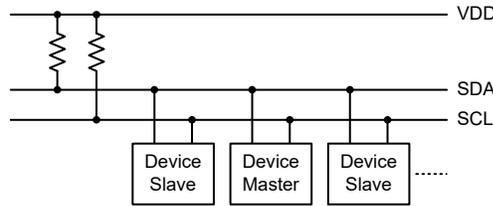
0: 除能
1: 使能

Bit 0 **HVOP0EN**: OCPO 硬件保护控制位

0: 除能
1: 使能

I²C 接口

I²C 可以和传感器，EEPROM 内存等外部硬件接口进行通信。最初是由飞利浦公司研制，是适用于同步串行数据传输的双线式低速串行接口。I²C 接口具有两线通信，非常简单的通信协议和在同一总线上和多个设备进行通信的能力的优点，使之在很多的应用场合中大受欢迎。

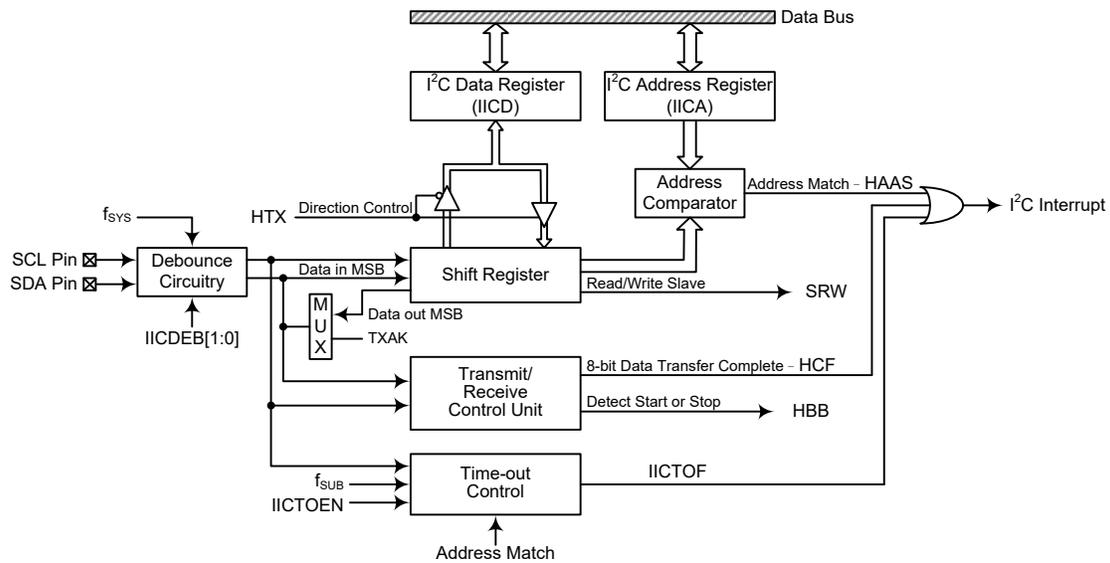


I²C 主从总线连接图

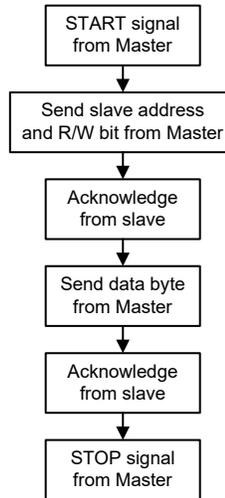
I²C 接口操作

I²C 串行接口是一个双线的接口，有一条串行数据线 SDA 和一条串行时钟线 SCL。由于可能有多个设备在同一条总线上相互连接，所以这些设备的输出都是开漏型输出。因此应在这些输出上都应加上拉电阻。应注意的是，I²C 总线上的每个设备都没有选择线，但分别与唯一的地址一一对应，用于 I²C 通信。

如果有两个设备通过双向的 I²C 总线进行通信，那么就存在一个主机和一个从机。主机和从机都可以用于发送和接收数据，但只有主机才可以控制总线动作。那些处于从机模式的设备，要在 I²C 总线上传输数据只有两种方式，一是从机发送模式，二是从机接收模式。



I²C 方框图



IICDEB1 和 IICDEB0 位决定 I²C 接口的去抖时间。这个功能可以使用内部时钟在外部时钟上增加一个去抖间隔，会减小时钟线上毛刺发生的可能性，以避免单片机发生误动作。如果选择了这个功能，去抖时间可以选择 2 个或 4 个系统时钟。为了达到需要的 I²C 数据传输速度，系统时钟 f_{SYS} 和 I²C 去抖时间之间存在一定的关系。I²C 标准模式或者快速模式下，用户需注意所选的系统时钟频率与标准匹配去抖时间的设置，其具体关系如下表所示。

I ² C 去抖时间选择	I ² C 标准模式 (100kHz)	I ² C 快速模式 (400kHz)
无去抖时间	$f_{SYS} > 2 \text{ MHz}$	$f_{SYS} > 5 \text{ MHz}$
2 个系统时钟去抖时间	$f_{SYS} > 4 \text{ MHz}$	$f_{SYS} > 10 \text{ MHz}$
4 个系统时钟去抖时间	$f_{SYS} > 8 \text{ MHz}$	$f_{SYS} > 20 \text{ MHz}$

I²C 最小 f_{SYS} 频率

I²C 寄存器

I²C 总线有三个控制寄存器 IICC0、IICC1 和 IICTOC，一个从机地址寄存器 IICA 及一个数据寄存器 IICD。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
IICC0	—	—	—	—	IICDEB1	IICDEB0	IICEN	—
IICC1	HCF	HAAS	HBB	HTX	TXAK	SRW	IAMWU	RXAK
IICD	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
IICA	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	—
IICTOC	IICTOEN	IICTOF	IICTOS5	IICTOS4	IICTOS3	IICTOS2	IICTOS1	IICTOS0

I²C 寄存器列表

● **IICD 寄存器**

IICD 用于存储发送和接收的数据。在单片机尚未将数据写入到 I²C 总线中时，要传输的数据应存在 IICD 中。I²C 总线接收到数据之后，单片机就可以从 IICD 数据寄存器中读取。所有通过 I²C 传输或接收的数据都必须通过 IICD 实现。

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	x	x	x	x	x	x	x	x

“x” 为未知

Bit 7~0 **D7~D0**: I²C 数据缓存位 bit 7~bit 0

IICA 寄存器

IICA 寄存器用于存放 7 位从机地址，寄存器 IICA 中的第 7~1 位是单片机的从机地址，位 0 未定义。如果接至 I²C 的主机发送处的地址和寄存器 IICA 中存储的地址相符，那么就选中了这个从机。

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	—
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	—
POR	0	0	0	0	0	0	0	—

Bit 7~1 **A6~A0**: I²C 从机地址位
A6~A0 是从机地址对应的 bit 6 ~ bit 0。

Bit 0 未定义，读为 “0”

I²C 控制寄存器

单片机中有两个控制 I²C 接口功能的寄存器，IICC0 和 IICC1。寄存器 IICC0 用于控制使能 / 除能功能和设置数据传输的时钟频率。寄存器 IICC1 包括多个用于表明 I²C 传输状态的相关标志位。另一个寄存器 IICTOC 用于控制 I²C 超时功能，将在相应章节描述。

● **IICC0 寄存器**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	IICDEB1	IICDEB0	IICEN	—
R/W	—	—	—	—	R/W	R/W	R/W	—
POR	—	—	—	—	0	0	0	—

Bit 7~4 未定义，读为 “0”

Bit 3~2 **IICDEB1~IICDEB0**: I²C 去抖时间选择位
00: 无去抖时间
01: 2 个系统时钟去抖时间
10: 4 个系统时钟去抖时间
11: 4 个系统时钟去抖时间

Bit 1 **IICEN**: I²C 控制位
0: 除能
1: 使能

此位为 I²C 接口的开 / 关控制位。此位为 “0” 时，I²C 接口除能，SDA 和 SCL 脚将失去 I²C 功能，I²C 工作电流减小到最小值。此位为 “1” 时，I²C 接口使能。当 IICEN 位由低到高转变时，I²C 控制寄存器中的设置，如 HXT 和 TXAK，将不会发生变化，其首先应在应用程序中初始化，此时相关 I²C 标志，如 HCF、

HAAS、HBB、SRW 和 RXAK，将被设置为其默认状态。

Bit 0 未定义，读为“0”

● IICC1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	HCF	HAAS	HBB	HTX	TXAK	SRW	IAMWU	RXAK
R/W	R	R	R	R/W	R/W	R	R/W	R
POR	1	0	0	0	0	0	0	1

- Bit 7 **HCF**: I²C 总线数据传输结束标志位
 0: 数据正在被传输
 1: 8 位数据传输完成
 数据正在传输时该位为低。当 8 位数据传输完成时，此位为高并产生一个中断。以下是一个两字节 I²C 数据传输的示例流程：
 1. I²C 从机接收到一个 I²C 主机发送的 START 信号，HCF 位自动清零；
 2. I²C 从机第一个数据字节接收完成，HCF 位自动置“1”；
 3. 用户通过软件从 IICC1 寄存器中读取第一个数据字节，HCF 位自动清零；
 4. I²C 从机第二个数据字节接收完成，HCF 位自动置“1”；
 5. I²C 从机接收到 I²C 主机发出的 STOP 信号，HCF 位自动置“1”。
- Bit 6 **HAAS**: I²C 地址匹配标志位
 0: 地址不匹配
 1: 地址匹配
 此标志位用于决定从机地址是否与主机发送地址相同。若地址匹配此位为高，否则此位为低。
- Bit 5 **HBB**: I²C 总线忙标志位
 0: I²C 总线闲
 1: I²C 总线忙
 当检测到 START 信号时 I²C 忙，此位变为高电平。当检测到 STOP 信号时 I²C 总线停止，该位变为低电平。
- Bit 4 **HTX**: 从机处于发送或接收模式标志位
 0: 从机处于接收模式
 1: 从机处于发送模式
- Bit 3 **TXAK**: I²C 总线发送确认标志位
 0: 从机发送确认标志
 1: 从机没有发送确认标志
 单片机接收 8 位数据之后会将该位在第九个时钟传到总线上。如果单片机想要接收更多的数据，则应在接收数据之前将此位设置为“0”。
- Bit 2 **SRW**: I²C 从机读 / 写位
 0: 从机应处于接收模式
 1: 从机应处于发送模式
 SRW 位是从机读写位。决定主机是否希望传输或接收来自 I²C 总线的的数据。当传输地址和从机的地址相同时，HAAS 位会被设置为高，主机将检测 SRW 位来决定进入发送模式还是接收模式。如果 SRW 位为高时，主机会请求从总线上读数据，此时设备处于传输模式。当 SRW 位为“0”时，主机往总线上写数据，设备处于接收模式以读取该数据。
- Bit 1 **IAMWU**: I²C 地址匹配唤醒控制位
 0: 除能
 1: 使能
 此位应设置为“1”使能 I²C 地址匹配以使系统从休眠模式中唤醒。若进入休眠模式前 IAMWU 已经置高以使能 I²C 地址匹配唤醒功能，在系统唤醒后须软件清除此位以确保单片机正确地运行。

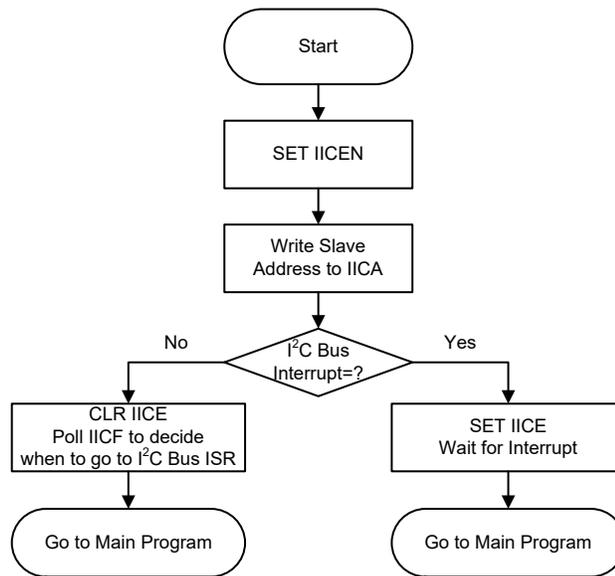
Bit 0 **RXAK:** I²C 总线接收确认标志位
 0: 从机接收到确认标志
 1: 从机没有接收到确认标志

RXAK 位是接收确认标志位。如果 RXAK 位被重设为“0”即 8 位数据传输之后，设备在第九个时钟有接受到一个正确的确认位。如果单片机处于发送状态，发送方会检查 RXAK 位来判断接收方是否愿意继续接收下一个字节。因此直到 RXAK 为“1”时，传输方停止发送数据。这时，传输方将释放 SDA 线，主机发出停止信号。

I²C 总线通信

I²C 总线上的通信需要四步完成，一个起始信号，一个从机地址发送，一个数据传输，还有一个停止信号。当起始信号被写入 I²C 总线时，总线上的所有从机都会接收到这个起始信号并且被通知总线上会有数据到达。数据的前 7 位是从机地址，高位在前，低位在后。如果发出的地址和从机地址匹配，IICC1 寄存器的 HAAS 位会被置位，同时产生 I²C 中断。进入中断服务程序后，系统要检测 HAAS 位和 IICTOF 位，以判断 I²C 总线中断是来自从机地址匹配，还是来自 8 位数据传递完毕，或是来自 I²C 超时。在数据传递中，注意的是，在 7 位从机地址被发送后，接下来的一位，即第 8 位，是读 / 写控制位，该位的值会反映到 SRW 位中。从机通过检测 SRW 位以确定主控制器是要进入发送模式还是接收模式。在 I²C 总线开始传送数据前，需要先初始化 I²C 总线，初始化 I²C 总线步骤如下：

- 步骤 1
设置 IICC0 寄存器中 IICEN 位为“1”，以使能 I²C 总线。
- 步骤 2
向 I²C 总线地址寄存器 IICA 写入从机地址。
- 步骤 3
设置中断控制寄存器中的 IICE 位，以使能 I²C 中断。



I²C 总线初始化流程图

I²C 总线起始信号

起始信号只能由连接 I²C 总线主机产生，而不是由只做从机的 MCU 产生。总线上的所有从机都可以侦测到起始信号。如果有从机侦测到起始信号，则表明 I²C 总线处于忙碌状态，并会置位 HBB。起始信号是指在 SCL 为高电平时，SDA 线上发生从高到低的电平变化。

从机地址

总线上的所有从机都会侦测由主机发出的起始信号。发送起始信号后，紧接着主机会发送从机地址以选择要进行数据传输的从机。所有在 I²C 总线上的从机接收到 7 位地址数据后，都会将其与各自内部的地址进行比较。如果从机从主机上接收到的地址与自身内部的地址相匹配，则会产生一个 I²C 总线中断信号。地址位接下来的一位为读 / 写状态位（即第 8 位），将被保存到 IICC1 寄存器的 SRW 位，随后发出一个低电平应答信号（即第 9 位）。当单片机从机的地址匹配时，会将状态标志位 HAAS 置位。

I²C 总线有三个中断源，当程序运行至中断服务子程序时，通过检测 HAAS 位和 IICTOF 位，以确定 I²C 总线中断是来自从机地址匹配，还是来自 8 位数据传递完毕，或是来自 I²C 超时。当是从机地址匹配发生中断时，则从机或是用于发送模式并将数据写进 IICD 寄存器，或是用于接收模式并从 IICD 寄存器中读取空值以释放 SCL 线。

I²C 总线读 / 写信号

IICC1 寄存器的 SRW 位用来表示主机是要从 I²C 总线上读取数据还是要将数据写到 I²C 总线上。从机则通过检测该位以确定自己是作为发送方还是接收方。当 SRW 置“1”，表示主机要从 I²C 总线上读取数据，从机则作为发送方，将数据写到 I²C 总线；当 SRW 清“0”，表示主机要写数据到 I²C 总线上，从机则做为接收方，从 I²C 总线上读取数据。

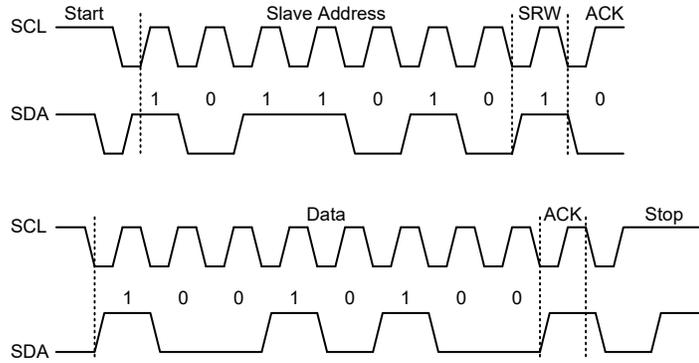
I²C 总线从机地址确认信号

主机发送呼叫地址后，当 I²C 总线上的任何从机内部地址与其匹配时，会发送一个应答信号。此应答信号会通知主机有从机已经接收到了呼叫地址。如果主机没有收到应答信号，则主机必须发送停止 (STOP) 信号以结束通信。当 HAAS 为高时，表示从机接收到的地址与自己内部地址匹配，则从机需检查 SRW 位，以确定自己是作为发送方还是作为接收方。如果 SRW 位为高，从机须设置成发送方，这样会置位 IICC1 寄存器的 HTX 位。如果 SRW 位为低，从机须设置成接收方，这样会清零 IICC1 寄存器的 HTX 位。

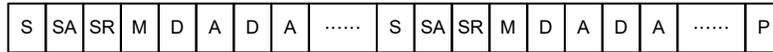
I²C 总线数据和确认信号

在从机确认接收到地址后，会进行 8 位宽度的数据传输。这个数据传输顺序是的高位在前，低位在后。接收方在接收到 8 位数据后必须发出一个应答信号（“0”）以继续接收下一个数据。如果发送方没接收到应答信号，发送方将释放 SDA 线，同时，主机将发出 STOP 信号以释放 I²C 总线。所传送的数据存储在 IICD 寄存器中。如果设置成发送方，从机必须先将欲传输的数据写到 IICD 寄存器中；如果设置成接收方，从机必须从 IICD 寄存器读取数据。

当接收器想要继续接收下一个数据时，必须在第 9 个时钟发出应答信号 (TXAK)。被设为发送方的从机将检测寄存器 IICC1 中的 RXAK 位以判断是否传输下一个字节的数据，如果单片机不传输下一个字节，那么它将释放 SDA 线并等待接收主机的停止信号。

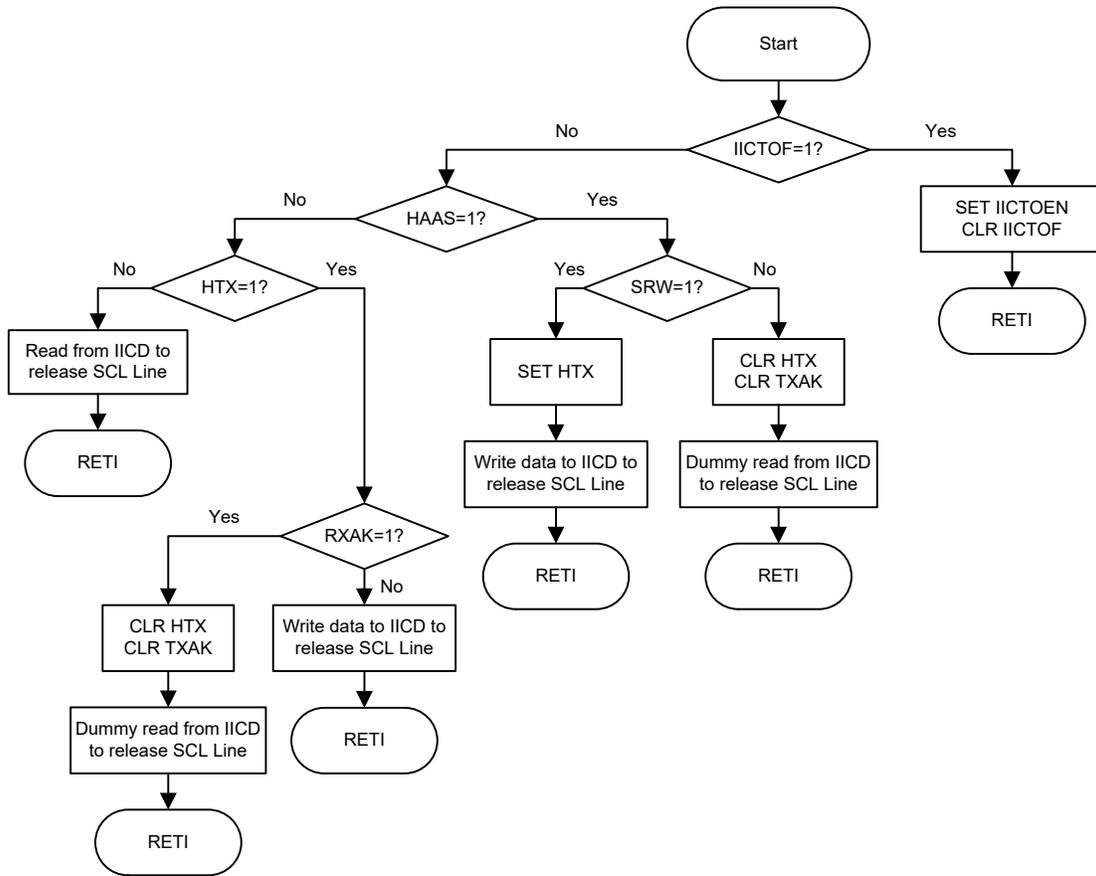


S=Start (1 bit)
SA=Slave Address (7 bits)
SR=SRW bit (1 bit)
M=Slave device send acknowledge bit (1 bit)
D=Data (8 bits)
A=ACK (RXAK bit for transmitter, TXAK bit for receiver, 1 bit)
P=Stop (1 bit)



注：* 当从机地址匹配时，单片机必须选择设置为发送模式还是接收模式。若设置为发送模式，需写数据至 IICD 寄存器；若设置为接收模式，需立即从 IICD 寄存器中虚读数据以释放 SCL 线。

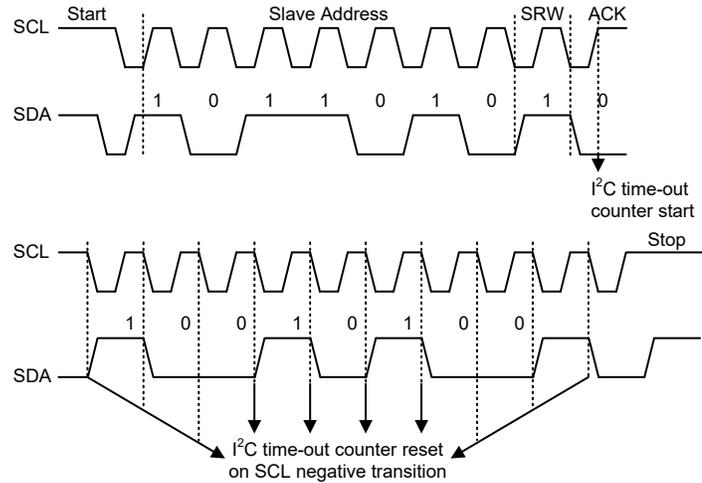
I²C 通信时序图



I²C 总线 ISR 流程图

I²C 超时控制

超时功能可减少由于接收错误的时钟源而引起的 I²C 锁死问题。在一定时间内如果 I²C 总线未接收到时钟源，则 I²C 电路和寄存器将会复位。超时计数器在 I²C 总线接收到“START”信号和“地址匹配”条件时开始计数，并在 SCL 下降沿处清零。在下一个 SCL 下降沿来临之前，如果等待时间大于 IICTOC 寄存器设定的超时时间，则会发生超时现象。当 I²C “STOP”条件发生时，超时计数器将停止计数。



I²C 超时

当 I²C 超时计数器溢出时，计数器停止且 IICTOEN 位清零，且 IICTOF 位被置高以表明超时计数器中断发生。超时时将产生一个中断且共用 I²C 中断向量。当 I²C 超时发生时，超时计数器中断使用的也是 I²C 中断向量。当 I²C 超时发生时，I²C 内部电路会被复位，寄存器也将发生如下复位情况。

寄存器	I ² C 超时发生后
IICD, IICA, IICC0	保持不变
IICC1	复位至 POR

IICTOF 标志位由应用程序清零。64 个超时时钟周期可由 IICTOC 寄存器里的相应位来设置。超时时间的计算方法如下：

$$((1 \sim 64) \times 32) / f_{SUB}$$

由此可得超时周期范围为 1ms~64ms。

IICTOC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	IICTOEN	IICTOF	IICTOS5	IICTOS4	IICTOS3	IICTOS2	IICTOS1	IICTOS0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7 **IICTOEN**: I²C 超时控制位
0: 除能
1: 使能

Bit 6 **IICTOF**: I²C 超时标志位
0: 超时未发生
1: 超时发生

Bit 5~0 **IICTOS5~IICTOS0**: I²C 超时时间选择位
I²C 超时时钟源是 $f_{SUB}/32$
I²C 超时时间计算公式: $(IICTOS[5:0]+1) \times (32/f_{SUB})$

中断

中断是单片机一个重要功能。当外部事件或内部功能如定时器模块或 A/D 转换器有效，并且产生中断时，系统会暂时中止当前的程序而转到执行相对应的中断服务程序。此单片机提供多个外部中断和内部中断功能，外部中断由 INT0 和 INT1 引脚动作产生，而内部中断由各种内部功能，如定时器模块、时基、LVD、EEPROM 和 A/D 转换器等产生。

中断寄存器

中断控制基本上是在一定单片机条件发生时设置请求标志位，应用程序中中断使能位的设置是通过位于专用数据存储器中的一系列寄存器控制的，总的分为三类。第一类是 INTC0~INTC2 寄存器，用于设置基本的中断；第二类是 MF10~MF11 寄存器，用于设置多功能中断；最后一种有 INTEG 寄存器，用于设置外部中断边沿触发类型。

寄存器中含有中断控制位和中断请求标志位。中断控制位用于使能或除能各种中断，中断请求标志位用于存放当前中断请求的状态。它们都按照特定的模式命名，前面表示中断类型的缩写，紧接着的字母“E”代表使能/除能位，“F”代表请求标志位。

功能	使能位	请求标志	注释
总中断	EMI	—	—
INTn 脚	INTnE	INTnF	n=0~1
多功能	MFnE	MFnF	n=0~1
A/D 转换器	ADE	ADF	—
时基	TBnE	TBnF	n=0~1
LVD	LVE	LVF	—
EEPROM	DEE	DEF	—
I ² C	IICE	IICF	—
过流保护	OCPE	OCPF	—
PTM	PTMnPE	PTMnPF	n=0~1
	PTMnAE	PTMnAF	

中断寄存器位命名模式

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
INTEG	—	—	—	—	INT1S1	INT1S0	INT0S1	INT0S0
INTC0	—	INT1F	OCPF	INT0F	INT1E	OCPE	INT0E	EMI
INTC1	TB1F	TB0F	MF1F	MF0F	TB1E	TB0E	MF1E	MF0E
INTC2	DEF	LVF	ADF	IICF	DEE	LVE	ADE	IICE
MF10	—	—	PTM0AF	PTM0PF	—	—	PTM0AE	PTM0PE
MF11	—	—	PTM1AF	PTM1PF	—	—	PTM1AE	PTM1PE

中断寄存器列表

INTEG 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	INT1S1	INT1S0	INT0S1	INT0S0
R/W	—	—	—	—	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	0	0	0	0

Bit 7~4 未定义，读为“0”

Bit 3~2 **INT1S1~INT1S0**: INT1 脚中断边沿控制位

- 00: 除能
- 01: 上升沿
- 10: 下降沿
- 11: 双沿

Bit 1~0 **INT0S1~INT0S0**: INT0 脚中断边沿控制位

- 00: 除能
- 01: 上升沿
- 10: 下降沿
- 11: 双沿

INTC0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	INT1F	OCPF	INT0F	INT1E	OCPE	INT0E	EMI
R/W	—	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	—	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7 未定义，读为“0”

Bit 6 **INT1F**: INT1 中断请求标志位

- 0: 无请求
- 1: 中断请求

Bit 5 **OCPF**: OCP 中断请求标志位

- 0: 无请求
- 1: 中断请求

Bit 4 **INT0F**: INT0 中断请求标志位

- 0: 无请求
- 1: 中断请求

Bit 3 **INT1E**: INT1 中断控制位

- 0: 除能
- 1: 使能

Bit 2 **OCPE**: OCP 中断控制位

- 0: 除能
- 1: 使能

Bit 1 **INT0E**: INT0 中断控制位

- 0: 除能
- 1: 使能

Bit 0 **EMI**: 总中断控制位

- 0: 除能
- 1: 使能

INTC1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	TB1F	TB0F	MF1F	MF0F	TB1E	TB0E	MF1E	MF0E
R/W								
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 7 **TB1F**: 时基 1 中断请求标志位
0: 无请求
1: 中断请求
- Bit 6 **TB0F**: 时基 0 中断请求标志位
0: 无请求
1: 中断请求
- Bit 5 **MF1F**: 多功能中断 1 请求标志位
0: 无请求
1: 中断请求
- Bit 4 **MF0F**: 多功能中断 0 请求标志位
0: 无请求
1: 中断请求
- Bit 3 **TB1E**: 时基 1 中断控制位
0: 除能
1: 使能
- Bit 2 **TB0E**: 时基 0 中断控制位
0: 除能
1: 使能
- Bit 1 **MF1E**: 多功能中断 1 控制位
0: 除能
1: 使能
- Bit 0 **MF0E**: 多功能中断 0 控制位
0: 除能
1: 使能

INTC2 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	DEF	LVF	ADF	IICF	DEE	LVE	ADE	IICE
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 7 **DEF**: 数据 EEPROM 中断请求标志位
0: 无请求
1: 中断请求
- Bit 6 **LVF**: LVD 中断请求标志位
0: 无请求
1: 中断请求
- Bit 5 **ADF**: A/D 转换器中断请求标志位
0: 无请求
1: 中断请求
- Bit 4 **IICF**: I²C 中断请求标志位
0: 无请求
1: 中断请求
- Bit 3 **DEE**: 数据 EEPROM 中断控制位
0: 除能
1: 使能
- Bit 2 **LVE**: LVD 中断控制位
0: 除能
1: 使能
- Bit 1 **ADE**: A/D 转换器中断控制位
0: 除能
1: 使能
- Bit 0 **IICE**: I²C 中断控制位
0: 除能
1: 使能

MF10 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	PTM0AF	PTM0PF	—	—	PTM0AE	PTM0PE
R/W	—	—	R/W	R/W	—	—	R/W	R/W
POR	—	—	0	0	—	—	0	0

- Bit 7~6 未定义，读为“0”
- Bit 5 **PTM0AF**: PTM0 比较器 A 匹配中断请求标志位
0: 无请求
1: 中断请求
- Bit 4 **PTM0PF**: PTM0 比较器 P 匹配中断请求标志位
0: 无请求
1: 中断请求
- Bit 3~2 未定义，读为“0”
- Bit 1 **PTM0AE**: PTM0 比较器 A 匹配中断控制位
0: 除能
1: 使能
- Bit 0 **PTM0PE**: PTM0 比较器 P 匹配中断控制位
0: 除能
1: 使能

MFII 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	PTM1AF	PTM1PF	—	—	PTM1AE	PTM1PE
R/W	—	—	R/W	R/W	—	—	R/W	R/W
POR	—	—	0	0	—	—	0	0

Bit 7~6 未定义，读为“0”

Bit 5 **PTM1AF**: PTM1 比较器 A 匹配中断请求标志位
0: 无请求
1: 中断请求

Bit 4 **PTM1PF**: PTM1 比较器 P 匹配中断请求标志位
0: 无请求
1: 中断请求

Bit 3~2 未定义，读为“0”

Bit 1 **PTM1AE**: PTM1 比较器 A 匹配中断控制位
0: 除能
1: 使能

Bit 0 **PTM1PE**: PTM1 比较器 P 匹配中断控制位
0: 除能
1: 使能

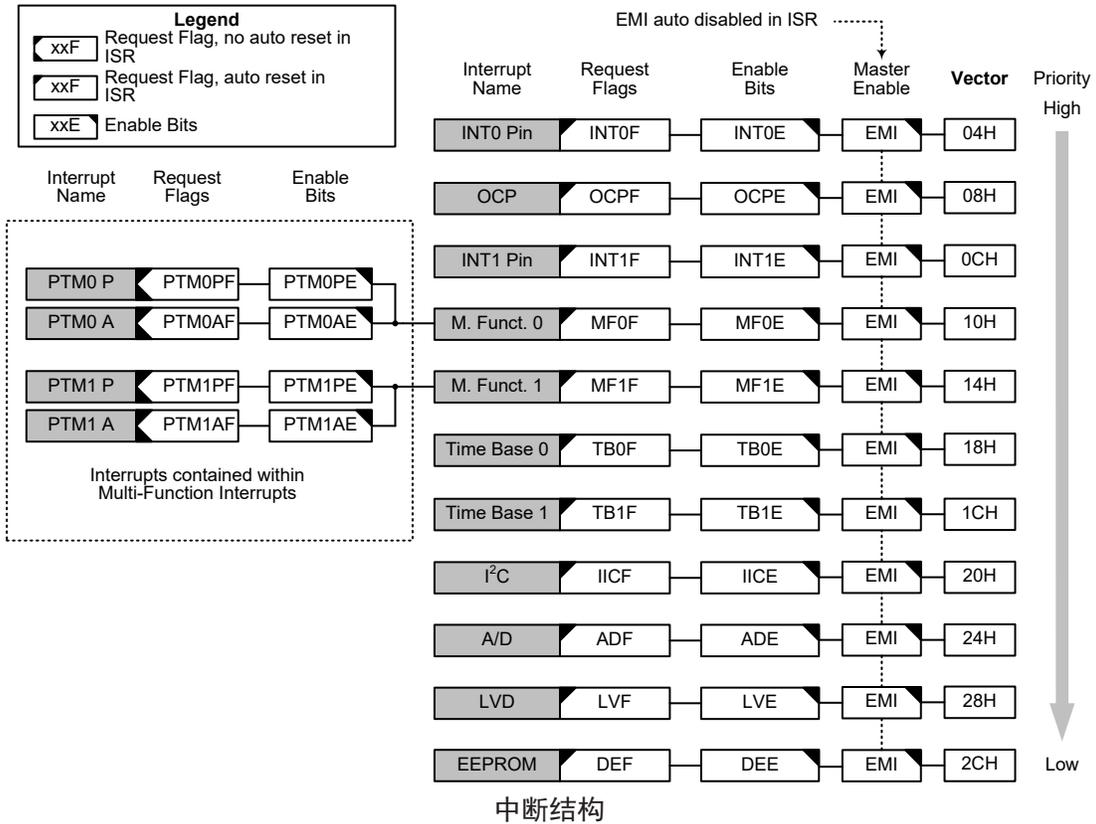
中断操作

若中断事件条件产生，如一个 TM 比较器 P、比较器 A 匹配或 A/D 转换结束等等，相关中断请求标志将置起。中断标志产生后程序是否会跳转至相关中断向量执行是由中断使能位的条件决定的。若使能位为“1”，程序将跳至相关中断向量中执行；若使能位为“0”，即使中断请求标志置起中断也不会发生，程序也不会跳转至相关中断向量执行。若总中断使能位为“0”，所有中断都将除能。

当中断发生时，下条指令的地址将被压入堆栈。相应的中断向量地址加载至 PC 中。系统将从此向量取下条指令。中断向量处通常为“JMP”指令，以跳转到相应的中断服务程序。中断服务程序必须以“RETI”指令返回至主程序，以继续执行原来的程序。

各个中断使能位以及相应的请求标志位，以优先级的次序显示在下图。一些中断源有自己的向量，但是有些中断却共用多功能中断向量。一旦中断子程序被响应，系统将自动清除 EMI 位，所有其它的中断将被屏蔽，这个方式可以防止任何进一步的中断嵌套。其它中断请求可能发生在此期间，虽然中断不会立即响应，但是中断请求标志位会被记录。

如果某个中断服务子程序正在执行时，有另一个中断要求立即响应，那么 EMI 位应在程序进入中断子程序后置位，以允许此中断嵌套。如果堆栈已满，即使此中断使能，中断请求也不会被响应，直到 SP 减少为止。如果要求立刻动作，则堆栈必须避免成为储满状态。请求同时发生时，执行优先级如下流程图所示。所有被置起的中断请求标志都可把单片机从休眠或空闲模式中唤醒，若要防止唤醒动作发生，在单片机进入休眠或空闲模式前应将相应的标志置起。



外部中断

通过 INT0~INT1 引脚上的信号变化可控制外部中断。当触发沿选择位设置好触发类型，INT0~INT1 引脚的状态发生变化，外部中断请求标志 INT0F~INT1F 被置位时外部中断请求产生。若要跳转到相应中断向量地址，总中断控制位 EMI 和相应中断使能位 INT0E~INT1E 需先被置位。此外，必须使用 INTEG 寄存器使能外部中断功能并选择触发沿类型。外部中断引脚和普通 I/O 口共用，如果相应寄存器中的中断使能位被置位，并且通过引脚共用寄存器选择外部中断脚，此引脚将被作为外部中断脚使用。此时该引脚必须通过设置控制寄存器，将该引脚设置为输入口。当中断使能，堆栈未满并且外部中断脚状态改变，将调用外部中断向量子程序。当响应外部中断服务子程序时，中断请求标志位 INT0F~INT1F 会自动复位且 EMI 位会被清零以除能其它中断。注意，即使此引脚被用作外部中断输入，其上拉电阻仍保持有效。

寄存器 INTEG 被用来选择有效的边沿类型，来触发外部中断。可以选择上升沿还是下降沿或双沿触发都产生外部中断。注意 INTEG 也可以用来除能外部中断功能。

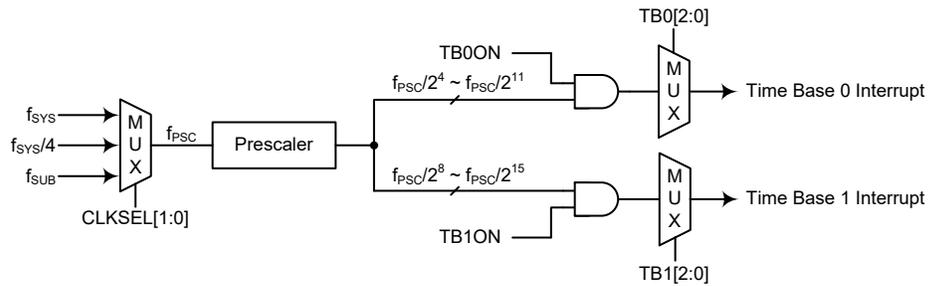
过流保护中断

过流保护中断是通过检测 OCP 的输入电流控制的。当检测到过电流情况时，过流保护中断请求标志位 OCPF 被置位，OCP 中断请求发生。当总中断使能位 EMI 和 OCP 中断使能位 OCPE 被置位，允许程序跳转到相应的中断向量地址。当中断使能，堆栈未满且过电流情况发生时，将调用 OCP 中断向量子程序。当响应中断服务子程序时，相应的中断请求标志位 OCPF 会自动清零。EMI 位也会被清零以除能其它中断。

时基中断

时基中断提供一个固定周期的中断信号，由各自的定时器功能产生溢出信号控制。当各自的中断请求标志 TB0F 或 TB1F 被置位时，中断请求发生。当总中断使能位 EMI 和时基使能位 TB0E 或 TB1E 被置位，允许程序跳转到各自的中断向量地址。当中断使能，堆栈未满足且时基溢出时，将调用它们各自的中断向量程序。当响应中断服务子程序时，相应的中断请求标志位 TB0F 或 TB1F 会自动复位且 EMI 位会被清零以除能其它中断。

时基中断的目的是提供一个固定周期的中断信号。其时钟源 f_{PSC} 来自内部时钟源 f_{SYS} 、 $f_{SYS}/4$ 或 f_{SUB} 。 f_{PSC} 输入时钟首先经过分频器，分频率由程序设置 TB0C 和 TB1C 寄存器相关位获取合适的分频值以提供更长的时基中断周期。相应的控制时基中断周期的时钟源可通过 PSCR 寄存器的 CLKSEL1 和 CLKSEL0 位选择。



时基中断

PSCR 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	CLKSEL1	CLKSEL0
R/W	—	—	—	—	—	—	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	—	—	0	0

Bit 7~2 未定义，读为“0”

Bit 1~0 **CLKSEL1~CLKSEL0**: 分频器时钟源选择

00: f_{SYS}
01: $f_{SYS}/4$
1x: f_{SUB}

TB0C 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	TB0ON	—	—	—	—	TB02	TB01	TB00
R/W	R/W	—	—	—	—	R/W	R/W	R/W
POR	0	—	—	—	—	0	0	0

Bit 7 **TB0ON**: 时基 0 使能 / 除能控制位

0: 除能
1: 使能

Bit 6~3 未定义，读为“0”

Bit 2~0 **TB02~TB00**: 选择时基 0 溢出周期位
 000: $2^4/f_{PSC}$
 001: $2^5/f_{PSC}$
 010: $2^6/f_{PSC}$
 011: $2^7/f_{PSC}$
 100: $2^8/f_{PSC}$
 101: $2^9/f_{PSC}$
 110: $2^{10}/f_{PSC}$
 111: $2^{11}/f_{PSC}$

TB1C 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	TB1ON	—	—	—	—	TB12	TB11	TB10
R/W	R/W	—	—	—	—	R/W	R/W	R/W
POR	0	—	—	—	—	0	0	0

Bit 7 **TB1ON**: 时基 1 使能 / 除能控制位
 0: 除能
 1: 使能

Bit 6~3 未定义, 读为 “0”

Bit 2~0 **TB12~TB10**: 选择时基 1 溢出周期位
 000: $2^8/f_{PSC}$
 001: $2^9/f_{PSC}$
 010: $2^{10}/f_{PSC}$
 011: $2^{11}/f_{PSC}$
 100: $2^{12}/f_{PSC}$
 101: $2^{13}/f_{PSC}$
 110: $2^{14}/f_{PSC}$
 111: $2^{15}/f_{PSC}$

I²C 中断

当一个字节数据已由 I²C 接口接收或发送完, 或 I²C 从机地址匹配, 或 I²C 超时发生, 中断请求标志 IICF 被置位, I²C 中断请求产生。若要程序跳转到相应中断向量地址, 总中断控制位 EMI 和 I²C 中断使能位 IICE 需先被置位。当中断使能, 堆栈未满足且以上任一种情况发生时, 将调用 I²C 中断向量子程序。当 I²C 中断响应时, I²C 中断请求标志位会自动复位且 EMI 位会被清零以除能其它中断。

A/D 转换器中断

A/D 转换器中断由 A/D 转换动作的结束来控制。当 A/D 转换器中断请求标志被置位, 即 A/D 转换过程完成时, 中断请求发生。若要跳转到相应中断向量地址, 总中断控制位 EMI 和 A/D 转换器中断使能位 ADE 需先被置位。当中断使能, 堆栈未满足且 A/D 转换动作结束时, 将调用 A/D 转换器中断向量子程序。当响应中断服务子程序时, 相应的中断请求标志位 ADF 会自动复位且 EMI 位会被清零以除能其它中断。

LVD 中断

当低电压检测功能检测到一个低电压时, LVD 中断请求标志 LVF 被置位, LVD 中断请求产生。若要程序跳转到相应中断向量地址, 总中断使能位 EMI 和低电压中断使能位 LVE 需先被置位。当中断使能, 堆栈未满足且低电压条件发生时, 将调用 LVD 中断向量子程序。当 LVD 中断被响应, 相应的中断请求标志位 LVF 会自动清零。EMI 也会自动清零以除能其它中断。

EEPROM 中断

当写周期结束，EEPROM 中断请求标志 DEF 被置位，EEPROM 中断请求产生。若要程序跳转到相应中断向量地址，总中断控制位 EMI、EEPROM 中断使能位 DEE 需先被置位。当中断使能，堆栈未满且 EEPROM 写周期结束时，可跳转至相应的 EEPROM 中断向量子程序中执行。当 EEPROM 中断响应，相应中断请求标志位 DEF 会自动清零且 EMI 位也会被清零以除能其它中断。

多功能中断

此单片机中有 2 种多功能中断，与其它中断不同，它没有独立源，但由其它现有的中断源构成，即 TM 中断。

当多功能中断中任何一种中断请求标志 MF_nF 被置位，多功能中断请求产生。当中断使能，堆栈未满，包括在多功能中断中的任意一个中断发生时，将调用多功能中断向量中的一个子程序。当响应中断服务子程序时，相关多功能请求标志位会自动复位且 EMI 位会自动清零以除能其它中断。

但必须注意的是，在中断响应时，虽然多功能中断标志会自动复位，但多功能中断源的请求标志位，即 TM 中断的请求标志位不会自动复位，必须由应用程序清零。

TM 中断

周期型 TM 有两个中断，都属于多功能中断。每个周期型 TM 都有两个中断请求标志位 PTM_nPF 和 PTM_nAF 及两个使能位 PTM_nPE 和 PTM_nAE。当 TM 比较器 P、A 匹配情况发生时，相应 TM 中断请求标志被置位，TM 中断请求产生。

若要程序跳转到相应中断向量地址，总中断控制位 EMI、相应 TM 中断使能位和相关多功能中断使能位 MF_nE 需先被置位。当中断使能，堆栈未满且 TM 比较器匹配情况发生时，可跳转至相关多功能中断向量子程序中执行。当 TM 中断响应，EMI 将被自动清零以除能其它中断，相关 MF_nF 标志也可自动清除，但 TM 中断请求标志需在应用程序中手动清除。

中断唤醒功能

每个中断都具有将处于休眠或空闲模式的单片机唤醒的能力。当中断请求标志由低到高转换时唤醒动作产生，其与中断是否使能无关。因此，尽管单片机处于休眠或空闲模式且系统振荡器停止工作，如有外部中断脚上产生外部边沿跳变或低电压都可能导致其相应的中断标志被置位，由此产生中断，因此必须注意避免伪唤醒情况的发生。若中断唤醒功能被除能，单片机进入休眠或空闲模式前相应中断请求标志应被置起。中断唤醒功能不受中断使能位的影响。

编程注意事项

通过禁止相关中断使能位，可以屏蔽中断请求，然而，一旦中断请求标志位被设定，它们会被保留在中断控制寄存器内，直到相应的中断服务子程序执行或请求标志位被软件指令清除。

多功能中断中所含中断相应程序执行时，多功能中断请求标志 MF_nF 可以自动清零，但各自的请求标志需在应用程序中手动清除。

建议在中断服务子程序中不要使用“CALL 子程序”指令。中断通常发生在不可预料的情况或是需要立刻执行的某些应用。假如只剩下一层堆栈且没有控制好中断，当“CALL 子程序”在中断服务子程序中执行时，将破坏原来的控制序列。

所有中断在休眠或空闲模式下都具有唤醒功能，当中断请求标志发生由低到高的转变时都可产生唤醒功能。若要避免相应中断产生唤醒动作，在单片机进入休眠或空闲模式前需先将相应请求标志置为高。

当进入中断服务程序，系统仅将程序计数器的内容压入堆栈，如果中断服务程序会改变状态寄存器或其它的寄存器的内容而破坏控制流程，应事先将这些数据保存起来。

若从中断子程序中返回可执行 RET 或 RETI 指令。除了能返回至主程序外，RETI 指令还能自动设置 EMI 位为高，允许进一步中断。RET 指令只能返回至主程序，清除 EMI 位，除能进一步中断。

低电压检测 – LVD

此单片机具有低电压检测功能，即 LVD。该功能使能用于监测电源电压 V_{DD} ，若电源电压低于一定值可提供一个警告信号。此功能在电池类产品中非常有用，在电池电压较低时产生警告信号。低电压检测也可产生中断信号。

LVD 寄存器

低电压检测功能由 LVDC 寄存器控制。VLVD2~VLVD0 位用于选择 8 个固定的电压中的一个参考点。LVDO 位被置位时低电压情况发生，若 LVDO 位为低表明 V_{DD} 电压工作在当前所设置低电压水平值之上。LVDEN 位用于控制低电压检测功能的开启 / 关闭，设置此位为高使能此功能，反之，关闭内部低电压检测电路。低电压检测会有一些的功耗，在不使用时可考虑关闭此功能，此举在功耗要求严格的电池供电应用中值得考虑。

LVDC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	LVDO	LVDEN	VBGEN	VLVD2	VLVD1	VLVD0
R/W	—	—	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	—	—	0	0	0	0	0	0

Bit 7~6 未定义，读为“0”

Bit 5 **LVDO**: LVD 输出标志位
0: 未检测到低电压
1: 检测到低电压

Bit 4 **LVDEN**: 低电压检测控制位
0: 除能
1: 使能

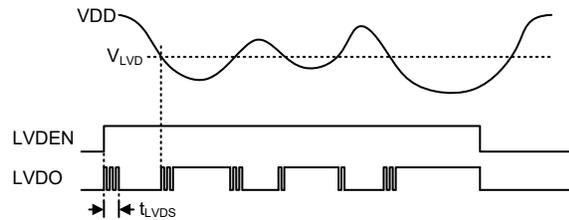
Bit 3 **VBGEN**: Bandgap 电压输出控制位
0: 除能
1: 使能

如果 LVD 或 LVR 使能或 VBGEN 置位，Bandgap 会自动使能。

Bit 2~0 **VLVD2~VLVD0**: 选择 LVD 电压位
000: 2.0V
001: 2.2V
010: 2.4V
011: 2.7V
100: 3.0V
101: 3.3V
110: 3.6V
111: 4.0V

LVD 操作

通过比较电源电压 V_{DD} 与存储在 LVDC 寄存器中的预置电压值的结果，低电压检测功能工作。其设置的范围为 2.0V~4.0V。当电源电压 V_{DD} 低于预置电压值时，LVDO 位被置为高，表明低电压产生。低电压检测功能由一个自动使能的参考电压提供。当单片机进入休眠模式时，即使 LVDEN 位为高，低电压检测器也会自动除能。低电压检测器使能后，读取 LVDO 位前，电路稳定需要一定的延时 t_{LVDS} 。注意， V_{DD} 电压可能上升或下降比较缓慢，在 V_{LVD} 电压值附近时，LVDO 位可能有多种变化。

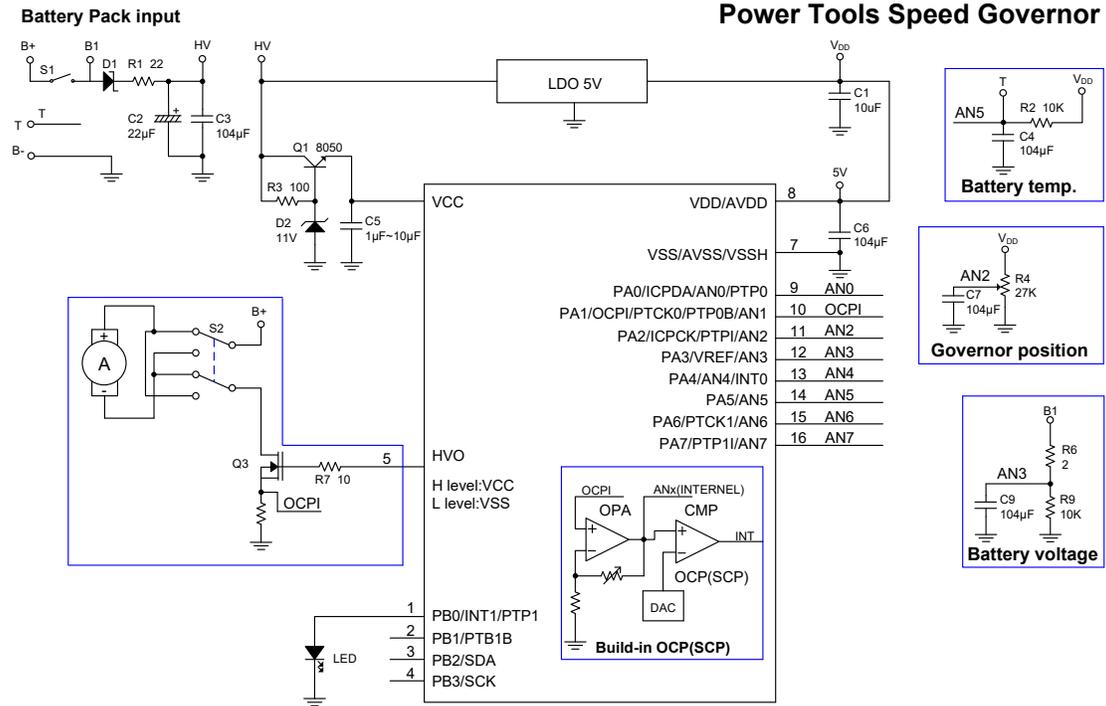


LVD 操作

低电压检测器也有自己的中断功能，它是除了轮询 LVDO 位之外的另一种检测低电压的方法。中断条件产生置位 LVDO 并延时 t_{LVD} 后，中断产生。此种情况下，若 V_{DD} 降至小于 LVD 预置电压值时，中断请求标志位 LVF 将被置位，中断产生，单片机将从休眠或空闲模式中被唤醒。若不要求低电压检测的唤醒功能使能，在单片机进入休眠或空闲模式前应将 LVF 标志置为高。

当 LVD 功能使能后，建议在使能相关中断前先将 LVD 中断标志位清零以避免错误操作。

应用电路



指令集

简介

任何单片机成功运作的核心在于它的指令集，此指令集为一组程序指令码，用来指导单片机如何去执行指定的工作。在 Holtek 单片机中，提供了丰富且灵活的指令，共超过六十条，程序设计者可以事半功倍地实现它们的应用。

为了更加容易理解各种各样的指令码，接下来按功能分组介绍它们。

指令周期

大部分的操作均只需要一个指令周期来执行。分支、调用或查表则需要两个指令周期。一个指令周期相当于四个系统时钟周期，因此如果在 8MHz 的系统时钟振荡器下，大部分的操作将在 0.5 μ s 中执行完成，而分支或调用操作则将在 1 μ s 中执行完成。虽然需要两个指令周期的指令通常指的是 JMP、CALL、RET、RETI 和查表指令，但如果牵涉到程序计数器低字节寄存器 PCL 也将多花费一个周期去加以执行。即指令改变 PCL 的内容进而导致直接跳转至新地址时，需要多一个周期去执行，例如“CLR PCL”或“MOV PCL, A”指令。对于跳转指令必须注意的是，如果比较的结果牵涉到跳转动作将多花费一个周期，如果没有则需一个周期即可。

数据的传送

单片机程序中数据传送是使用最为频繁的操作之一，使用三种 MOV 的指令，数据不但可以从寄存器转移至累加器（反之亦然），而且能够直接移动立即数到累加器。数据传送最重要的应用之一是从输入端口接收数据或传送数据到输出端口。

算术运算

算术运算和数据处理是大部分单片机应用所必需具备的能力，在 Holtek 单片机内部的指令集中，可直接实现加与减的运算。当加法的结果超出 255 或减法的结果少于 0 时，要注意正确的处理进位和借位的问题。INC、INCA、DEC 和 DECA 指令提供了对一个指定地址的值加一或减一的功能。

逻辑和移位运算

标准逻辑运算例如 AND、OR、XOR 和 CPL 全都包含在 Holtek 单片机内部的指令集中。大多数牵涉到数据运算的指令，数据的传送必须通过累加器。在所有逻辑数据运算中，如果运算结果为零，则零标志位将被置位，另外逻辑数据运用形式还有移位指令，例如 RR、RL、RRC 和 RLC 提供了向左或向右移动一位的方法。不同的移位指令可满足不同的应用需要。移位指令常用于串行端口的程序应用，数据可从内部寄存器转移至进位标志位，而此位则可被检验，移位运算还可应用在乘法与除法的运算组成中。

分支和控制转换

程序分支是采取使用 JMP 指令跳转至指定地址或使用 CALL 指令调用子程序的形式，两者之不同在于当子程序被执行完毕后，程序必须马上返回原来的地址。这个动作是由放置在子程序里的返回指令 RET 来实现，它可使程序跳回 CALL 指令之后的地址。在 JMP 指令中，程序则只是跳到一个指定的地址而已，并不需如 CALL 指令般跳回。一个非常有用的分支指令是条件跳转，跳转条件是由数据存储器或指定位来加以决定。遵循跳转条件，程序将继续执行下一条指令或略过且跳转至接下来的指令。这些分支指令是程序走向的关键，跳转条件可能是外部开关输入，或是内部数据位的值。

位运算

提供数据存储器中单个位的运算指令是 Holtek 单片机的特性之一。这特性对于输出端口位的设置尤其有用，其中个别的位或端口的引脚可以使用“SET [m].i”或“CLR [m].i”指令来设定其为高位或低位。如果没有这特性，程序设计师必须先读入输入口的 8 位数据，处理这些数据，然后再输出正确的新数据。这种读入 - 修改 - 写出的过程现在则被位运算指令所取代。

查表运算

数据的储存通常由寄存器完成，然而当处理大量固定的数据时，它的存储量常常造成对个别存储器的不便。为了改善此问题，Holtek 单片机允许在程序存储器中建立一个表格作为数据可直接存储的区域，只需要一组简易的指令即可对数据进行查表。

其它运算

除了上述功能指令外，其它指令还包括用于省电的“HALT”指令和使程序在极端电压或电磁环境下仍能正常工作的看门狗定时器控制指令。这些指令的使用则请查阅相关的章节。

指令集概要

当要操作的数据存储器位于数据存储器 Sector 0 时，下表说明了与数据存储器存取有关的指令。

惯例

x: 立即数
m: 数据存储器地址
A: 累加器
i: 第 0~7 位
addr: 程序存储器地址

助记符	说明	指令周期	影响标志位
算术运算			
ADD A,[m]	ACC 与数据存储器相加，结果放入 ACC	1	Z, C, AC, OV, SC
ADDM A,[m]	ACC 与数据存储器相加，结果放入数据存储器	1注	Z, C, AC, OV, SC
ADD A, x	ACC 与立即数相加，结果放入 ACC	1	Z, C, AC, OV, SC
ADC A,[m]	ACC 与数据存储器、进位标志相加，结果放入 ACC	1	Z, C, AC, OV, SC
ADCM A,[m]	ACC 与数据存储器、进位标志相加，结果放入数据存储器	1注	Z, C, AC, OV, SC
SUB A, x	ACC 与立即数相减，结果放入 ACC	1	Z, C, AC, OV, SC, CZ
SUB A,[m]	ACC 与数据存储器相减，结果放入 ACC	1	Z, C, AC, OV, SC, CZ
SUBM A,[m]	ACC 与数据存储器相减，结果放入数据存储器	1注	Z, C, AC, OV, SC, CZ
SBC A,[m]	ACC 与数据存储器、进位标志的反相减，结果放入 ACC	1	Z, C, AC, OV, SC, CZ
SBCM A,[m]	ACC 与数据存储器、进位标志相减，结果放入数据存储器	1注	Z, C, AC, OV, SC, CZ
SBC A, x	ACC 与立即数、进位标志相减，结果放入 ACC	1	Z, C, AC, OV, SC, CZ
DAA [m]	将加法运算中放入 ACC 的值调整为十进制数，并将结果放入数据存储器	1注	C
逻辑运算			
AND A,[m]	ACC 与数据存储器做“与”运算，结果放入 ACC	1	Z
OR A,[m]	ACC 与数据存储器做“或”运算，结果放入 ACC	1	Z
XOR A,[m]	ACC 与数据存储器做“异或”运算，结果放入 ACC	1	Z
ANDM A,[m]	ACC 与数据存储器做“与”运算，结果放入数据存储器	1注	Z
ORM A,[m]	ACC 与数据存储器做“或”运算，结果放入数据存储器	1注	Z
XORM A,[m]	ACC 与数据存储器做“异或”运算，结果放入数据存储器	1注	Z
AND A, x	ACC 与立即数做“与”运算，结果放入 ACC	1	Z
OR A, x	ACC 与立即数做“或”运算，结果放入 ACC	1	Z
XOR A, x	ACC 与立即数做“异或”运算，结果放入 ACC	1	Z
CPL [m]	对数据存储器取反，结果放入数据存储器	1注	Z
CPLA [m]	对数据存储器取反，结果放入 ACC	1	Z
递增和递减			
INCA [m]	递增数据存储器，结果放入 ACC	1	Z
INC [m]	递增数据存储器，结果放入数据存储器	1注	Z
DECA [m]	递减数据存储器，结果放入 ACC	1	Z
DEC [m]	递减数据存储器，结果放入数据存储器	1注	Z

助记符	说明	指令周期	影响标志位
移位			
RRA [m]	数据存储器右移一位，结果放入 ACC	1	无
RR [m]	数据存储器右移一位，结果放入数据存储器	1注	无
RRCA [m]	带进位将数据存储器右移一位，结果放入 ACC	1	C
RRC [m]	带进位将数据存储器右移一位，结果放入数据存储器	1注	C
RLA [m]	数据存储器左移一位，结果放入 ACC	1	无
RL [m]	数据存储器左移一位，结果放入数据存储器	1注	无
RLCA [m]	带进位将数据存储器左移一位，结果放入 ACC	1	C
RLC [m]	带进位将数据存储器左移一位，结果放入数据存储器	1注	C
数据传送			
MOV A,[m]	将数据存储器送至 ACC	1	无
MOV [m],A	将 ACC 送至数据存储器	1注	无
MOV A, x	将立即数送至 ACC	1	无
位运算			
CLR [m].i	清除数据存储器的位	1注	无
SET [m].i	置位数据存储器的位	1注	无
转移			
JMP addr	无条件跳转	2	无
SZ [m]	如果数据存储器为零，则跳过下一条指令	1注	无
SZA [m]	数据存储器送至 ACC，如果内容为零，则跳过下一条指令	1注	无
SNZ [m]	如果数据存储器不为零，则跳过下一条指令	1注	无
SZ [m].i	如果数据存储器的第 i 位为零，则跳过下一条指令	1注	无
SNZ [m].i	如果数据存储器的第 i 位不为零，则跳过下一条指令	1注	无
SIZ [m]	递增数据存储器，如果结果为零，则跳过下一条指令	1注	无
SDZ [m]	递减数据存储器，如果结果为零，则跳过下一条指令	1注	无
SIZA [m]	递增数据存储器，将结果放入 ACC，如果结果为零，则跳过下一条指令	1注	无
SDZA [m]	递减数据存储器，将结果放入 ACC，如果结果为零，则跳过下一条指令	1注	无
CALL addr	子程序调用	2	无
RET	从子程序返回	2	无
RET A, x	从子程序返回，并将立即数放入 ACC	2	无
RETI	从中断返回	2	无
查表			
TABRD [m]	读取特定页的 ROM 内容，并送至数据存储器 and TBLH	2注	无
TABRDL [m]	读取最后页的 ROM 内容，并送至数据存储器 and TBLH	2注	无
ITABRD [m]	读表指针 TBLP 自加，读取当前页的 ROM 内容，并送至数据存储器 and TBLH	2注	无
ITABRDL [m]	读表指针 TBLP 自加，读取最后页的 ROM 内容，并送至数据存储器 and TBLH	2注	无
其它指令			
NOP	空指令	1	无
CLR [m]	清除数据存储器	1注	无
SET [m]	置位数据存储器	1注	无

助记符	说明	指令周期	影响标志位
CLR WDT	清除看门狗定时器	1	TO, PDF
SWAP [m]	交换数据存储器的高低字节, 结果放入数据存储器	1 ^注	无
SWAPA [m]	交换数据存储器的高低字节, 结果放入 ACC	1	无
HALT	进入暂停模式	1	TO, PDF

- 注: 1. 对跳转指令而言, 如果比较的结果牵涉到跳转即需 3 个周期, 如果没有发生跳转, 则只需一个周期。
2. 任何指令若要改变 PCL 的内容将需要 2 个周期来执行。
3. 对于“CLR WDT”指令而言, TO 和 PDF 标志位也许会受执行结果影响, “CLR WDT”被执行后, TO 和 PDF 标志位会被清除, 否则 TO 和 PDF 标志位保持不变。

扩展指令集

扩展指令用来提供更大范围的数据存储器寻址。当被存取的数据存储器位于 Sector 0 之外的任何数据存储器 Sector，扩展指令可直接存取数据存储器而无需使用间接寻址，此举不仅可节省 Flash 存储空间的使用，同时可提高 CPU 执行效率。

助记符	说明	指令周期	影响标志位
算术运算			
LADD A,[m]	ACC 与数据存储器相加，结果放入 ACC	2	Z, C, AC, OV, SC
LADDM A,[m]	ACC 与数据存储器相加，结果放入数据存储器	2 ^注	Z, C, AC, OV, SC
LADC A,[m]	ACC 与数据存储器、进位标志相加，结果放入 ACC	2	Z, C, AC, OV, SC
LADCM A,[m]	ACC 与数据存储器、进位标志相加，结果放入数据存储器	2 ^注	Z, C, AC, OV, SC
LSUB A,[m]	ACC 与数据存储器相减，结果放入 ACC	2	Z, C, AC, OV, SC, CZ
LSUBM A,[m]	ACC 与数据存储器相减，结果放入数据存储器	2 ^注	Z, C, AC, OV, SC, CZ
LSBC A,[m]	ACC 与数据存储器、进位标志的反相减，结果放入 ACC	2	Z, C, AC, OV, SC, CZ
LSBCM A,[m]	ACC 与数据存储器、进位标志相减，结果放入数据存储器	2 ^注	Z, C, AC, OV, SC, CZ
LDA A [m]	将加法运算中放入 ACC 的值调整为十进制数，并将结果放入数据存储器	2 ^注	C
逻辑运算			
LAND A,[m]	ACC 与数据存储器做“与”运算，结果放入 ACC	2	Z
LOR A,[m]	ACC 与数据存储器做“或”运算，结果放入 ACC	2	Z
LXOR A,[m]	ACC 与数据存储器做“异或”运算，结果放入 ACC	2	Z
LANDM A,[m]	ACC 与数据存储器做“与”运算，结果放入数据存储器	2 ^注	Z
LORM A,[m]	ACC 与数据存储器做“或”运算，结果放入数据存储器	2 ^注	Z
LXORM A,[m]	ACC 与数据存储器做“异或”运算，结果放入数据存储器	2 ^注	Z
LCPL [m]	对数据存储器取反，结果放入数据存储器	2 ^注	Z
LCPLA [m]	对数据存储器取反，结果放入 ACC	2	Z
递增和递减			
LINCA [m]	递增数据存储器，结果放入 ACC	2	Z
LINC [m]	递增数据存储器，结果放入数据存储器	2 ^注	Z
LDECA [m]	递减数据存储器，结果放入 ACC	2	Z
LDEC [m]	递减数据存储器，结果放入数据存储器	2 ^注	Z
移位			
LRRA [m]	数据存储器右移一位，结果放入 ACC	2	无
LRR [m]	数据存储器右移一位，结果放入数据存储器	2 ^注	无
LRRCA [m]	带进位将数据存储器右移一位，结果放入 ACC	2	C
LRRC [m]	带进位将数据存储器右移一位，结果放入数据存储器	2 ^注	C
LRLA [m]	数据存储器左移一位，结果放入 ACC	2	无
LRL [m]	数据存储器左移一位，结果放入数据存储器	2 ^注	无
LRLCA [m]	带进位将数据存储器左移一位，结果放入 ACC	2	C
LRLC [m]	带进位将数据存储器左移一位，结果放入数据存储器	2 ^注	C
数据传送			
LMOV A,[m]	将数据存储器送至 ACC	2	无
LMOV [m],A	将 ACC 送至数据存储器	2 ^注	无

助记符	说明	指令周期	影响标志位
位运算			
LCLR [m].i	清除数据存储器的位	2 ^注	无
LSET [m].i	置位数据存储器的位	2 ^注	无
转移			
LSZ [m]	如果数据存储器为零，则跳过下一条指令	2 ^注	无
LSZA [m]	数据存储器送至 ACC，如果内容为零，则跳过下一条指令	1 ^注	无
LSNZ [m]	如果数据存储器不为零，则跳过下一条指令	2 ^注	无
LSZ [m].i	如果数据存储器的第 i 位为零，则跳过下一条指令	2 ^注	无
LSNZ [m].i	如果数据存储器的第 i 位不为零，则跳过下一条指令	2 ^注	无
LSIZ [m]	递增数据存储器，如果结果为零，则跳过下一条指令	2 ^注	无
LSDZ [m]	递减数据存储器，如果结果为零，则跳过下一条指令	2 ^注	无
LSIZA [m]	递增数据存储器，将结果放入 ACC，如果结果为零，则跳过下一条指令	2 ^注	无
LSDZA [m]	递减数据存储器，将结果放入 ACC，如果结果为零，则跳过下一条指令	2 ^注	无
查表			
LTABRD [m]	读取当前页的 ROM 内容，并送至数据存储器 and TBLH	3 ^注	无
LTABRDL [m]	读取最后页的 ROM 内容，并送至数据存储器 and TBLH	3 ^注	无
LITABRD [m]	读表指针 TBLP 自加，读取当前页的 ROM 内容，并送至数据存储器 and TBLH	3 ^注	无
LITABRDL [m]	读表指针 TBLP 自加，读取最后页的 ROM 内容，并送至数据存储器 and TBLH	3 ^注	无
其它指令			
LCLR [m]	清除数据存储器	2 ^注	无
LSET [m]	置位数据存储器	2 ^注	无
LSWAP [m]	交换数据存储器的高低字节，结果放入数据存储器	2 ^注	无
LSWAPA [m]	交换数据存储器的高低字节，结果放入 ACC	2	无

注：1. 对扩展跳转指令而言，如果比较的结果牵涉到跳转即需 4 个周期，如果没有发生跳转，则只需两个周期。

2. 任何扩展指令若要改变 PCL 的内容将需要 3 个周期来执行。

指令定义

ADC A, [m]	Add Data Memory to ACC with Carry
指令说明	将指定的数据存储器、累加器内容以及进位标志相加，结果存放到累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC + [m] + C$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC
ADCM A, [m]	Add ACC to Data Memory with Carry
指令说明	将指定的数据存储器、累加器内容和进位标志位相加，结果存放到指定的数据存储器。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC + [m] + C$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC
ADD A, [m]	Add Data Memory to ACC
指令说明	将指定的数据存储器和累加器内容相加，结果存放到累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC + [m]$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC
ADD A, x	Add immediate data to ACC
指令说明	将累加器和立即数相加，结果存放到累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC + x$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC
ADDM A, [m]	Add ACC to Data Memory
指令说明	将指定的数据存储器和累加器内容相加，结果存放到指定的数据存储器。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC + [m]$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC
AND A, [m]	Logical AND Data Memory to ACC
指令说明	将累加器中的数据和指定数据存储器内容做逻辑与，结果存放到累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC \text{ "AND" } [m]$
影响标志位	Z

AND A, x	Logical AND immediate data to ACC
指令说明	将累加器中的数据和立即数做逻辑与，结果存放到累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC \text{ “AND” } x$
影响标志位	Z
ANDM A, [m]	Logical AND ACC to Data Memory
指令说明	将指定数据存储器内容和累加器中的数据做逻辑与，结果存放到数据存储器。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC \text{ “AND” } [m]$
影响标志位	Z
CALL addr	Subroutine call
指令说明	无条件地调用指定地址的子程序，此时程序计数器先加 1 获得下一个要执行的指令地址并压入堆栈，接着载入指定地址并从新地址继续执行程序，由于此指令需要额外的运算，所以为一个 2 周期的指令。
功能表示	$Stack \leftarrow Program\ Counter + 1$ $Program\ Counter \leftarrow addr$
影响标志位	无
CLR [m]	Clear Data Memory
指令说明	将指定数据存储器的内容清零。
功能表示	$[m] \leftarrow 00H$
影响标志位	无
CLR [m].i	Clear bit of Data Memory
指令说明	将指定数据存储器的 i 位内容清零。
功能表示	$[m].i \leftarrow 0$
影响标志位	无
CLR WDT	Clear Watchdog Timer
指令说明	WDT 计数器、暂停标志位 PDF 和看门狗溢出标志位 TO 清零。
功能表示	WDT cleared $TO \ \& \ PDF \leftarrow 0$
影响标志位	TO、PDF

CPL [m]	Complement Data Memory
指令说明	将指定数据存储器中的每一位取逻辑反，相当于从 1 变 0 或 0 变 1。
功能表示	$[m] \leftarrow \overline{[m]}$
影响标志位	Z
CPLA [m]	Complement Data Memory with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器中的每一位取逻辑反，相当于从 1 变 0 或 0 变 1，而结果被储存回累加器且数据存储器中的内容不变。
功能表示	$ACC \leftarrow \overline{[m]}$
影响标志位	Z
DAA [m]	Decimal-Adjust ACC for addition with result in Data Memory
指令说明	将累加器中的内容转换为 BCD（二进制转成十进制）码。如果低四位的值大于“9”或 AC=1，那么 BCD 调整就执行对原值加“6”，否则原值保持不变；如果高四位的值大于“9”或 C=1，那么 BCD 调整就执行对原值加“6”。BCD 转换实质上是根据累加器和标志位执行 00H，06H，60H 或 66H 的加法运算，结果存放到数据存储器。只有进位标志位 C 受影响，用来指示原始 BCD 的和是否大于 100，并可以进行双精度十进制数的加法运算。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC + 00H$ 或 $[m] \leftarrow ACC + 06H$ 或 $[m] \leftarrow ACC + 60H$ 或 $[m] \leftarrow ACC + 66H$
影响标志位	C
DEC [m]	Decrement Data Memory
指令说明	将指定数据存储器内容减 1。
功能表示	$[m] \leftarrow [m] - 1$
影响标志位	Z
DECA [m]	Decrement Data Memory with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容减 1，把结果存放回累加器并保持指定数据存储器的内容不变。
功能表示	$ACC \leftarrow [m] - 1$
影响标志位	Z

HALT	Enter power down mode
指令说明	此指令终止程序执行并关掉系统时钟，RAM 和寄存器的内容保持原状态，WDT 计数器和分频器被清“0”，暂停标志位 PDF 被置位 1，WDT 溢出标志位 TO 被清 0。
功能表示	$TO \leftarrow 0$ $PDF \leftarrow 1$
影响标志位	TO、PDF
INC [m]	Increment Data Memory
指令说明	将指定数据存储器的内容加 1。
功能表示	$[m] \leftarrow [m] + 1$
影响标志位	Z
INCA [m]	Increment Data Memory with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容加 1，结果存放回累加器并保持指定的数据存储器内容不变。
功能表示	$ACC \leftarrow [m] + 1$
影响标志位	Z
JMP addr	Jump unconditionally
指令说明	程序计数器的内容无条件地由被指定的地址取代，程序由新的地址继续执行。当新的地址被加载时，必须插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。
功能表示	$Program\ Counter \leftarrow addr$
影响标志位	无
MOV A, [m]	Move Data Memory to ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容复制到累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow [m]$
影响标志位	无
MOV A, x	Move immediate data to ACC
指令说明	将 8 位立即数载入累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow x$
影响标志位	无

<p>MOV [m], A 指令说明 功能表示 影响标志位</p>	<p>Move ACC to Data Memory 将累加器的内容复制到指定的数据存储器。 $[m] \leftarrow ACC$ 无</p>
<p>NOP 指令说明 功能表示 影响标志位</p>	<p>No operation 空操作，接下来顺序执行下一条指令。 $PC \leftarrow PC+1$ 无</p>
<p>ORA, [m] 指令说明 功能表示 影响标志位</p>	<p>Logical OR Data Memory to ACC 将累加器中的数据和指定的数据存储器内容逻辑或，结果存放到累加器。 $ACC \leftarrow ACC \text{ "OR" } [m]$ Z</p>
<p>ORA, x 指令说明 功能表示 影响标志位</p>	<p>Logical OR immediate data to ACC 将累加器中的数据和立即数逻辑或，结果存放到累加器。 $ACC \leftarrow ACC \text{ "OR" } x$ Z</p>
<p>ORM A, [m] 指令说明 功能表示 影响标志位</p>	<p>Logical OR ACC to Data Memory 将存在指定数据存储器中的数据和累加器逻辑或，结果放到数据存储器。 $[m] \leftarrow ACC \text{ "OR" } [m]$ Z</p>
<p>RET 指令说明 功能表示 影响标志位</p>	<p>Return from subroutine 将堆栈寄存器中的程序计数器值恢复，程序由取回的地址继续执行。 Program Counter ← Stack 无</p>
<p>RET A, x 指令说明 功能表示 影响标志位</p>	<p>Return from subroutine and load immediate data to ACC 将堆栈寄存器中的程序计数器值恢复且累加器载入指定的立即数，程序由取回的地址继续执行。 Program Counter ← Stack ACC ← x 无</p>

RETI	Return from interrupt
指令说明	将堆栈寄存器中的程序计数器值恢复且中断功能通过设置 EMI 位重新使能。EMI 是控制中断使能的主控制位。如果在执行 RETI 指令之前还有中断未被相应，则这个中断将在返回主程序之前被相应。
功能表示	Program Counter ← Stack
影响标志位	EMI ← 1 无
RL [m]	Rotate Data Memory left
指令说明	将指定数据存储器的内容左移 1 位，且第 7 位移到第 0 位。
功能表示	[m].(i+1) ← [m].i (i=0~6) [m].0 ← [m].7
影响标志位	无
RLA [m]	Rotate Data Memory left with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容左移 1 位，且第 7 位移到第 0 位，结果送到累加器，而指定数据存储器的内容保持不变。
功能表示	ACC.(i+1) ← [m].i (i=0~6) ACC.0 ← [m].7
影响标志位	无
RLC [m]	Rotate Data Memory Left through Carry
指令说明	将指定数据存储器的内容连同进位标志左移 1 位，第 7 位取代进位标志且原本的进位标志移到第 0 位。
功能表示	[m].(i+1) ← [m].i (i=0~6) [m].0 ← C C ← [m].7
影响标志位	C
RLC A [m]	Rotate Data Memory left through Carry with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容连同进位标志左移 1 位，第 7 位取代进位标志且原本的进位标志移到第 0 位，移位结果送回累加器，但是指定数据寄存器的内容保持不变。
功能表示	ACC.(i+1) ← [m].i (i=0~6) ACC.0 ← C C ← [m].7
影响标志位	C

RR [m]	Rotate Data Memory right
指令说明	将指定数据存储器的内容循环右移 1 位且第 0 位移到第 7 位。
功能表示	$[m].i \leftarrow [m].(i+1)$ (i=0~6) $[m].7 \leftarrow [m].0$
影响标志位	无
RRA [m]	Rotate Data Memory right with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容循环右移 1 位，第 0 位移到第 7 位，移位结果存放到累加器，而指定数据存储器的内容保持不变。
功能表示	$ACC.i \leftarrow [m].(i+1)$ (i=0~6) $ACC.7 \leftarrow [m].0$
影响标志位	无
RRC [m]	Rotate Data Memory right through Carry
指令说明	将指定数据存储器的内容连同进位标志右移 1 位，第 0 位取代进位标志且原本的进位标志移到第 7 位。
功能表示	$[m].i \leftarrow [m].(i+1)$ (i=0~6) $[m].7 \leftarrow C$ $C \leftarrow [m].0$
影响标志位	C
RRCA [m]	Rotate Data Memory right through Carry with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容连同进位标志右移 1 位，第 0 位取代进位标志且原本的进位标志移到第 7 位，移位结果送回累加器，但是指定数据寄存器的内容保持不变。
功能表示	$ACC.i \leftarrow [m].(i+1)$ (i=0~6) $ACC.7 \leftarrow C$ $C \leftarrow [m].0$
影响标志位	C
SBC A, [m]	Subtract Data Memory from ACC with Carry
指令说明	将累加器减去指定数据存储器的内容以及进位标志的反，结果存放到累加器。如果结果为负，C 标志位清除为 0，反之结果为正或 0，C 标志位设置为 1。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC - [m] - \bar{C}$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC、CZ

SBC A, x 指令说明	Subtract immediate data from ACC with Carry 将累加器减去立即数以及进位标志，结果存放到累加器。 如果结果为负，C 标志位清除为 0，反之结果为正或 0，C 标志位设置为 1。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC - [m] - \bar{C}$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC、CZ
SBCM A, [m] 指令说明	Subtract Data Memory from ACC with Carry and result in Data Memory 将累加器减去指定数据存储器的内容以及进位标志的反，结果存放到数据存储器。如果结果为负，C 标志位清除为 0，反之结果为正或 0，C 标志位设置为 1。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC - [m] - \bar{C}$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC、CZ
SDZ [m] 指令说明	Skip if Decrement Data Memory is 0 将指定的数据存储器的内容减 1，判断是否为 0，若为 0 则跳过下一条指令，由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。
功能表示	$[m] \leftarrow [m] - 1$ ，如果 $[m]=0$ 跳过下一条指令执行
影响标志位	无
SDZA [m] 指令说明	Decrement data memory and place result in ACC, skip if 0 将指定数据存储器内容减 1，判断是否为 0，如果为 0 则跳过下一条指令，此结果将存放到累加器，但指定数据存储器内容不变。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。
功能表示	$ACC \leftarrow [m] - 1$ ，如果 $ACC=0$ 跳过下一条指令执行
影响标志位	无
SET [m] 指令说明	Set Data Memory 将指定数据存储器的每一位设置为 1。
功能表示	$[m] \leftarrow FFH$
影响标志位	无

<p>SET [m].i</p> <p>指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Set bit of Data Memory</p> <p>将指定数据存储器的第 i 位置位为 1。</p> <p>$[m].i \leftarrow 1$</p> <p>无</p>
<p>SIZ [m]</p> <p>指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Skip if increment Data Memory is 0</p> <p>将指定的数据存储器的内容加 1，判断是否为 0，若为 0 则跳过下一条指令。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。</p> <p>$[m] \leftarrow [m]+1$，如果 $[m]=0$ 跳过下一条指令执行</p> <p>无</p>
<p>SIZA [m]</p> <p>指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Skip if increment Data Memory is zero with result in ACC</p> <p>将指定数据存储器的内容加 1，判断是否为 0，如果为 0 则跳过下一条指令，此结果会被存放到累加器，但是指定数据存储器的内容不变。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。</p> <p>$ACC \leftarrow [m]+1$，如果 $ACC=0$ 跳过下一条指令执行</p> <p>无</p>
<p>SNZ [m].i</p> <p>指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Skip if bit i of Data Memory is not 0</p> <p>判断指定数据存储器的第 i 位，若不为 0，则程序跳过下一条指令执行。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果为 0，则程序继续执行下一条指令。</p> <p>如果 $[m].i \neq 0$，跳过下一条指令执行</p> <p>无</p>
<p>SNZ [m]</p> <p>指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Skip if Data Memory is not 0</p> <p>判断指定存储器，若不为 0，则程序跳过下一条指令执行。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果为 0，则程序继续执行下一条指令。</p> <p>如果 $[m] \neq 0$，跳过下一条指令执行</p> <p>无</p>

SUB A, [m] 指令说明	Subtract Data Memory from ACC 将累加器的内容减去指定的数据存储器的数据，把结果存放到累加器。如果结果为负，C 标志位清除为 0，反之结果为正或 0，C 标志位设置为 1。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC - [m]$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC、CZ
SUBM A, [m] 指令说明	Subtract Data Memory from ACC with result in Data Memory 将累加器的内容减去指定数据存储器的数据，结果存放到指定的数据存储器。如果结果为负，C 标志位清除为 0，反之结果为正或 0，C 标志位设置为 1。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC - [m]$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC、CZ
SUB A, x 指令说明	Subtract immediate Data from ACC 将累加器的内容减去立即数，结果存放到累加器。如果结果为负，C 标志位清除为 0，反之结果为正或 0，C 标志位设置为 1。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC - x$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC、CZ
SWAP [m] 指令说明	Swap nibbles of Data Memory 将指定数据存储器的低 4 位和高 4 位互相交换。
功能表示	$[m].3 \sim [m].0 \leftrightarrow [m].7 \sim [m].4$
影响标志位	无
SWAPA [m] 指令说明	Swap nibbles of Data Memory with result in ACC 将指定数据存储器的低 4 位与高 4 位互相交换，再将结果存放到累加器且指定数据寄存器的数据保持不变。
功能表示	$ACC.3 \sim ACC.0 \leftarrow [m].7 \sim [m].4$ $ACC.7 \sim ACC.4 \leftarrow [m].3 \sim [m].0$
影响标志位	无
SZ [m] 指令说明	Skip if Data Memory is 0 判断指定数据存储器的内容是否为 0，若为 0，则程序跳过下一条指令执行。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。
功能表示	如果 $[m]=0$ ，跳过下一条指令执行
影响标志位	无

<p>SZA [m] 指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Skip if Data Memory is 0 with data movement to ACC 将指定数据存储器内容复制到累加器，并判断指定数据存储器的内容是否为 0，若为 0 则跳过下一条指令。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。</p> <p>ACC ←[m]，如果 [m]=0，跳过下一条指令执行</p> <p>无</p>
<p>SZ [m].i 指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Skip if bit i of Data Memory is 0 判断指定数据存储器的第 i 位是否为 0，若为 0，则跳过下一条指令。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。</p> <p>如果 [m].i=0，跳过下一条指令执行</p> <p>无</p>
<p>TABRD [m] 指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Read table (specific page) to TBLH and Data Memory 将表格指针对 TBHP 和 TBLP 所指的程序代码低字节 (指定页) 移至指定数据存储器且将高字节移至 TBLH。</p> <p>[m] ← 程序代码 (低字节) TBLH ← 程序代码 (高字节)</p> <p>无</p>
<p>TABRDL [m] 指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Read table (last page) to TBLH and Data Memory 将表格指针 TBLP 所指的程序代码低字节 (最后一页) 移至指定数据存储器且将高字节移至 TBLH。</p> <p>[m] ← 程序代码 (低字节) TBLH ← 程序代码 (高字节)</p> <p>无</p>
<p>ITABRD [m] 指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Increment table pointer low byte first and read table to TBLH and data memory 将自加表格指针 TBLP 所指的程序代码低字节 (当前页) 移至指定的数据存储器且将高字节移至 TBLH。</p> <p>[m] ← 程序代码 (低字节) TBLH ← 程序代码 (高字节)</p> <p>无</p>

ITABRDL [m]	Increment table pointer low byte first and read table(last page) to TBLH and data memory
指令说明	将自加表格指针 TBLP 所指的程序代码低字节（最后一页）移至指定的数据存储器且将高字节移至 TBLH。
功能表示	[m] ← 程序代码 (低字节) TBLH ← 程序代码 (高字节)
影响标志位	无
XOR A, [m]	Logical XOR Data Memory to ACC
指令说明	将累加器的数据和指定的数据存储器内容逻辑异或，结果存放到累加器。
功能表示	ACC ← ACC “XOR” [m]
影响标志位	Z
XORM A, [m]	Logical XOR ACC to Data Memory
指令说明	将累加器的数据和指定的数据存储器内容逻辑异或，结果放到数据存储器。
功能表示	[m] ← ACC “XOR” [m]
影响标志位	Z
XOR A, x	Logical XOR immediate data to ACC
指令说明	将累加器的数据与立即数逻辑异或，结果存放到累加器。
功能表示	ACC ← ACC “XOR” x
影响标志位	Z

扩展指令定义

扩展指令被用来直接存取存储在任何数据存储器 Sector 中的数据。

LADC A, [m]	Add Data Memory to ACC with Carry
指令说明	将指定的数据存储器、累加器内容以及进位标志相加，结果存放到累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC + [m] + C$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC
LADCM A, [m]	Add ACC to Data Memory with Carry
指令说明	将指定的数据存储器、累加器内容和进位标志位相加，结果存放到指定的数据存储器。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC + [m] + C$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC
LADD A, [m]	Add Data Memory to ACC
指令说明	将指定的数据存储器和累加器内容相加，结果存放到累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC + [m]$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC
LADDM A, [m]	Add ACC to Data Memory
指令说明	将指定的数据存储器和累加器内容相加，结果存放到指定的数据存储器。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC + [m]$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC
LAND A, [m]	Logical AND Data Memory to ACC
指令说明	将累加器中的数据和指定数据存储器内容做逻辑与，结果存放到累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC \text{ "AND" } [m]$
影响标志位	Z
LANDM A, [m]	Logical AND ACC to Data Memory
指令说明	将指定数据存储器内容和累加器中的数据做逻辑与，结果存放到数据存储器。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC \text{ "AND" } [m]$
影响标志位	Z

LCLR [m]	Clear Data Memory
指令说明	将指定数据存储器的内容清零。
功能表示	$[m] \leftarrow 00H$
影响标志位	无
LCLR [m].i	Clear bit of Data Memory
指令说明	将指定数据存储器的 i 位内容清零。
功能表示	$[m].i \leftarrow 0$
影响标志位	无
LCPL [m]	Complement Data Memory
指令说明	将指定数据存储器中的每一位取逻辑反， 相当于从 1 变 0 或 0 变 1。
功能表示	$[m] \leftarrow \overline{[m]}$
影响标志位	Z
LCPLA [m]	Complement Data Memory with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器中的每一位取逻辑反，相当于从 1 变 0 或 0 变 1，结果被存放回累加器且数据寄存器的内容保持 不变。
功能表示	$ACC \leftarrow \overline{[m]}$
影响标志位	Z
LDAA [m]	Decimal-Adjust ACC for addition with result in Data Memory
指令说明	将累加器中的内容转换为 BCD（二进制转成十进制）码。 如果低四位的值大于“9”或 AC=1，那么 BCD 调整就执行 对低四位加“6”，否则低四位保持不变；如果高四位的 值大于“9”或 C=1，那么 BCD 调整就执行对高四位加“6”。 BCD 转换实质上是根据累加器和标志位执行 00H，06H， 60H 或 66H 的加法运算，结果存放到数据存储器。只有进 位标志位 C 受影响，用来指示原始 BCD 的和是否大于 100，并可以进行双精度十进制数的加法运算。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC + 00H$ 或 $[m] \leftarrow ACC + 06H$ 或 $[m] \leftarrow ACC + 60H$ 或 $[m] \leftarrow ACC + 66H$
影响标志位	C

LDEC [m]	Decrement Data Memory
指令说明	将指定数据存储器的内容减 1。
功能表示	$[m] \leftarrow [m] - 1$
影响标志位	Z
LDECA [m]	Decrement Data Memory with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容减 1，把结果存放回累加器并保持指定数据存储器的内容不变。
功能表示	$ACC \leftarrow [m] - 1$
影响标志位	Z
LINC [m]	Increment Data Memory
指令说明	将指定数据存储器的内容加 1。
功能表示	$[m] \leftarrow [m] + 1$
影响标志位	Z
LINCA [m]	Increment Data Memory with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容加 1，结果存放回累加器并保持指定的数据存储器内容不变。
功能表示	$ACC \leftarrow [m] + 1$
影响标志位	Z
LMOV A, [m]	Move Data Memory to ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容复制到累加器中。
功能表示	$ACC \leftarrow [m]$
影响标志位	无
LMOV [m], A	Move ACC to Data Memory
指令说明	将累加器的内容复制到指定数据存储器。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC$
影响标志位	无
LOR A, [m]	Logical OR Data Memory to ACC
指令说明	将累加器中的数据和指定的数据存储器内容逻辑或，结果存放到累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC \text{ "OR" } [m]$
影响标志位	Z

LORM A, [m]	Logical OR ACC to Data Memory
指令说明	将存在指定数据存储器中的数据 and 累加器逻辑或，结果放到数据存储器。
功能表示	$[m] \leftarrow \text{ACC} \text{ "OR" } [m]$
影响标志位	Z
LRL [m]	Rotate Data Memory left
指令说明	将指定数据存储器的内容左移 1 位，且第 7 位移到第 0 位。
功能表示	$[m].(i+1) \leftarrow [m].i \ (i=0\sim6)$ $[m].0 \leftarrow [m].7$
影响标志位	无
LRLA [m]	Rotate Data Memory left with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容左移 1 位，且第 7 位移到第 0 位，结果送到累加器，而指定数据存储器的内容保持不变。
功能表示	$\text{ACC}.(i+1) \leftarrow [m].i \ (i=0\sim6)$ $\text{ACC}.0 \leftarrow [m].7$
影响标志位	无
LRLC [m]	Rotate Data Memory Left through Carry
指令说明	将指定数据存储器的内容连同进位标志左移 1 位，第 7 位取代进位标志且原本的进位标志移到第 0 位。
功能表示	$[m].(i+1) \leftarrow [m].i \ (i=0\sim6)$ $[m].0 \leftarrow C$ $C \leftarrow [m].7$
影响标志位	C
LRLC A [m]	Rotate Data Memory left through Carry with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容连同进位标志左移 1 位，第 7 位取代进位标志且原本的进位标志移到第 0 位，移位结果送回累加器，但是指定数据寄存器的内容保持不变。
功能表示	$\text{ACC}.(i+1) \leftarrow [m].i \ (i=0\sim6)$ $\text{ACC}.0 \leftarrow C$ $C \leftarrow [m].7$
影响标志位	C

LRR [m]	Rotate Data Memory right
指令说明	将指定数据存储器的内容循环右移 1 位且第 0 位移到第 7 位。
功能表示	$[m].i \leftarrow [m].(i+1)$ (i=0~6) $[m].7 \leftarrow [m].0$
影响标志位	无
LRRA [m]	Rotate Data Memory right with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容循环右移 1 位，第 0 位移到第 7 位，移位结果存放到累加器，而指定数据存储器的内容保持不变。
功能表示	$ACC.i \leftarrow [m].(i+1)$ (i=0~6) $ACC.7 \leftarrow [m].0$
影响标志位	无
LRRC [m]	Rotate Data Memory right through Carry
指令说明	将指定数据存储器的内容连同进位标志右移 1 位，第 0 位取代进位标志且原本的进位标志移到第 7 位。
功能表示	$[m].i \leftarrow [m].(i+1)$ (i=0~6) $[m].7 \leftarrow C$ $C \leftarrow [m].0$
影响标志位	C
LRRC A [m]	Rotate Data Memory right through Carry with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容连同进位标志右移 1 位，第 0 位取代进位标志且原本的进位标志移到第 7 位，移位结果送回累加器，但是指定数据寄存器的内容保持不变。
功能表示	$ACC.i \leftarrow [m].(i+1)$ (i=0~6) $ACC.7 \leftarrow C$ $C \leftarrow [m].0$
影响标志位	C
LSBC A, [m]	Subtract Data Memory from ACC with Carry
指令说明	将累加器减去指定数据存储器的内容以及进位标志的反，结果存放到累加器。如果结果为负，C 标志位清除为 0，反之结果为正或 0，C 标志位设置为 1。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC - [m] - \bar{C}$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC、CZ

LSBCMA, [m]	Subtract Data Memory from ACC with Carry and result in Data Memory
指令说明	将累加器减去指定数据存储器的内容以及进位标志的反，结果存放到数据存储器。如果结果为负，C标志位清除为0，反之结果为正或0，C标志位设置为1。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC - [m] - \bar{C}$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC、CZ
LSDZ [m]	Skip if Decrement Data Memory is 0
指令说明	将指定的数据存储器的内容减1，判断是否为0，若为0则跳过下一条指令，由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为2个周期的指令。如果结果不为0，则程序继续执行下一条指令。
功能表示	$[m] \leftarrow [m] - 1$ ，如果 $[m]=0$ 跳过下一条指令执行
影响标志位	无
LSDZA [m]	Skip if decrement Data Memory is zero with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器内容减1，判断是否为0，如果为0则跳过下一条指令，此结果将存放到累加器，但指定数据存储器内容不变。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为2个周期的指令。如果结果不为0，则程序继续执行下一条指令。
功能表示	$ACC \leftarrow [m] - 1$ ，如果 $ACC=0$ 跳过下一条指令执行
影响标志位	无
LSET [m]	Set Data Memory
指令说明	将指定数据存储器的每一个位置位为1。
功能表示	$[m] \leftarrow FFH$
影响标志位	无
LSET [m].i	Set bit of Data Memory
指令说明	将指定数据存储器的第i位置位为1。
功能表示	$[m].i \leftarrow 1$
影响标志位	无

<p>LSIZ [m] 指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Skip if increment Data Memory is 0</p> <p>将指定的数据存储器的内容加 1，判断是否为 0，若为 0 则跳过下一条指令。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。</p> <p>$[m] \leftarrow [m]+1$，如果 $[m]=0$ 跳过下一条指令执行</p> <p>无</p>
<p>LSIZA [m] 指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Skip if increment Data Memory is zero with result in ACC</p> <p>将指定数据存储器的内容加 1，判断是否为 0，如果为 0 则跳过下一条指令，此结果会被存放到累加器，但是指定数据存储器的内容不变。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。</p> <p>$ACC \leftarrow [m]+1$，如果 $ACC=0$ 跳过下一条指令执行</p> <p>无</p>
<p>LSNZ [m].i 指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Skip if bit i of Data Memory is not 0</p> <p>判断指定数据存储器的第 i 位，若不为 0，则程序跳过下一条指令执行。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果为 0，则程序继续执行下一条指令。</p> <p>如果 $[m].i \neq 0$，跳过下一条指令执行</p> <p>无</p>
<p>LSNZ [m] 指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Skip if Data Memory is not 0</p> <p>判断指定数据存储器，若不为 0，则程序跳过下一条指令执行。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果为 0，则程序继续执行下一条指令。</p> <p>如果 $[m] \neq 0$，跳过下一条指令执行</p> <p>无</p>
<p>LSUB A, [m] 指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Subtract Data Memory from ACC</p> <p>将累加器的内容减去指定的数据存储器的数据，把结果存放到累加器。如果结果为负，C 标志位清除为 0，反之结果为正或 0，C 标志位设置为 1。</p> <p>$ACC \leftarrow ACC - [m]$</p> <p>OV、Z、AC、C、SC、CZ</p>

LSUBM A, [m] 指令说明	Subtract Data Memory from ACC with result in Data Memory 将累加器的内容减去指定数据存储器中的数据，结果存放到指定的数据存储器。如果结果为负，C 标志位清除为 0，反之结果为正或 0，C 标志位设置为 1。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC - [m]$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC、CZ
LSWAP [m] 指令说明	Swap nibbles of Data Memory 将指定数据存储器的低 4 位和高 4 位互相交换。
功能表示	$[m].3 \sim [m].0 \leftrightarrow [m].7 \sim [m].4$
影响标志位	无
LSWAPA [m] 指令说明	Swap nibbles of Data Memory with result in ACC 将指定数据存储器的低 4 位和高 4 位互相交换，再将结果存放到累加器且指定数据寄存器的数据保持不变。
功能表示	$ACC.3 \sim ACC.0 \leftarrow [m].7 \sim [m].4$ $ACC.7 \sim ACC.4 \leftarrow [m].3 \sim [m].0$
影响标志位	无
LSZ [m] 指令说明	Skip if Data Memory is 0 判断指定数据存储器内容是否为 0，若为 0，则程序跳过下一条指令执行。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。
功能表示	如果 $[m]=0$ ，跳过下一条指令执行
影响标志位	无
LSZA [m] 指令说明	Skip if Data Memory is 0 with data movement to ACC 将指定数据存储器内容复制到累加器，并判断指定数据存储器内容是否为 0，若为 0 则跳过下一条指令。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。
功能表示	$ACC \leftarrow [m]$ ，如果 $[m]=0$ ，跳过下一条指令执行
影响标志位	无

<p>LSZ [m].i 指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Skip if bit i of Data Memory is 0 判断指定数据存储器的第 i 位是否为 0，若为 0，则跳过下一条指令。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。</p> <p>如果 [m].i=0，跳过下一条指令执行</p> <p>无</p>
<p>LTABRD [m] 指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Move the ROM code to TBLH and data memory 将表格指针 TBLP 所指的程序代码低字节（当前页）移至指定数据存储器且将高字节移至 TBLH。</p> <p>[m] ← 程序代码（低字节） TBLH ← 程序代码（高字节）</p> <p>无</p>
<p>LTABRDL [m] 指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Read table (last page) to TBLH and Data Memory 将表格指针 TBLP 所指的程序代码低字节（最后一页）移至指定数据存储器且将高字节移至 TBLH。</p> <p>[m] ← 程序代码（低字节） TBLH ← 程序代码（高字节）</p> <p>无</p>
<p>LITABRD [m] 指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Increment table pointer low byte first and read table to TBLH and data memory 将自加表格指针 TBHP 和 TBLP 所指的程序代码低字节移至指定的数据存储器且将高字节移至 TBLH。</p> <p>[m] ← 程序代码（低字节） TBLH ← 程序代码（高字节）</p> <p>无</p>
<p>LITABRDL [m] 指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Increment table pointer low byte first and read table(last page) to TBLH and data memory 将自加表格指针 TBLP 所指的程序代码低字节（最后一页）移至指定的数据存储器且将高字节移至 TBLH。</p> <p>[m] ← 程序代码（低字节） TBLH ← 程序代码（高字节）</p> <p>无</p>

LXOR A, [m]	Logical XOR Data Memory to ACC
指令说明	将累加器的数据和指定的数据存储器内容逻辑异或，结果存放到累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC \text{ "XOR" } [m]$
影响标志位	Z
LXORM A, [m]	Logical XOR ACC to Data Memory
指令说明	将累加器的数据和指定的数据存储器内容逻辑异或，结果放到数据存储器。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC \text{ "XOR" } [m]$
影响标志位	Z

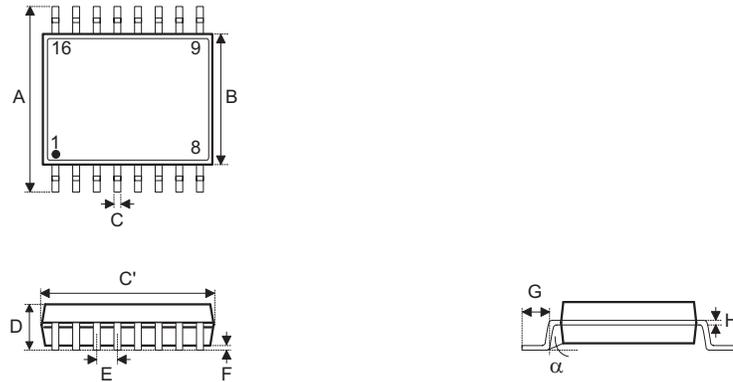
封装信息

请注意，这里提供的封装信息仅作为参考。由于这个信息经常更新，提醒用户咨询 [Holtek 网站](#) 以获取最新版本的[封装信息](#)。

封装信息的相关内容如下所示，点击可链接至 Holtek 网站相关信息页面。

- 封装信息 (包括外形尺寸、包装带和卷轴规格)
- 封装材料信息
- 纸箱信息

16-pin SSOP (150mil) 外形尺寸



符号	尺寸 (单位: inch)		
	最小值	典型值	最大值
A	—	0.236 BSC	—
B	—	0.154 BSC	—
C	0.008	—	0.012
C'	—	0.193 BSC	—
D	—	—	0.069
E	—	0.025 BSC	—
F	0.004	—	0.010
G	0.016	—	0.050
H	0.004	—	0.010
α	0°	—	8°

符号	尺寸 (单位: mm)		
	最小值	典型值	最大值
A	—	6.0 BSC	—
B	—	3.9 BSC	—
C	0.20	—	0.30
C'	—	4.9 BSC	—
D	—	—	1.75
E	—	0.635 BSC	—
F	0.10	—	0.25
G	0.41	—	1.27
H	0.10	—	0.25
α	0°	—	8°

Copyright® 2020 by HOLTEK SEMICONDUCTOR INC.

使用指南中所出现的信息在出版当时相信是正确的，然而 **Holtek** 对于说明书的使用不负任何责任。文中提到的应用目的仅仅是用来做说明，**Holtek** 不保证或表示这些没有进一步修改的应用将是适当的，也不推荐它的产品使用在会由于故障或其它原因可能会对人身造成危害的地方。**Holtek** 产品不授权用于救生、维生从机或系统中做为关键从机。**Holtek** 拥有不事先通知而修改产品的权利，对于最新的信息，请参考我们的网址 <http://www.holtek.com/zh/>。